富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
S9012	PNP	2T1	300	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	70-400	-1	-50	150	SOT-23	通用
S9013	NPN	J3	300	500	40	25	0.6	500	50	70-400	1	50	150	SOT-23	通用
S9014	NPN	J6	225	100	50	45	0.3	100	5	200-1000	5	1	150	SOT-23	通用
S9015	PNP	M6	225	-100	-50	-45	-0.3	-100	-5	200-1000	-5	-1	150	SOT-23	通用
S1015	PNP	BA	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	120-400	-6	-2	80	SOT-23	通用
S1815	NPN	HF	225	150	60	50	0.25	100	10	120-400	6	2	80	SOT-23	通用
C945	NPN	CR	225	150	60	50	0.3	100	10	120-400	6	2	250	SOT-23	通用
A733	PNP	CS	225	-150	-60	-50	-0.3	-100	-10	120-475	-6	-2	250	SOT-23	通用
2SA812M4	PNP	M4	225	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	90-180	-6	-1	180	SOT-23	通用
2SA812M5	PNP	M5	225	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	135-270	-6	-1	180	SOT-23	通用
2SA812M6	PNP	M6	225	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	200-400	-6	-1	180	SOT-23	通用
2SA812M7	PNP	M7	225	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	300-600	-6	-1	180	SOT-23	通用
2SC1623L4	NPN	L4	225	100	60	50	0.3	100	10	90-180	6	1	250	SOT-23	通用
2SC1623L5	NPN	L5	225	100	60	50	0.3	100	10	135-270	6	1	250	SOT-23	通用
2SC1623L6	NPN	L6	225	100	60	50	0.3	100	10	200-400	6	1	250	SOT-23	通用
2SC1623L7	NPN	L7	225	100	60	50	0.3	100	10	300-600	6	1	250	SOT-23	通用
2SC2712(O)	NPN	LO	225	150	60	50	0.25	100	10	70-140	6	2	80	SOT-23	通用
2SC2712(Y)	NPN	LY	225	150	60	50	0.25	100	10	120-240	6	2	80	SOT-23	通用
2SC2712(G)	NPN	LG	225	150	60	50	0.25	100	10	200-400	6	2	80	SOT-23	通用
2SC2712(L)	NPN	LL	225	150	60	50	0.25	100	10	350-700	6	2	80	SOT-23	通用
2SA1162(O)	PNP	SO	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	70-140	-6	-2	80	SOT-23	通用
2SA1162(Y)	PNP	SY	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	120-240	-6	-2	80	SOT-23	通用
2SA1162(G)	PNP	SG	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	0	200-400	-6	-2	80	SOT-23	通用
C3875S(O)	NPN	ALO	225	150	60	50	0.25	100	10	70-140	6	2	80	SOT-23	通用
C3875S(Y)	NPN	ALY	225	150	60	50	0.25	100	10	120-240	6	2	80	SOT-23	通用
C3875S(G)	NPN	ALG	225	150	60	50	0.25	100	10	200-400	6	2	80	SOT-23	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
C3875S(L)	NPN	ALL	225	150	60	50	0.25	100	10	350-700	6	2	80	SOT-23	通用
A1504(O)	PNP	ASO	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	70-140	-6	-2	80	SOT-23	通用
A1504(Y)	PNP	ASY	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	120-240	-6	-2	80	SOT-23	通用
A1504(G)	PNP	ASG	225	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	200-400	-6	-2	80	SOT-23	通用
2SC2412(Q)	NPN	BQ	225	150	60	50	0.4	50	5	120-270	6	1	180	SOT-23	通用
2SC2412(R)	NPN	BR	225	150	60	50	0.4	50	5	180-390	6	1	180	SOT-23	通用
2SC2412(S)	NPN	BS	225	150	60	50	0.4	50	5	270-560	6	1	180	SOT-23	通用
2SA1037(Q)	PNP	FQ	225	-150	-60	-50	-0.5	-50	-5	120-270	-6	-1	140	SOT-23	通用
2SA1037(R)	PNP	FR	225	-150	-60	-50	-0.5	-50	-5	180-390	-6	-1	140	SOT-23	通用
2SA1037(S)	PNP	FS	225	-150	-60	-50	-0.5	-50	-5	270-560	-6	-1	140	SOT-23	通用
BC846A	NPN	1A	225	100	80	65	0.6	100	5	110-220	5	2	100	SOT-23	通用
BC846B	NPN	1B	225	100	80	65	0.6	100	5	200-450	5	2	100	SOT-23	通用
BC847A	NPN	1E	225	100	50	45	0.6	100	5	110-220	5	2	100	SOT-23	通用
BC847B	NPN	1F	225	100	50	45	0.6	100	5	200-450	5	2	100	SOT-23	通用
BC847C	NPN	1G	225	100	50	45	0.6	100	5	420-800	5	2	100	SOT-23	通用
BC848A	NPN	1J	225	100	30	30	0.6	100	5	110-220	5	2	100	SOT-23	通用
BC848B	NPN	1K	225	100	30	30	0.6	100	5	200-450	5	2	100	SOT-23	通用
BC848C	NPN	1L	225	100	30	30	0.6	100	5	420-800	5	2	100	SOT-23	通用
BC856A	PNP	3A	225	-100	-80	-65	-0.65	-100	-5	125-250	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC856B	PNP	3B	225	-100	-80	-65	-0.65	-100	-5	220-475	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC857A	PNP	3E	225	-100	-50	-45	-0.65	-100	-5	125-250	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC857B	PNP	3F	225	-100	-50	-45	-0.65	-100	-5	220-475	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC857C	PNP	3G	225	-100	-50	-45	-0.65	-100	-5	420-800	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC858A	PNP	3J	225	-100	-30	-30	-0.65	-100	-5	125-250	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC858B	PNP	3K	225	-100	-30	-30	-0.65	-100	-5	220-475	-5	-2	100	SOT-23	通用
BC858C	PNP	3L	225	-100	-30	-30	-0.65	-100	-5	420-800	-5	-2	100	SOT-23	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
BC807-16	PNP	5A	225	-500	-50	-45	-0.7	-500	-50	100-250	-1	-100	100	SOT-23	通用
BC807-25	PNP	5B	225	-500	-50	-45	-0.7	-500	-50	160-400	-1	-100	100	SOT-23	通用
BC807-40	PNP	5C	225	-500	-50	-45	-0.7	-500	-50	250-600	-1	-100	100	SOT-23	通用
BC817-16	NPN	6A	225	500	50	45	0.7	500	50	100-250	1	100	100	SOT-23	通用
BC817-25	NPN	6B	225	500	50	45	0.7	500	50	160-400	1	100	100	SOT-23	通用
BC817-40	NPN	6C	225	500	50	45	0.7	500	50	250-600	1	100	100	SOT-23	通用
2SA1036(P)	PNP	HP	200	-500	-40	-32	-0.4	-500	-50	82-180	-3	-100	200	SOT-23	通用
2SA1036(Q)	PNP	HQ	200	-500	-40	-32	-0.4	-500	-50	120-270	-3	-100	200	SOT-23	通用
2SA1036(R)	PNP	HR	200	-500	-40	-32	-0.4	-500	-50	180-390	-3	-100	200	SOT-23	通用
2SC2411(P)	NPN	CP	200	500	40	32	0.4	500	50	82-180	3	100	250	SOT-23	通用
2SC2411(Q)	NPN	CQ	200	500	40	32	0.4	500	50	120-270	3	100	250	SOT-23	通用
2SC2411(R)	NPN	CR	200	500	40	32	0.4	500	50	180-390	3	100	250	SOT-23	通用
A1505(O)	PNP	AZO	150	-500	-35	-30	-0.25	-100	-10	70-140	-1	-100	200	SOT-23	通用
A1505(Y)	PNP	AZY	150	-500	-35	-30	-0.25	-100	-10	120-240	-1	-100	200	SOT-23	通用
A1505(G)	PNP	AZG	150	-500	-35	-30	-0.25	-100	-10	200-400	-1	-100	200	SOT-23	通用
C3876(O)	NPN	WO	200	500	35	30	0.25	100	10	70-140	1	100	300	SOT-23	通用
C3876(Y)	NPN	WY	200	500	35	30	0.25	100	10	120-240	1	100	300	SOT-23	通用
C3876(G)	NPN	WG	200	500	35	30	0.25	100	10	200-400	1	100	300	SOT-23	通用
2SD780-1	NPN	DW1	200	300	60	60	0.6	300	30	110-180	1	50	140	SOT-23	通用
2SD780-2	NPN	DW2	200	300	60	60	0.6	300	30	135-220	1	50	140	SOT-23	通用
2SD780-3	NPN	DW3	200	300	60	60	0.6	300	30	170-270	1	50	140	SOT-23	通用
2SD780-4	NPN	DW4	200	300	60	60	0.6	300	30	200-320	1	50	140	SOT-23	通用
2SD780-5	NPN	DW5	200	300	60	60	0.6	300	30	250-400	1	50	140	SOT-23	通用
2SB736-1	PNP	BW1	200	-300	-60	-60	-0.6	-300	-30	110-180	-1	-50	100	SOT-23	通用
2SB736-2	PNP	BW2	200	-300	-60	-60	-0.6	-300	-30	135-220	-1	-50	100	SOT-23	通用
2SB736-3	PNP	BW3	200	-300	-60	-60	-0.6	-300	-30	170-270	-1	-50	100	SOT-23	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SB736-4	PNP	BW4	200	-300	-60	-60	-0.6	-300	-30	200-320	-1	-50	100	SOT-23	通用
2SB736-5	PNP	BW5	200	-300	-60	-60	-0.6	-300	-30	250-400	-1	-50	100	SOT-23	通用
MMBT5401S	PNP	2L.	300	-600	-160	-150	-0.5	-50	-5	100-300	-5	-10	100	SOT-23	高压
MMBT5551S	NPN	G1.	300	600	180	160	0.5	50	5	100-300	5	10	100	SOT-23	高压
MMBT5401	PNP	2L	225	-500	-160	-150	-0.5	-50	-5	100-300	-5	-10	100	SOT-23	高压
MMBT5551	NPN	G1	225	600	180	160	0.2	50	5	100-300	5	10	100	SOT-23	高压
MMBTA42	NPN	1D	350	300	300	300	0.2	20	2	100-200	10	10	50	SOT-23	高压
MMBTA43	NPN	M1E	350	300	200	200	0.2	20	2	100-200	10	10	50	SOT-23	高压
MMBTA44	NPN	3D	350	200	400	400	0.5	10	1	50-200	10	10	50	SOT-23	高压
MMBTA45	NPN	3D	300	200	400	350	0.3	50	5	80-300	10	10	50	SOT-23	高压
MMBTA92	PNP	2D	300	-200	-300	-300	-0.2	-20	-2	100-200	-10	-10	50	SOT-23	高压
MMBTA93	PNP	2E	300	-200	-200	-200	-0.2	-20	-2	100-200	-10	-10	50	SOT-23	高压
MMBTA94	PNP	4D	350	-200	-400	-400	-0.2	-10	-1	80-300	-10	-10	50	SOT-23	高压
FMMT458	NPN	458	350	225	400	400	0.5	50	6	100-300	10	50	50	SOT-23	高压
FMMT558	PNP	558	350	-150	-400	-400	-0.5	-50	-6	100-300	-10	-50	50	SOT-23	高压
FMMT560	PNP	HF	500	-150	-500	-500	-0.5	-50	-10	80-300	-10	-50	60	SOT-23	高压
BCX19	NPN	U1	225	500	50	45	0.62	500	50	100-600	1	100	100	SOT-23	通用
MMBTA05	NPN	1H	300	500	60	60	0.25	100	10	>100	1	100	100	SOT-23	通用
MMBTA55	PNP	2H	300	-500	-60	-60	-0.25	-100	-10	>100	-1	-100	50	SOT-23	通用
MMBTA06	NPN	1GM	300	500	80	80	0.25	100	10	>100	1	100	100	SOT-23	通用
MMBTA56	PNP	2GM	300	-500	-80	-80	-0.25	-100	-10	>100	-1	-100	50	SOT-23	通用
2SB1198(Q)	PNP	AKQ	150	-500	-80	-80	-0.5	-500	-50	120-270	-3	-100	120	SOT-23	通用
2SB1198(R)	PNP	AKR	150	-500	-80	-80	-0.5	-500	-50	180-390	-3	-100	120	SOT-23	通用
2SD1782(Q)	NPN	AJQ	200	500	80	80	0.5	500	50	120-270	3	100	120	SOT-23	通用
2SD1782(R)	NPN	AJR	200	500	80	80	0.5	500	50	180-390	3	100	120	SOT-23	通用
S8050	NPN	J3Y	300	500	40	25	0.6	500	50	85-400	1	100	100	SOT-23	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
S8550	PNP	2TY	300	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	85-400	-1	-100	100	SOT-23	通用
M8050	NPN	Y11	300	1000	40	25	0.6	500	50	85-400	1	100	100	SOT-23	通用
M8550	PNP	Y21	300	-1000	-40	-25	-0.6	-500	-50	85-400	-1	-100	100	SOT-23	通用
MMT8050	NPN	Y.1	300	1200	40	25	0.6	800	80	85-400	1	100	100	SOT-23	通用
MMT8550	PNP	Y.2	300	-1200	-40	-25	-0.6	-800	-80	85-400	-1	-100	100	SOT-23	通用
SS8050	NPN	Y1	300	1500	40	25	0.5	800	80	85-400	1	100	100	SOT-23	通用
SS8550	PNP	Y2	300	-1500	-40	-25	-0.5	-800	-80	85-400	-1	-100	100	SOT-23	通用
SS8050A	NPN	Y1	300	1500	40	25	0.6	1000	100	85-400	1	100	100	SOT-23	通用
SS8550A	PNP	Y2	300	-1500	-40	-25	-0.6	-1000	-100	85-400	-1	-100	100	SOT-23	通用
2SD596-1	NPN	DV1	225	700	30	25	0.6	700	70	110-180	1	100	170	SOT-23	通用
2SD596-2	NPN	DV2	225	700	30	25	0.6	700	70	135-220	1	100	170	SOT-23	通用
2SD596-3	NPN	DV3	225	700	30	25	0.6	700	70	170-270	1	100	170	SOT-23	通用
2SD596-4	NPN	DV4	225	700	30	25	0.6	700	70	200-320	1	100	170	SOT-23	通用
2SD596-5	NPN	DV5	225	700	30	25	0.6	700	70	250-400	1	100	170	SOT-23	通用
2SB624-1	PNP	BV1	225	-700	-30	-25	-0.6	-700	-70	110-180	-1	-100	160	SOT-23	通用
2SB624-2	PNP	BV2	225	-700	-30	-25	-0.6	-700	-70	135-220	-1	-100	160	SOT-23	通用
2SB624-3	PNP	BV3	225	-700	-30	-25	-0.6	-700	-70	170-270	-1	-100	160	SOT-23	通用
2SB624-4	PNP	BV4	225	-700	-30	-25	-0.6	-700	-70	200-320	-1	-100	160	SOT-23	通用
2SB624-5	PNP	BV5	225	-700	-30	-25	-0.6	-700	-70	250-400	-1	-100	160	SOT-23	通用
C3265(O)	NPN	EO	200	800	35	30	0.5	500	20	100-200	1	100	120	SOT-23	通用
C3265(Y)	NPN	EY	200	800	35	30	0.5	500	20	160-320	1	100	120	SOT-23	通用
A1298(O)	PNP	IO	200	-800	-35	-30	-0.4	-500	-20	100-200	-1	-100	120	SOT-23	通用
A1298(Y)	PNP	IY	200	-800	-35	-30	-0.4	-500	-20	160-320	-1	-100	120	SOT-23	通用
2SB1197(Q)	PNP	AHQ	200	-800	-40	-32	-0.5	-500	-50	120-270	-3	-100	120	SOT-23	通用
2SB1197(R)	PNP	AHR	200	-800	-40	-32	-0.5	-500	-50	180-390	-3	-100	120	SOT-23	通用
2SD1781(Q)	NPN	AFQ	200	800	40	32	0.4	500	50	120-270	3	100	120	SOT-23	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SD1781(R)	NPN	AFR	200	800	40	32	0.4	500	50	180-390	3	100	120	SOT-23	通用
M28S	NPN	28S	300	1000	40	20	0.55	600	20	300-1000	1	100	100	SOT-23	通用
2SD2675	NPN	TL	300	1000	30	30	0.35	500	25	270-680	2	100	100	SOT-23	通用
MMBT4140	NPN	JD	450	1000	40	40	0.5	1000	100	300-900	5	500	150	SOT-23	通用
FMMT449	NPN	449	250	1000	35	30	0.5	1000	100	100-300	5	500	100	SOT-23	通用
FMMT549	PNP	549	310	-1000	-35	-30	-0.35	-1000	-100	100-300	-2	-500	100	SOT-23	通用
FMMT549A	PNP	59A	310	-1000	-35	-30	-0.35	-1000	-100	150-500	-2	-500	100	SOT-23	通用
FMMT489	NPN	489	250	1000	50	30	0.5	1000	100	100-300	5	500	150	SOT-23	通用
FMMT589	PNP	589	310	-1000	-50	-30	-0.35	-1000	-100	100-300	-2	-500	100	SOT-23	通用
FMMT491	NPN	491	250	1000	80	60	0.5	1000	100	100-300	5	500	150	SOT-23	通用
FMMT591	PNP	591	250	-1000	-80	-60	-0.6	-1000	-100	100-300	-5	-500	150	SOT-23	通用
FMMT591A	PNP	91A	250	-1000	-40	-40	-0.5	-1000	-100	300-800	-5	-500	150	SOT-23	通用
FMMT493	NPN	493	250	1000	120	100	0.6	1000	100	100-300	10	250	150	SOT-23	通用
FMMT593	PNP	593	250	-1000	-120	-100	-0.3	-500	-50	100-300	-5	-250	50	SOT-23	通用
FMMT617	NPN	617	625	3000	15	15	0.2	3000	100	300-450	2	200	100	SOT-23	通用
FMMT717	PNP	717	625	-2500	-12	-12	-0.6	-2500	-50	300-450	-2	-200	80	SOT-23	通用
FMMT618	NPN	618	625	2500	20	20	0.2	2500	50	300-450	2	200	100	SOT-23	通用
FMMT718	PNP	718	625	-1500	-20	-20	-0.2	-1500	-50	300-450	-2	-200	80	SOT-23	通用
FMMT619	NPN	619	250	2000	50	50	0.25	1500	50	300-450	2	200	150	SOT-23	通用
FMMT720	PNP	720	250	-2000	-50	-50	-0.3	-1500	-50	300-450	-2	-200	150	SOT-23	通用
FMMT624	NPN	624	625	1000	125	125	0.2	1000	30	300-450	2	200	100	SOT-23	通用
FMMT722	PNP	722	625	-1500	-70	-70	-0.25	-1500	-50	300-450	-2	-200	80	SOT-23	通用
FMMT625	NPN	625	625	1000	150	150	0.2	1000	30	300-450	2	200	100	SOT-23	通用
FMMT723	PNP	723	625	-1000	-100	-100	-0.2	-1000	-30	300-450	-2	-200	80	SOT-23	通用
MMBTA13	NPN	1M	300	300	30	30	1.5	100	0.1	>10000	5	100	50	SOT-23	达林顿
MMBTA14	NPN	1N	300	300	30	30	1.5	100	0.1	>20000	5	100	50	SOT-23	达林顿

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
MMBTA63	PNP	2U	300	-300	-30	-30	-1.5	-100	-0.1	>10000	-5	-100	50	SOT-23	达林顿
MMBTA64	PNP	2V	300	-300	-30	-30	-1.5	-100	-0.1	>20000	-5	-100	50	SOT-23	达林顿
BCV26	PNP	FD	300	-300	-40	-30	-1	-100	-0.1	>20000	-5	-100	50	SOT-23	达林顿
BCV27	NPN	FF	300	300	40	30	1.5	100	0.1	>20000	5	100	50	SOT-23	达林顿
BCV46	PNP	FE	300	-500	-80	-60	-1	-100	-0.1	>10000	-5	-100	50	SOT-23	达林顿
BCV47	NPN	FG	300	500	80	60	1	100	0.1	>10000	5	100	50	SOT-23	达林顿
FS13001	NPN	8D	350	200	600	420	0.5	50	10	20-30	20	10	8	SOT-23	高压开关
MMBT3904	NPN	1AM	225	200	60	40	0.3	50	5	100-300	1	10	300	SOT-23	开关
MMBT3906	PNP	2A	225	-200	-40	-40	-0.3	-50	-5	100-300	-1	-10	300	SOT-23	开关
MMBT4401	NPN	2X	225	600	60	40	0.4	150	15	100-300	1	150	250	SOT-23	开关
MMBT4403	PNP	2T	225	-600	-40	-40	-0.4	-150	-15	100-300	-2	-150	200	SOT-23	开关
MMBT2222	NPN	1B	225	600	60	30	0.4	150	15	100-300	10	150	250	SOT-23	开关
MMBT2222A	NPN	1P	225	600	75	40	0.3	150	15	100-300	10	150	300	SOT-23	开关
MMBT2907	PNP	M2B	225	-600	-60	-40	-0.4	-150	-15	100-300	-10	-150	200	SOT-23	开关
MMBT2907A	PNP	2F	225	-600	-60	-60	-0.4	-150	-15	100-300	-10	-150	200	SOT-23	开关
S9018	NPN	J8	150	20	20	20	0.6	10	1	40-200	5	1	800	SOT-23	高频
MMBTH10	NPN	3EM	225	50	30	25	0.5	4	0.4	>60	10	4	650	SOT-23	高频
KST10	NPN	3E	225	100	30	25	0.5	4	0.4	>60	10	4	650	SOT-23	高频
C380	NPN	380	225	50	35	30	0.4	10	1	40-240	12	2	400	SOT-23	高频
2SC3735(R)	NPN	B33	200	200	40	40	0.25	10	1	40-80	1	10	750	SOT-23	高频
2SC3735(O)	NPN	B34	200	200	40	40	0.25	10	1	60-120	1	10	750	SOT-23	高频
2SC3735(Y)	NPN	B35	200	200	40	40	0.25	10	1	100-200	1	10	750	SOT-23	高频
2SC2714(R)	NPN	QR	100	20	40	30	0.6	10	1	40-80	6	1	550	SOT-23	高频
2SC2714(O)	NPN	QO	100	20	40	30	0.6	10	1	70-140	6	1	550	SOT-23	高频
2SC2714(Y)	NPN	QY	100	20	40	30	0.6	10	1	100-200	6	1	550	SOT-23	高频
C3879S(R)	NPN	RR	150	50	35	30	0.4	10	1	40-80	12	2	400	SOT-23	高频

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
C3879S(O)	NPN	RO	150	50	35	30	0.4	10	1	70-140	12	2	400	SOT-23	高频
C3879S(Y)	NPN	RY	150	50	35	30	0.4	10	1	120-240	12	2	400	SOT-23	高频
BFS17A	NPN	E2	225	50	25	15	0.5	10	5	>25	1	2	2800	SOT-23	高频
2SC3838	NPN	AD	225	50	20	11	0.5	10	5	50-300	10	5	3200	SOT-23	高频
2SC3356Q	NPN	R23	200	100	20	12				50-100	10	20	7000	SOT-23	高频
2SC3356R	NPN	R24	200	100	20	12				80-160	10	20	7000	SOT-23	高频
2SC3356S	NPN	R25	200	100	20	12				150-250	10	20	7000	SOT-23	高频
MMBT3904W	NPN	K2N	200	200	60	40	0.3	50	5	100-300	1	10	300	SOT-323	开关
MMBT3906W	PNP	2A	200	-200	-40	-40	-0.3	-50	-5	100-300	-1	-10	250	SOT-323	开关
MMBT2222AW	NPN	K3P	200	600	75	40	0.3	150	15	100-300	10	150	300	SOT-323	开关
MMBT2907AW	PNP	K3F	200	-600	-60	-60	-0.4	-150	-15	100-300	-10	-150	200	SOT-323	开关
MMBT5401W	PNP	K4M	200	-300	-160	-150	-0.5	-50	-5	100-300	-5	-10	100	SOT-323	高压
MMBT5551W	NPN	K4N	200	300	180	160	0.2	50	5	100-300	5	10	100	SOT-323	高压
BC807W-16	PNP	5A	200	-500	-50	-45	-0.7	-500	-50	100-250	-1	-100	100	SOT-323	通用
BC807W-25	PNP	5B	200	-500	-50	-45	-0.7	-500	-50	160-400	-1	-100	100	SOT-323	通用
BC807W-40	PNP	5C	200	-500	-50	-45	-0.7	-500	-50	250-600	-1	-100	100	SOT-323	通用
BC817W-16	NPN	6A	200	500	50	45	0.7	500	50	100-250	1	100	100	SOT-323	通用
BC817W-25	NPN	6B	200	500	50	45	0.7	500	50	160-400	1	100	100	SOT-323	通用
BC817W-40	NPN	6C	200	500	50	45	0.7	500	50	250-600	1	100	100	SOT-323	通用
SS8050W	NPN	Y1	250	1500	30	20	0.5	800	80	120-400	1	100	100	SOT-323	通用
SS8550W	PNP	Y2	200	-1500	-30	-20	-0.5	-800	-80	120-400	-1	-100	100	SOT-323	通用
MMBT3904T	NPN	K5N	150	200	60	40	0.3	50	5	100-300	1	10	300	SOT-523	开关
MMBT3906T	PNP	3N	150	-200	-40	-40	-0.4	-50	-5	100-300	-1	-10	250	SOT-523	开关
BC847BS	双NPN	1F	200	100	50	45	0.65	100	5	200-450	5	2	200	SOT-363	通用
MMDT5451DW	PNP	KNM	200	-200	-160	-150	-0.5	-50	-5	100-300	-5	-10	100	SOT-363	高压
	NPN		200	200	180	160	0.2	50	5	100-300	5	10	100		

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
MMDT5401DW	双 PNP	2L	200	-200	-160	-150	-0.5	-50	-5	60-300	-5	-10	100	SOT-363	高压
MMDT5551DW	双 NPN	G1	200	200	180	160	0.2	50	5	100-300	5	10	100	SOT-363	高压
MMDT5401D	双 PNP	K4S	300	-200	-160	-150	-0.5	-50	-5	60-300	-5	-10	100	SOT-23-6L	高压
MMDT5551D	双 NPN	K4R	300	200	180	160	0.2	50	5	80-250	5	10	100	SOT-23-6L	高压
MMDT5551S	双 NPN	K4T	300	200	180	160	0.2	50	5	80-250	5	10	100	SOT-23-6L	高压
PXT8050	NPN	Y1	500	1500	40	25	0.5	800	150	85-400	1	100	100	SOT-89	功率通用
PXT8550	PNP	Y2	500	-1500	-40	-25	-0.5	-800	-150	85-400	-1	-100	100	SOT-89	功率通用
D882H(R)	NPN	D882H	500	3000	100	60	0.5	2000	200	60-120	2	1000	50	SOT-89	功率通用
D882H(O)	NPN	D882H	500	3000	100	60	0.5	2000	200	100-200	2	1000	50	SOT-89	功率通用
D882H(Y)	NPN	D882H	500	3000	100	60	0.5	2000	200	160-320	2	1000	50	SOT-89	功率通用
D882H(GR)	NPN	D882H	500	3000	100	60	0.5	2000	200	200-400	2	1000	50	SOT-89	功率通用
D882(R)	NPN	D882	500	3000	40	30	0.5	2000	200	60-120	2	1000	60	SOT-89	功率通用
D882(O)	NPN	D882	500	3000	40	30	0.5	2000	200	100-200	2	1000	60	SOT-89	功率通用
D882(Y)	NPN	D882	500	3000	40	30	0.5	2000	200	160-320	2	1000	60	SOT-89	功率通用
D882(GR)	NPN	D882	500	3000	40	30	0.5	2000	200	200-400	2	1000	60	SOT-89	功率通用
B772(R)	PNP	B772	500	-3000	-40	-30	-0.5	-2000	-200	60-120	-2	-1000	80	SOT-89	功率通用
B772(O)	PNP	B772	500	-3000	-40	-30	-0.5	-2000	-200	100-200	-2	-1000	80	SOT-89	功率通用
B772(Y)	PNP	B772	500	-3000	-40	-30	-0.5	-2000	-200	160-320	-2	-1000	80	SOT-89	功率通用
B772(GR)	PNP	B772	500	-3000	-40	-30	-0.5	-2000	-200	200-400	-2	-1000	80	SOT-89	功率通用
A1666(O)	PNP	WO	500	-2000	-50	-50	-0.5	-1000	-50	70-140	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
A1666(Y)	PNP	WY	500	-2000	-50	-50	-0.5	-1000	-50	120-240	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
A1273(O)	PNP	1273	500	-2000	-30	-30	-1	-1500	-30	100-200	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
A1273(Y)	PNP	1273	500	-2000	-30	-30	-1	-1500	-30	160-320	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
C4377(A)	NPN	SA	500	2000	30	10	0.5	2000	50	140-240	1	500	150	SOT-89	功率通用
C4377(B)	NPN	SB	500	2000	30	10	0.5	2000	50	200-330	1	500	150	SOT-89	功率通用
C4377(C)	NPN	SC	500	2000	30	10	0.5	2000	50	300-450	1	500	150	SOT-89	功率通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
C4377(D)	NPN	SD	500	2000	30	10	0.5	2000	50	420-600	1	500	150	SOT-89	功率通用
2SC4375(O)	NPN	GO	500	1500	30	30	2	1500	30	100-200	2	500	120	SOT-89	通用
2SC4375(Y)	NPN	GY	500	1500	30	30	2	1500	30	160-320	2	500	120	SOT-89	通用
D1898(O)	NPN	ZO	500	1000	100	80	0.4	500	20	70-140	3	500	100	SOT-89	通用
D1898(Y)	NPN	ZY	500	1000	100	80	0.4	500	20	120-240	3	500	100	SOT-89	通用
D1898(GR)	NPN	ZG	500	1000	100	80	0.4	500	20	200-400	3	500	100	SOT-89	通用
A1668(O)	PNP	JO	500	-1000	-80	-60	-0.7	-500	-50	60-120	-2	-50	120	SOT-89	通用
A1668(Y)	PNP	JY	500	-1000	-80	-60	-0.7	-500	-50	100-200	-2	-50	120	SOT-89	通用
A1668(GR)	PNP	JGR	500	-1000	-80	-60	-0.7	-500	-50	160-320	-2	-50	120	SOT-89	通用
C4378(Y)	NPN	TY	500	1000	80	60	0.5	500	50	100-200	2	50	150	SOT-89	通用
C4378(GR)	NPN	TGR	500	1000	80	60	0.5	500	50	160-320	2	50	150	SOT-89	通用
C4376(O)	NPN	PO	500	800	35	30	0.5	500	20	100-200	1	100	120	SOT-89	通用
C4376(Y)	NPN	PY	500	800	35	30	0.5	500	20	160-320	1	100	120	SOT-89	通用
C4373(O)	NPN	CO	500	800	120	120	1	500	50	80-160	5	100	120	SOT-89	通用
C4373(Y)	NPN	CY	500	800	120	120	1	500	50	120-240	5	100	120	SOT-89	通用
2SC4373(O)	NPN	CO	500	800	120	120	1	500	50	80-160	5	100	120	SOT-89	通用
2SC4373(Y)	NPN	CY	500	800	120	120	1	500	50	120-240	5	100	120	SOT-89	通用
2SC2881(O)	NPN	CO1	500	800	120	120	1	500	50	80-160	5	100	100	SOT-89	通用
2SC2881(Y)	NPN	CY1	500	800	120	120	1	500	50	120-240	5	100	100	SOT-89	通用
2SA1201(O)	PNP	DO	500	-800	-120	-120	-1	-500	-50	80-160	-5	-100	120	SOT-89	通用
2SA1201(Y)	PNP	DY	500	-800	-120	-120	-1	-500	-50	120-240	-5	-100	120	SOT-89	通用
C4374(O)	NPN	EO	500	400	80	80	0.4	200	20	70-140	2	50	100	SOT-89	通用
C4374(Y)	NPN	EY	500	400	80	80	0.4	200	20	120-240	2	50	100	SOT-89	通用
2SC4374(O)	NPN	EO	500	400	80	80	0.4	200	20	70-140	2	50	100	SOT-89	通用
2SC4374(Y)	NPN	EY	500	400	80	80	0.4	200	20	120-240	2	50	100	SOT-89	通用
2SA1662(O)	PNP	FO	500	-400	-80	-80	-0.4	-200	-20	70-140	-2	-50	120	SOT-89	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SA1662(Y)	PNP	FY	500	-400	-80	-80	-0.4	-200	-20	120-240	-2	-50	120	SOT-89	通用
2SC2884(O)	NPN	PO1	500	800	35	30	0.5	500	20	100-200	1	100	120	SOT-89	通用
2SC2884(Y)	NPN	PY1	500	800	35	30	0.5	500	20	160-320	1	100	120	SOT-89	通用
2SA1204(O)	PNP	RO	500	-800	-35	-30	-0.7	-500	-20	100-200	-1	-100	120	SOT-89	通用
2SA1204(Y)	PNP	RY	500	-800	-35	-30	-0.7	-500	-20	160-320	-1	-100	120	SOT-89	通用
2SA1664(O)	PNP	RO	500	-800	-35	-30	-0.7	-500	-20	100-200	-1	-100	120	SOT-89	通用
2SA1664(Y)	PNP	RY	500	-800	-35	-30	-0.7	-500	-20	160-320	-1	-100	120	SOT-89	通用
2SA1661(O)	PNP	DO.	500	-800	-120	-120	-1	-500	-50	80-160	-5	-100	120	SOT-89	通用
2SA1661(Y)	PNP	DY.	500	-800	-120	-120	-1	-500	-50	120-240	-5	-100	120	SOT-89	通用
2SD874(Q)	NPN	ZQ	500	1000	30	25	0.4	500	50	85-170	10	500	200	SOT-89	通用
2SD874(R)	NPN	ZR	500	1000	30	25	0.4	500	50	120-240	10	500	200	SOT-89	通用
2SD874(S)	NPN	ZS	500	1000	30	25	0.4	500	50	170-340	10	500	200	SOT-89	通用
2SB766(Q)	PNP	AQ	500	-1000	-30	-25	-0.4	-500	-50	85-170	-10	-500	200	SOT-89	通用
2SB766(R)	PNP	AR	500	-1000	-30	-25	-0.4	-500	-50	120-240	-10	-500	200	SOT-89	通用
2SB766(S)	PNP	AS	500	-1000	-30	-25	-0.4	-500	-50	170-340	-10	-500	200	SOT-89	通用
2SD874A(Q)	NPN	YQ	500	1000	60	50	0.4	500	50	85-170	10	500	200	SOT-89	通用
2SD874A(R)	NPN	YR	500	1000	60	50	0.4	500	50	120-240	10	500	200	SOT-89	通用
2SD874A(S)	NPN	YS	500	1000	60	50	0.4	500	50	170-340	10	500	200	SOT-89	通用
2SB766A(Q)	PNP	BQ	500	-1000	-60	-50	-0.4	-500	-50	85-170	-10	-500	200	SOT-89	通用
2SB766A(R)	PNP	BR	500	-1000	-60	-50	-0.4	-500	-50	120-240	-10	-500	200	SOT-89	通用
2SB766A(S)	PNP	BS	500	-1000	-60	-50	-0.4	-500	-50	170-340	-10	-500	200	SOT-89	通用
2SD1664(P)	NPN	DAP	500	1000	40	32	0.4	500	50	80-180	3	100	150	SOT-89	通用
2SD1664(Q)	NPN	DAQ	500	1000	40	32	0.4	500	50	120-270	3	100	150	SOT-89	通用
2SD1664(R)	NPN	DAR	500	1000	40	32	0.4	500	50	180-390	3	100	150	SOT-89	通用
2SB1132(P)	PNP	BAP	500	-1000	-40	-32	-0.4	-500	-50	80-180	-3	-100	150	SOT-89	通用
2SB1132(Q)	PNP	BAQ	500	-1000	-40	-32	-0.4	-500	-50	120-270	-3	-100	150	SOT-89	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SB1132(R)	PNP	BAR	500	-1000	-40	-32	-0.4	-500	-50	180-390	-3	-100	150	SOT-89	通用
2SB1119(R)	PNP	BB	500	-1000	-25	-25	-0.7	-500	-50	100-200	-2	-50	180	SOT-89	通用
2SB1119(S)	PNP	BB	500	-1000	-25	-25	-0.7	-500	-50	140-280	-2	-50	180	SOT-89	通用
2SB1119(T)	PNP	BB	500	-1000	-25	-25	-0.7	-500	-50	200-400	-2	-50	180	SOT-89	通用
2SB1119(U)	PNP	BB	500	-1000	-25	-25	-0.7	-500	-50	280-560	-2	-50	180	SOT-89	通用
2SD1767(P)	NPN	DCP	500	700	80	80	0.4	500	50	82-180	3	100	120	SOT-89	通用
2SD1767(Q)	NPN	DCQ	500	700	80	80	0.4	500	50	120-270	3	100	120	SOT-89	通用
2SD1767(R)	NPN	DCR	500	700	80	80	0.4	500	50	180-390	3	100	120	SOT-89	通用
2SB1189(P)	PNP	BDP	500	-700	-80	-80	-0.4	-500	-50	82-180	-3	-100	100	SOT-89	通用
2SB1189(Q)	PNP	BDQ	500	-700	-80	-80	-0.4	-500	-50	120-270	-3	-100	100	SOT-89	通用
2SB1189(R)	PNP	BDR	500	-700	-80	-80	-0.4	-500	-50	180-390	-3	-100	100	SOT-89	通用
2SD1898(P)	NPN	DF	500	1000	100	80	0.4	500	50	82-180	3	100	100	SOT-89	通用
2SD1898(Q)	NPN	DF	500	1000	100	80	0.4	500	50	120-270	3	100	100	SOT-89	通用
2SD1898(R)	NPN	DF	500	1000	100	80	0.4	500	50	180-390	3	100	100	SOT-89	通用
2SB1260(P)	PNP	ZL	500	-1000	-100	-80	-0.4	-500	-50	82-180	-3	-100	100	SOT-89	通用
2SB1260(Q)	PNP	ZL	500	-1000	-100	-80	-0.4	-500	-50	120-270	-3	-100	100	SOT-89	通用
2SB1260(R)	PNP	ZL	500	-1000	-100	-80	-0.4	-500	-50	180-390	-3	-100	100	SOT-89	通用
2SD1005(W)	NPN	BW	500	1000	100	80	0.5	500	50	90-180	2	100	160	SOT-89	通用
2SD1005(V)	NPN	BV	500	1000	100	80	0.5	500	50	135-270	2	100	160	SOT-89	通用
2SD1005(U)	NPN	BU	500	1000	100	80	0.5	500	50	200-400	2	100	160	SOT-89	通用
2SB804(W)	PNP	AW	500	-1000	-100	-80	-0.5	-500	-50	90-180	-2	-100	80	SOT-89	通用
2SB804(V)	PNP	AV	500	-1000	-100	-80	-0.5	-500	-50	135-270	-2	-100	80	SOT-89	通用
2SB804(U)	PNP	AU	500	-1000	-100	-80	-0.5	-500	-50	200-400	-2	-100	80	SOT-89	通用
BSR33	PNP	BR4	500	-1000	-90	-80	-0.5	-500	-50	100-300	-5	-100	100	SOT-89	通用
HM4033	PNP	H4033	500	-1000	-80	-80	-0.5	-500	-50	>100	-5	-100	100	SOT-89	通用
BCX591	PNP	P1	500	-100	-80	-60	-0.6	-1000	-100	100-300	-1	-500	120	SOT-89	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SD999(L)	NPN	CL	500	1000	30	25	0.4	1000	100	90-180	1	100	130	SOT-89	通用
2SD999(M)	NPN	CM	500	1000	30	25	0.4	1000	100	135-270	1	100	130	SOT-89	通用
2SD999(K)	NPN	CK	500	1000	30	25	0.4	1000	100	200-400	1	100	130	SOT-89	通用
BC868-10	NPN	CBC	500	1000	32	20	0.5	1000	100	85-160	1	500	100	SOT-89	通用
BC868-16	NPN	CCC	500	1000	32	20	0.5	1000	100	100-250	1	500	100	SOT-89	通用
BC868-25	NPN	CDC	500	1000	32	20	0.5	1000	100	160-375	1	500	100	SOT-89	通用
BC869	PNP	CEC	500	-1000	-32	-20	-0.5	-1000	-100	100-375	-10	-500	100	SOT-89	通用
BC869-16	PNP	CGC	500	-1000	-32	-20	-0.5	-1000	-100	100-250	-10	-500	100	SOT-89	通用
BC869-25	PNP	CHC	500	-1000	-32	-20	-0.5	-1000	-100	160-375	-10	-500	100	SOT-89	通用
BCX69	PNP	CE1	500	-1000	-25	-20	-0.5	-1000	-100	85-375	-10	-500	100	SOT-89	通用
BCX69-10	PNP	CF1	500	-1000	-25	-20	-0.5	-1000	-100	85-160	-10	-500	100	SOT-89	通用
BCX69-16	PNP	CG1	500	-1000	-25	-20	-0.5	-1000	-100	100-250	-10	-500	100	SOT-89	通用
BCX69-25	PNP	CH1	500	-1000	-25	-20	-0.5	-1000	-100	160-375	-10	-500	100	SOT-89	通用
BCX54	NPN	BA	500	1000	45	45	0.5	500	50	63-250	2	150	130	SOT-89	通用
BCX54-10	NPN	BC	500	1000	45	45	0.5	500	50	63-160	2	150	130	SOT-89	通用
BCX54-16	NPN	BD	500	1000	45	45	0.5	500	50	100-250	2	150	130	SOT-89	通用
BCX55	NPN	BE	500	1000	60	60	0.5	500	50	63-250	2	150	130	SOT-89	通用
BCX55-10	NPN	BG	500	1000	60	60	0.5	500	50	63-160	2	150	130	SOT-89	通用
BCX55-16	NPN	BM	500	1000	60	60	0.5	500	50	100-250	2	150	130	SOT-89	通用
BCX56	NPN	BH	500	1000	100	80	0.5	500	50	63-250	2	150	130	SOT-89	通用
BCX56-10	NPN	BK	500	1000	100	80	0.5	500	50	63-160	2	150	130	SOT-89	通用
BCX56-16	NPN	BL	500	1000	100	80	0.5	500	50	100-250	2	150	130	SOT-89	通用
BSR43	NPN	AR4	500	1000	90	80	0.5	500	50	100-300	5	100	100	SOT-89	通用
BCX51	PNP	AA	500	-1000	-45	-45	-0.5	-500	-50	63-250	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX51-10	PNP	AC	500	-1000	-45	-45	-0.5	-500	-50	63-160	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX51-16	PNP	AD	500	-1000	-45	-45	-0.5	-500	-50	100-250	-2	-150	50	SOT-89	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
BCX52	PNP	AE	500	-1000	-60	-60	-0.5	-500	-50	63-250	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX52-10	PNP	AG	500	-1000	-60	-60	-0.5	-500	-50	63-160	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX52-16	PNP	AM	500	-1000	-60	-60	-0.5	-500	-50	100-250	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX53	PNP	AH	500	-1000	-100	-80	-0.5	-500	-50	63-250	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX53-10	PNP	AK	500	-1000	-100	-80	-0.5	-500	-50	63-160	-2	-150	50	SOT-89	通用
BCX53-16	PNP	AL	500	-1000	-100	-80	-0.5	-500	-50	100-250	-2	-150	50	SOT-89	通用
2SCR553	NPN	EL	500	2000	50	50	0.35	700	50	180-450	2	50	120	SOT-89	功率通用
2SAR553	PNP	DL	500	-2000	-50	-50	-0.4	-700	-50	180-450	-2	-50	120	SOT-89	功率通用
2SC1766(P)	NPN	P1766	500	2000	50	50	0.5	1000	50	82-180	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SC1766(Q)	NPN	Q1766	500	2000	50	50	0.5	1000	50	120-270	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SC1766(R)	NPN	R1766	500	2000	50	50	0.5	1000	50	180-390	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SD1766(P)	NPN	DBP	500	2000	40	32	0.8	2000	200	80-180	3	500	100	SOT-89	功率通用
2SD1766(Q)	NPN	DBQ	500	2000	40	32	0.8	2000	200	120-270	3	500	100	SOT-89	功率通用
2SD1766(R)	NPN	DBR	500	2000	40	32	0.8	2000	200	180-390	3	500	100	SOT-89	功率通用
2SB1188(P)	PNP	BCP	500	-2000	-40	-32	-0.8	-2000	-200	80-180	-3	-500	100	SOT-89	功率通用
2SB1188(Q)	PNP	BCQ	500	-2000	-40	-32	-0.8	-2000	-200	120-270	-3	-500	100	SOT-89	功率通用
2SB1188(R)	PNP	BCR	500	-2000	-40	-32	-0.8	-2000	-200	180-390	-3	-500	100	SOT-89	功率通用
2SC4115(Q)	NPN	4115Q	500	3000	40	20	0.5	2000	100	120-270	2	100	290	SOT-89	功率通用
2SC4115(R)	NPN	4115R	500	3000	40	20	0.5	2000	100	180-390	2	100	290	SOT-89	功率通用
2SC4115(S)	NPN	4115S	500	3000	40	20	0.5	2000	100	270-560	2	100	290	SOT-89	功率通用
2SB1073(Q)	PNP	IQ	500	-4000	-30	-20	-1	-3000	-100	120-205	-2	-2000	120	SOT-89	功率通用
2SB1073(R)	PNP	IR	500	-4000	-30	-20	-1	-3000	-100	180-315	-2	-2000	120	SOT-89	功率通用
2SB1308(P)	PNP	BFP	500	-3000	-30	-20	-0.45	-1500	-150	82-180	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
2SB1308(Q)	PNP	BFQ	500	-3000	-30	-20	-0.45	-1500	-150	120-270	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
2SB1308(R)	PNP	BFR	500	-3000	-30	-20	-0.45	-1500	-150	180-390	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
2SB1386(P)	PNP	BHP	500	-5000	-30	-20	-1	-4000	-100	82-180	-2	-500	120	SOT-89	功率通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SB1386(Q)	PNP	BHQ	500	-5000	-30	-20	-1	-4000	-100	120-270	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
2SB1386(R)	PNP	BHR	500	-5000	-30	-20	-1	-4000	-100	180-390	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
2SD2098(Q)	NPN	AHQ	500	5000	50	20	1	4000	100	120-270	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD2098(R)	NPN	AHR	500	5000	50	20	1	4000	100	180-390	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD965(Q)	NPN	D965	500	5000	40	20	1	3000	100	230-380	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD965(R)	NPN	D965	500	5000	40	20	1	3000	100	340-600	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD965(S)	NPN	D965	500	5000	40	20	1	3000	100	560-800	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD965A(Q)	NPN	D965A	500	5000	40	30	1	3000	100	230-380	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD965A(R)	NPN	D965A	500	5000	40	30	1	3000	100	340-600	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD965A(S)	NPN	D965A	500	5000	40	30	1	3000	100	560-800	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD2150(R)	NPN	CFR	500	3000	40	20	0.5	2000	100	180-390	2	100	290	SOT-89	功率通用
2SD2150(S)	NPN	CFS	500	3000	40	20	0.5	2000	100	270-560	2	100	290	SOT-89	功率通用
2SB1424(Q)	PNP	AEQ	500	-3000	-20	-20	-0.5	-2000	-100	120-270	-2	-100	240	SOT-89	功率通用
2SB1424(R)	PNP	AER	500	-3000	-20	-20	-0.5	-2000	-100	180-390	-2	-100	240	SOT-89	功率通用
2SD2185(R)	NPN	1H	500	3000	50	50	0.3	1000	50	120-240	2	200	80	SOT-89	功率通用
2SD2185(S)	NPN	1H	500	3000	50	50	0.3	1000	50	170-340	2	200	80	SOT-89	功率通用
2SD1119(Q)	NPN	TQ	500	3000	40	25	1	3000	100	230-380	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SD1119(R)	NPN	TR	500	3000	40	25	1	3000	100	340-600	2	500	150	SOT-89	功率通用
2SB1440(R)	PNP	1L	500	-2000	-50	-50	-0.3	-1000	-50	120-240	-2	-200	80	SOT-89	功率通用
2SB1440(S)	PNP	1L	500	-2000	-50	-50	-0.3	-1000	-50	170-340	-2	-200	80	SOT-89	功率通用
2SA1797(P)	PNP	AGP	500	-2000	-50	-50	-0.35	-1000	-50	82-180	-2	-500	200	SOT-89	功率通用
2SA1797(Q)	PNP	AGQ	500	-2000	-50	-50	-0.35	-1000	-50	120-270	-2	-500	200	SOT-89	功率通用
2SA1797(R)	PNP	AGR	500	-2000	-50	-50	-0.35	-1000	-50	180-390	-2	-500	200	SOT-89	功率通用
2SC4672(P)	NPN	DKP	500	2000	60	50	0.35	1000	50	82-180	2	500	210	SOT-89	功率通用
2SC4672(Q)	NPN	DKQ	500	2000	60	50	0.35	1000	50	120-270	2	500	210	SOT-89	功率通用
2SC4672(R)	NPN	DKR	500	2000	60	50	0.35	1000	50	180-390	2	500	210	SOT-89	功率通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SD2391(P)	NPN	DTP*	500	2000	60	60	0.35	1000	50	82-180	2	500	210	SOT-89	功率通用
2SD2391(Q)	NPN	DTQ*	500	2000	60	60	0.35	1000	50	120-270	2	500	210	SOT-89	功率通用
2SD2391(R)	NPN	DTR*	500	2000	60	60	0.35	1000	50	180-390	2	500	210	SOT-89	功率通用
C4375(O)	NPN	GO	500	1500	30	30	1	1500	30	100-200	2	500	120	SOT-89	功率通用
C4375(Y)	NPN	GY	500	1500	30	30	1	1500	30	160-320	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SC2883(O)	NPN	GO	500	1500	30	30	1	1500	30	100-200	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SC2883(Y)	NPN	GY	500	1500	30	30	1	1500	30	160-320	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SA1203(O)	PNP	HO1	500	-1500	-30	-30	-1	-1500	-30	100-200	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
2SA1203(Y)	PNP	HY1	500	-1500	-30	-30	-1	-1500	-30	160-320	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
A1663(O)	PNP	HO	500	-1500	-30	-30	-1	-1500	-30	100-200	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
A1663(Y)	PNP	HY	500	-1500	-30	-30	-1	-1500	-30	160-320	-2	-500	120	SOT-89	功率通用
C3205(O)	NPN	3205	500	2000	30	30	1	1500	30	100-200	2	500	120	SOT-89	功率通用
C3205(Y)	NPN	3205	500	2000	30	30	1	1500	30	160-320	2	500	120	SOT-89	功率通用
2SC2873(O)	NPN	MO	500	2000	50	50	0.5	1000	50	70-140	2	500	120	SOT-89	功率开关
2SC2873(Y)	NPN	MY	500	2000	50	50	0.5	1000	50	120-240	2	500	120	SOT-89	功率开关
2SA1213(O)	PNP	NO	500	-2000	-50	-50	-0.5	-1000	-50	70-140	-2	-500	100	SOT-89	功率开关
2SA1213(Y)	PNP	NY	500	-2000	-50	-50	-0.5	-1000	-50	120-240	-2	-500	100	SOT-89	功率开关
C4379(O)	NPN	UO	500	2000	50	50	0.5	1000	50	70-140	2	500	120	SOT-89	功率开关
C4379(Y)	NPN	UY	500	2000	50	50	0.5	1000	50	120-240	2	500	120	SOT-89	功率开关
C2655(O)	NPN	2655O	500	2000	50	50	0.5	1000	50	70-140	2	500	120	SOT-89	功率开关
C2655(Y)	NPN	2655Y	500	2000	50	50	0.5	1000	50	120-240	2	500	120	SOT-89	功率开关
2SA1417(R)	PNP	ACR	500	-2000	-120	-100	-0.6	-1000	-100	100-200	-5	-100	120	SOT-89	功率开关
2SA1417(S)	PNP	ACS	500	-2000	-120	-100	-0.6	-1000	-100	140-280	-5	-100	120	SOT-89	功率开关
2SA1417(T)	PNP	ACT	500	-2000	-120	-100	-0.6	-1000	-100	200-400	-5	-100	120	SOT-89	功率开关
PXT2222A	NPN	1P	500	600	75	40	0.3	150	15	100-300	10	150	300	SOT-89	开关
PXT2907A	PNP	P2F	500	-600	-60	-60	-0.4	-150	-15	100-300	-10	-150	200	SOT-89	开关

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
PXT3904	NPN	1A	500	200	60	40	0.3	50	5	100-300	1	10	300	SOT-89	开关
PXT3906	PNP	2A	500	-200	-40	-40	-0.3	-50	-5	100-300	-1	-10	300	SOT-89	开关
2SC4548(D)	NPN	CN	500	200	400	400	0.6	50	5	60-120	10	50	70	SOT-89	高压
2SC4548(E)	NPN	CN	500	200	400	400	0.6	50	5	100-200	10	50	70	SOT-89	高压
2SA1740(D)	PNP	AK	500	-200	-400	-400	-0.6	-50	-5	60-120	-10	-50	70	SOT-89	高压
2SA1740(E)	PNP	AK	500	-200	-400	-400	-0.6	-50	-5	100-200	-10	-50	70	SOT-89	高压
2SD2413	NPN	1S	500	100	400	400	0.9	50	5	>30	5	30	40	SOT-89	高压
BST39	NPN	AT1	500	100	400	350	0.5	50	4	>30	10	20	70	SOT-89	高压
BST40	NPN	AT2	500	100	300	250	0.5	50	4	>30	10	20	70	SOT-89	高压
A42	NPN	A42	500	200	310	305	0.2	20	2	100-200	10	10	50	SOT-89	高压
A92	PNP	A92	500	-200	-310	-305	-0.2	-20	-2	100-200	-10	-10	50	SOT-89	高压
A94	PNP	A94	500	-200	-400	-400	-0.6	-20	-2	100-200	-10	-10	50	SOT-89	高压
BF620	NPN	DC	500	50	300	300	0.6	30	5	100-200	20	10	60	SOT-89	高压
BF621	PNP	DF	500	-50	-300	-300	-0.8	-30	-5	100-200	-20	-10	60	SOT-89	高压
FS621	PNP	621	500	-50	-310	-305	-0.8	-30	-5	100-200	-20	-10	60	SOT-89	高压
BF622	NPN	DA	500	50	250	250	0.6	30	5	100-200	20	10	60	SOT-89	高压
BF623	PNP	DB	500	-50	-250	-250	-0.8	-30	-5	100-200	-20	-10	60	SOT-89	高压
C4372(O)	NPN	AO	500	50	200	150	0.5	50	5	70-140	5	10	120	SOT-89	高压
C4372(Y)	NPN	AY	500	50	200	150	0.5	50	5	120-240	5	10	120	SOT-89	高压
A1013(R)	PNP	1013R	500	-1000	-160	-160	-1.5	-500	-50	60-120	-5	-200	15	SOT-89	高压
A1013(O)	PNP	1013O	500	-1000	-160	-160	-1.5	-500	-50	100-200	-5	-200	15	SOT-89	高压
A1013(Y)	PNP	1013Y	500	-1000	-160	-160	-1.5	-500	-50	160-320	-5	-200	15	SOT-89	高压
C2383(R)	NPN	2383R	500	1000	160	160	1	500	50	60-120	5	200	20	SOT-89	高压
C2383(O)	NPN	2383O	500	1000	160	160	1	500	50	100-200	5	200	20	SOT-89	高压
C2383(Y)	NPN	2383Y	500	1000	160	160	1	500	50	160-320	5	200	20	SOT-89	高压
CXT5551	NPN	1G6	500	600	180	160	0.2	50	5	100-300	5	10	100	SOT-89	高压

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc (mW)	Ic(mA)	BV_{CBO} (V)	BV_{CEO} (V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
CXT5401	PNP	5401	500	-500	-160	-150	-0.5	-50	-5	100-300	-5	-10	100	SOT-89	高压
2SC3357H	NPN	RH	350	100	20	12				50-100	10	20	6500	SOT-89	高频
2SC3357F	NPN	RF	350	100	20	12				80-160	10	20	6500	SOT-89	高频
2SC3357E	NPN	RE	350	100	20	12				150-250	10	20	6500	SOT-89	高频
T9012D	PNP	T9012D	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	64-91	-1	-50	150	TO-92	通用
T9012E	PNP	T9012E	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	78-112	-1	-50	150	TO-92	通用
T9012F	PNP	T9012F	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	96-135	-1	-50	150	TO-92	通用
T9012G	PNP	T9012G	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	112-166	-1	-50	150	TO-92	通用
T9012H	PNP	T9012H	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	144-202	-1	-50	150	TO-92	通用
T9012I	PNP	T9012I	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	190-300	-1	-50	150	TO-92	通用
T9012J	PNP	T9012J	625	-500	-40	-25	-0.6	-500	-50	280-400	-1	-50	150	TO-92	通用
T9013D	NPN	T9013D	625	500	40	25	0.6	500	50	64-91	1	50	150	TO-92	通用
T9013E	NPN	T9013E	625	500	40	25	0.6	500	50	78-112	1	50	150	TO-92	通用
T9013F	NPN	T9013F	625	500	40	25	0.6	500	50	96-135	1	50	150	TO-92	通用
T9013G	NPN	T9013G	625	500	40	25	0.6	500	50	112-166	1	50	150	TO-92	通用
T9013H	NPN	T9013H	625	500	40	25	0.6	500	50	144-202	1	50	150	TO-92	通用
T9013I	NPN	T9013I	625	500	40	25	0.6	500	50	190-300	1	50	150	TO-92	通用
T9013J	NPN	T9013J	625	500	40	25	0.6	500	50	280-400	1	50	150	TO-92	通用
T9014A	NPN	T9014A	450	100	50	45	0.3	100	5	60-150	5	1	150	TO-92	通用
T9014B	NPN	T9014B	450	100	50	45	0.3	100	5	100-300	5	1	150	TO-92	通用
T9014C	NPN	T9014C	450	100	50	45	0.3	100	5	200-600	5	1	150	TO-92	通用
T9014D	NPN	T9014D	450	100	50	45	0.3	100	5	400-1000	5	1	150	TO-92	通用
T9015A	PNP	T9015A	450	-100	-50	-45	-0.3	-100	-5	60-150	-5	-1	150	TO-92	通用
T9015B	PNP	T9015B	450	-100	-50	-45	-0.3	-100	-5	100-300	-5	-1	150	TO-92	通用
T9015C	PNP	T9015C	450	-100	-50	-45	-0.3	-100	-5	200-600	-5	-1	150	TO-92	通用
T9015D	PNP	T9015D	450	-100	-50	-45	-0.3	-100	-5	400-1000	-5	-1	150	TO-92	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2SA1015O	PNP	A1015O	400	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	70-140	-6	-2	80	TO-92	通用
2SA1015Y	PNP	A1015Y	400	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	120-240	-6	-2	80	TO-92	通用
2SA1015GR	PNP	A1015GR	400	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	200-400	-6	-2	80	TO-92	通用
2SA1015BL	PNP	A1015BL	400	-150	-50	-50	-0.3	-100	-10	350-700	-6	-2	80	TO-92	通用
2SC1815O	NPN	C1815O	400	150	60	50	0.25	100	10	70-140	6	2	80	TO-92	通用
2SC1815Y	NPN	C1815Y	400	150	60	50	0.25	100	10	120-240	6	2	80	TO-92	通用
2SC1815GR	NPN	C1815GR	400	150	60	50	0.25	100	10	200-400	6	2	80	TO-92	通用
2SC1815BL	NPN	C1815BL	400	150	60	50	0.25	100	10	350-700	6	2	80	TO-92	通用
2SC945O	NPN	C945O	400	150	60	50	0.3	100	10	70-140	6	1	200	TO-92	通用
2SC945Y	NPN	C945Y	400	150	60	50	0.3	100	10	120-240	6	1	200	TO-92	通用
2SC945GR	NPN	C945GR	400	150	60	50	0.3	100	10	200-400	6	1	200	TO-92	通用
2SC945BL	NPN	C945BL	400	150	60	50	0.3	100	10	350-700	6	1	200	TO-92	通用
2SA733R	PNP	A733R	250	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	90-180	-6	-1	100	TO-92	通用
2SA733Q	PNP	A733Q	250	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	135-270	-6	-1	100	TO-92	通用
2SA733P	PNP	A733P	250	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	200-400	-6	-1	100	TO-92	通用
2SA733K	PNP	A733K	250	-100	-60	-50	-0.3	-100	-10	300-600	-6	-1	100	TO-92	通用
C3198(O)	NPN	C3198	625	150	60	50	0.25	100	10	70-140	6	2	80	TO-92	通用
C3198(Y)	NPN	C3198	625	150	60	50	0.25	100	10	120-240	6	2	80	TO-92	通用
C3198(GR)	NPN	C3198	625	150	60	50	0.25	100	10	200-400	6	2	80	TO-92	通用
C3198(BL)	NPN	C3198	625	150	60	50	0.25	100	10	300-700	6	2	80	TO-92	通用
A1271(O)	PNP	A1271	625	-800	-35	-30	-0.7	-500	-20	100-200	-1	-100	120	TO-92	通用
A1271(Y)	PNP	A1271	625	-800	-35	-30	-0.7	-500	-20	160-320	-1	-100	120	TO-92	通用
C1008(R)	NPN	C1008	800	700	80	60	0.4	500	50	40-80	2	50	30	TO-92	通用
C1008(O)	NPN	C1008	800	700	80	60	0.4	500	50	70-140	2	50	30	TO-92	通用
C1008(Y)	NPN	C1008	800	700	80	60	0.4	500	50	120-240	2	50	30	TO-92	通用
C1008(G)	NPN	C1008	800	700	80	60	0.4	500	50	200-400	2	50	30	TO-92	通用

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

晶体三极管

型号	极性	印字	功率	集电流	集基耐压	集射耐压	饱和压降	压降测试条件		放大倍数	倍数测试条件		频率	封装	特点
Type	Polarity	Marking	Pc(mW)	Ic(mA)	BV_{CBO}(V)	BV_{CEO}(V)	$V_{CE(SAT)}$	Ic(mA)	I_B(mA)	HFE@VCE/IC	V_{CE} (V)	Ic(mA)	fT(MHz)	Package	Feature
2N5401	PNP	2N5401	625	-500	-160	-150	-0.5	-50	-5	100-300	-5	-10	100	TO-92	高压
2N5551	NPN	2N5551	625	600	180	160	0.2	50	5	100-300	5	10	100	TO-92	高压
MPSA42	NPN	A42	625	500	300	300	0.5	20	2	40-300	10	10	50	TO-92	高压
MPSA92	PNP	A92	625	-500	-300	-300	-0.5	-20	-2	40-300	-10	-10	50	TO-92	高压
MPSA44	NPN	A44	625	200	400	400	0.5	100	10	40-300	10	10	50	TO-92	高压
MPSA94	PNP	A94	625	-200	-400	-400	-0.6	-20	-2	40-240	-10	-10	50	TO-92	高压
2N2222A	NPN	2N2222A	625	600	75	40	0.3	150	15	100-300	10	150	300	TO-92	开关
2N2907A	PNP	2N2907A	625	-600	-60	-60	-0.4	-150	-15	100-300	-10	-150	200	TO-92	开关
2N3904	NPN	2N3904	625	200	60	40	0.3	50	5	100-400	1	10	300	TO-92	开关
2N3906	PNP	2N3906	625	-200	-40	-40	-0.3	-50	-5	100-400	-1	-10	300	TO-92	开关
2SC2383(R)	NPN	C2383	750	1000	160	160	1	500	50	60-120	5	200	20	TO-92L	高压
2SC2383(O)	NPN	C2383	750	1000	160	160	1	500	50	100-200	5	200	20	TO-92L	高压
2SC2383(Y)	NPN	C2383	750	1000	160	160	1	500	50	160-320	5	200	20	TO-92L	高压
C3209(O)	NPN	C3209	1000	2000	50	50	0.5	1000	50	70-140	2	500	100	TO-92L	功率
C3209(Y)	NPN	C3209	1000	2000	50	50	0.5	1000	50	120-240	2	500	100	TO-92L	功率
2SC1384(Q)	NPN	C1384	750	1000	60	50	0.4	500	50	85-170	10	500	200	TO-92L	功率
2SC1384(R)	NPN	C1384	750	1000	60	50	0.4	500	50	120-240	10	500	200	TO-92L	功率
2SC1384(S)	NPN	C1384	750	1000	60	50	0.4	500	50	170-340	10	500	200	TO-92L	功率

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
DTA113T	PNP	-50	-100	200	250	-3.8	100	1	∞	91	SOT-23
DTA113Z	PNP	-50	-100	200	250	-7.2	33	1	10	11	SOT-23
DTA114E	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	30	10	10	14	SOT-23
DTA114G	PNP	-50	-100	200	250	-7.2	30	0	10	K14	SOT-23
DTA114T	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	100	10	∞	94	SOT-23
DTA114W	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	24	10	4.7	74	SOT-23
DTA114Y	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	68	10	47	54	SOT-23
DTA115E	PNP	-50	-100	200	250	-0.15	82	100	100	19	SOT-23
DTA115G	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	82	0	100	K19	SOT-23
DTA115T	PNP	-50	-100	200	250	-0.15	100	100	∞	99	SOT-23
DTA115U	PNP	-50	-100	200	250	-0.1	27	100	10	79	SOT-23
DTA123E	PNP	-50	-100	200	250	-3.8	20	2.2	2.2	12	SOT-23
DTA123J	PNP	-50	-100	200	250	-3.8	60	2.2	47	32	SOT-23
DTA123Y	PNP	-50	-100	200	250	-3.8	33	2.2	10	52	SOT-23
DTA124E	PNP	-50	-100	200	250	-0.38	56	22	22	15	SOT-23
DTA124G	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	56	0	10	K15	SOT-23
DTA124T	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	100	22	∞	95	SOT-23
DTA124X	PNP	-50	-100	200	250	-0.38	68	22	47	35	SOT-23
DTA125T	PNP	-50	-100	200	250	-0.33	100	200	∞	9A	SOT-23
DTA143E	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	20	4.7	4.7	13	SOT-23
DTA143T	PNP	-50	-100	200	250	-7.2	100	4.7	∞	93	SOT-23
DTA143X	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	30	4.7	10	33	SOT-23
DTA143Y	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	56	4.7	22	53	SOT-23
DTA143Z	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	60	4.7	47	E13	SOT-23
DTA144E	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	68	47	47	16	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
DTA144G	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	68	0	47	K16	SOT-23
DTA144T	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	100	47	∞	96	SOT-23
DTA144V	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	33	47	10	56	SOT-23
DTA144W	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	56	47	22	76	SOT-23
DTA214Y	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	68	10	47	N14	SOT-23
DTA1D3R	PNP	-50	-100	200	250	-3.7	20	2.7	1	K38	SOT-23
DTB113E	PNP	-50	-500	200	250	-7.2	33	1	1	F11	SOT-23
DTB113Z	PNP	-50	-500	200	250	-7.2	56	1	10	G11	SOT-23
DTB114E	PNP	-50	-500	200	250	-0.88	56	10	10	F14	SOT-23
DTB114G	PNP	-50	-500	200	250	-7.2	56	0	10	L14	SOT-23
DTB114T	PNP	-50	-500	200	250	-0.88	100	10	∞	E94	SOT-23
DTB122J	PNP	-50	-500	200	250	-4.5	47	0.22	4.7	G3C	SOT-23
DTB123E	PNP	-50	-500	200	250	-3.8	39	2.2	2.2	F12	SOT-23
DTB123T	PNP	-50	-500	200	250	-7.2	100	2.2	∞	E92	SOT-23
DTB123Y	PNP	-50	-500	200	250	-3.6	56	2.2	10	F52	SOT-23
DTB133H	PNP	-50	-500	200	250	-2.4	56	3.3	10	G98	SOT-23
DTB143E	PNP	-50	-500	200	250	-1.8	47	4.7	4.7	F13	SOT-23
DTB143T	PNP	-50	-500	200	250	-0.88	100	4.7	∞	F03	SOT-23
DTB163T	PNP	-50	-500	200	250	-1.8	100	6.8	∞	E97	SOT-23
DTC113T	NPN	50	100	200	250	3.8	100	1	∞	1	SOT-23
DTC113Z	NPN	50	100	200	250	7.2	33	1	10	E12	SOT-23
DTC114E	NPN	50	100	200	250	0.88	30	10	10	24	SOT-23
DTC114G	NPN	50	100	200	250	7.2	30	0	10	K24	SOT-23
DTC114T	NPN	50	100	200	250	0.88	100	10	∞	4	SOT-23
DTC114W	NPN	50	100	200	250	0.88	24	10	4.7	84	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
DTC114Y	NPN	50	100	200	250	0.88	68	10	47	64	SOT-23
DTC115E	NPN	50	100	200	250	0.15	82	100	100	29	SOT-23
DTC115G	NPN	50	100	200	250	0.88	82	0	100	K29	SOT-23
DTC115T	NPN	50	100	200	250	0.15	100	100	∞	9	SOT-23
DTC115U	NPN	50	100	200	250	0.1	27	100	10	E89	SOT-23
DTC123E	NPN	50	100	200	250	3.8	20	2.2	2.2	22	SOT-23
DTC123J	NPN	50	100	200	250	3.8	80	2.2	47	E42	SOT-23
DTC123T	NPN	50	100	200	200	7.2	100	2.2	∞	N03	SOT-23
DTC123Y	NPN	50	100	200	250	3.8	33	2.2	10	62	SOT-23
DTC124E	NPN	50	100	200	250	0.38	56	22	22	25	SOT-23
DTC124G	NPN	50	100	200	250	0.88	56	0	22	K25	SOT-23
DTC124T	NPN	50	100	200	250	1.8	100	22	∞	5	SOT-23
DTC124X	NPN	50	100	200	250	0.38	68	22	47	45	SOT-23
DTC125T	NPN	50	100	200	250	0.33	100	200	∞	0A	SOT-23
DTC143E	NPN	50	100	200	250	1.8	20	4.7	4.7	23	SOT-23
DTC143T	NPN	50	100	200	250	7.2	100	4.7	∞	3	SOT-23
DTC143X	NPN	50	100	200	250	1.8	30	4.7	10	43	SOT-23
DTC143Y	NPN	50	100	200	250	1.8	56	4.7	22	63	SOT-23
DTC143Z	NPN	50	100	200	250	1.8	80	4.7	47	E23	SOT-23
DTC144E	NPN	50	100	200	250	0.18	68	47	47	26	SOT-23
DTC144G	NPN	50	100	200	250	1.8	68	0	47	K26	SOT-23
DTC144T	NPN	50	100	200	250	0.88	100	47	∞	6	SOT-23
DTC144V	NPN	50	100	200	250	0.18	33	47	10	E66	SOT-23
DTC144W	NPN	50	100	200	250	0.18	56	47	22	86	SOT-23
DTC214Y	NPN	50	100	200	250	0.88	68	10	47	N24	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
DTC1D3R	NPN	50	100	200	250	3.7	20	2.7	1	K4B	SOT-23
DTC314T	NPN	50	600	200	200	0.88	100	10	∞	H04	SOT-23
DTC323T	NPN	50	600	200	200	7.2	100	2.2	∞	H02	SOT-23
DTC343T	NPN	50	600	200	200	0.88	100	4.7	∞	H03	SOT-23
DTC363T	NPN	50	600	200	200	1.8	100	6.8	∞	H07	SOT-23
DTD113E	NPN	50	500	200	250	7.2	30	1	1	F21	SOT-23
DTD113Z	NPN	50	500	200	250	7.2	56	1	10	G21	SOT-23
DTD114E	NPN	50	500	200	250	0.88	56	10	10	F24	SOT-23
DTD114G	NPN	50	500	200	250	7.2	56	0	10	L24	SOT-23
DTD114T	NPN	50	500	200	250	0.88	100	10	∞	E04	SOT-23
DTD122J	NPN	50	500	200	250	4.5	47	0.22	4.7	G4C	SOT-23
DTD123E	NPN	50	500	200	250	3.8	39	2.2	2.2	F22	SOT-23
DTD123T	NPN	50	500	200	250	7.2	100	2.2	∞	E02	SOT-23
DTD123Y	NPN	50	500	200	250	3.8	56	2.2	10	F62	SOT-23
DTD133H	NPN	50	500	200	250	2.4	56	3.3	10	G06	SOT-23
DTD143E	NPN	50	500	200	250	1.8	47	4.7	4.7	F23	SOT-23
DTD143T	NPN	50	500	200	250	0.88	100	4.7	∞	F13	SOT-23
DTD163T	NPN	50	500	200	250	1.8	100	6.8	∞	E07	SOT-23
MUN2111	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	30	10	10	6A	SOT-23
MUN2112	PNP	-50	-100	200	250	-0.38	56	22	22	6B	SOT-23
MUN2113	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	68	47	47	6C	SOT-23
MUN2114	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	68	10	47	6D	SOT-23
MUN2115	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	100	10	∞	6E	SOT-23
MUN2116	PNP	-50	-100	200	250	-7.2	100	4.7	∞	6F	SOT-23
MUN2130	PNP	-50	-100	200	250	-4.3	3	1	1	6G	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
MUN2131	PNP	-50	-100	200	250	-2.3	8	2.2	2.2	6H	SOT-23
MUN2132	PNP	-50	-100	200	250	-1.5	15	4.7	4.7	6J	SOT-23
MUN2133	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	80	4.7	47	6K	SOT-23
MUN2134	PNP	-50	-100	200	250	-0.13	80	22	47	6L	SOT-23
MUN2136	PNP	-50	-100	200	250	-0.15	82	100	100	6N	SOT-23
MUN2137	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	56	47	22	6P	SOT-23
MUN2140	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	100	47	∞	6T	SOT-23
MUN2211	NPN	50	100	200	250	0.5	35	10	10	8A	SOT-23
MUN2212	NPN	50	100	200	250	0.2	60	22	22	8B	SOT-23
MUN2213	NPN	50	100	200	250	0.1	80	47	47	8C	SOT-23
MUN2214	NPN	50	100	200	250	0.2	80	10	47	8D	SOT-23
MUN2215	NPN	50	100	200	250	0.9	160	10	∞	8E	SOT-23
MUN2216	NPN	50	100	200	250	1.9	160	4.7	∞	8F	SOT-23
MUN2230	NPN	50	100	200	250	4.3	5	1	1	8G	SOT-23
MUN2231	NPN	50	100	200	250	2.3	15	2.2	2.2	8H	SOT-23
MUN2232	NPN	50	100	200	250	1.5	30	4.7	4.7	8J	SOT-23
MUN2233	NPN	50	100	200	250	0.18	200	4.7	47	8K	SOT-23
MUN2234	NPN	50	100	200	250	0.13	150	22	47	8L	SOT-23
MUN2235	NPN	50	100	200	250	0.13	80	2.2	47	8M	SOT-23
MUN2238	NPN	50	100	200	250	4	160	2.2	∞	8R	SOT-23
MUN2241	NPN	50	100	200	250	0.1	160	100	∞	8U	SOT-23
KRA101S	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	30	4.7	4.7	PA	SOT-23
KRA102S	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	30	10	10	PB	SOT-23
KRA103S	PNP	-50	-100	200	250	-0.38	56	22	22	PC	SOT-23
KRA104S	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	68	47	47	PD	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
KRA105S	PNP	-50	-100	200	250	-3.6	80	2.2	47	PE	SOT-23
KRA106S	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	80	4.7	47	PF	SOT-23
KRA107S	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	68	10	47	PH	SOT-23
KRA108S	PNP	-50	-100	200	250	-0.36	68	22	47	PI	SOT-23
KRA109S	PNP	-50	-100	200	250	-0.18	56	47	22	PJ	SOT-23
KRA116S	PNP	-50	-100	200	250	-7.2	33	1	10	P2	SOT-23
KRA117S	PNP	-50	-100	200	250	-3.8	20	2.2	2.2	P4	SOT-23
KRA118S	PNP	-50	-100	200	250	-3.8	33	2.2	10	P5	SOT-23
KRA119S	PNP	-50	-100	200	250	-1.8	30	4.7	10	P6	SOT-23
KRA120S	PNP	-50	-100	200	250	-0.88	24	10	4.7	P7	SOT-23
KRA121S	PNP	-50	-100	200	250	-0.16	33	47	10	P8	SOT-23
KRA122S	PNP	-50	-100	200	250	-0.15	62	100	100	P9	SOT-23
KRA221S	PNP	-50	-500	200	250	-7.2	33	1	1	PQ	SOT-23
KRA222S	PNP	-50	-500	200	250	-3.8	39	2.2	2.2	PR	SOT-23
KRA223S	PNP	-50	-500	200	250	-1.8	47	4.7	4.7	PS	SOT-23
KRA224S	PNP	-50	-500	200	250	-0.88	56	10	10	PT	SOT-23
KRA225S	PNP	-50	-500	200	250	-7.2	56	1	10	PU	SOT-23
KRA226S	PNP	-50	-500	200	250	-3.6	56	2.2	10	PV	SOT-23
KRC101S	NPN	50	100	200	250	1.8	30	4.7	4.7	NA	SOT-23
KRC102S	NPN	50	100	200	250	0.88	50	10	10	NB	SOT-23
KRC103S	NPN	50	100	200	250	0.36	70	22	22	NC	SOT-23
KRC104S	NPN	50	100	200	250	0.18	80	47	47	ND	SOT-23
KRC105S	NPN	50	100	200	250	3.6	80	2.2	47	NE	SOT-23
KRC106S	NPN	50	100	200	250	1.8	80	4.7	47	NF	SOT-23
KRC107S	NPN	50	100	200	250	0.88	80	10	47	NH	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

数字晶体管

型号	极性	耐压	输出电流	耗散功率	特征频率	输入电流	增益	偏置电阻1	偏置电阻2	印字	封装
Type	Polarity	VCC(V)	IO(mA)	PD(mW)	fT(MHz)	II(mA)@V	G(min)@	R1(KΩ)	R2(KΩ)	Marking	Package
KRC108S	NPN	50	100	200	250	0.36	80	22	47	NI	SOT-23
KRC109S	NPN	50	100	200	250	0.16	70	47	22	NJ	SOT-23
KRC116S	NPN	50	100	200	250	7.2	33	1	10	N2	SOT-23
KRC117S	NPN	50	100	200	250	3.8	20	2.2	2.2	N4	SOT-23
KRC118S	NPN	50	100	200	250	3.8	33	2.2	10	N5	SOT-23
KRC119S	NPN	50	100	200	250	1.8	30	4.7	10	N6	SOT-23
KRC120S	NPN	50	100	200	250	0.88	24	10	4.7	N7	SOT-23
KRC121S	NPN	50	100	200	250	0.16	33	47	10	N8	SOT-23
KRC122S	NPN	50	100	200	250	0.15	62	100	100	N9	SOT-23
KRC231S	NPN	50	600	200	250	-	200	2.2	∞	NW	SOT-23
KRC232S	NPN	50	600	200	250	-	200	5.6	∞	NY	SOT-23
KRC233S	NPN	50	600	200	250	-	200	10	∞	NZ	SOT-23
KRC234S	NPN	50	600	200	250	-	200	4.7	∞	NNA	SOT-23
KRC235S	NPN	50	600	200	250	-	200	6.8	∞	NNB	SOT-23

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FSS2300S	2300	N	0.9	20	+/-10	4	0.78		40	55		220	SOT-23	沟槽	S2300S
FSS2300M	2300	N	1	20	+/-10	5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23	沟槽	S2300M
FS2300M	2300	N	1.25	20	+/-10	6.8	0.62		13.5	17	22	888	SOT-23	沟槽	2300
FS2300LM	2300	N	1.25	20	+/-10	6.8	0.62		13.5	17	22	888	SOT-23	沟槽	2300
FSS2301S	A1SHB..	P	0.7	-20	+/-10	-2.3	-0.62		90	128	185	327	SOT-23	沟槽	S2301S
FSS2301M	A1SHB.	P	0.7	-20	+/-10	-2.8	-0.6		86	115	165	327	SOT-23	沟槽	S2301M
FSS2301LM	A1SHB.	P	0.7	-15	+/-10	-2	-0.62		82	105	140	327	SOT-23	沟槽	S2301L
FS2301M	A1	P	0.7	-20	+/-12	-3	-0.7		58.6	74		325	SOT-23	沟槽	SI2301
FSS2302KM	22K	N	0.7	20	+/-12	2.8	0.75		60	80		120	SOT-23	沟槽ESD	DMG2302UK
FSS2302S	A2SHB.	N	0.7	20	+/-10	3	0.75		45	58		120	SOT-23	沟槽	S2302S
FSS2302M	A2SHB	N	0.7	20	+/-10	3.5	0.78		40	55		220	SOT-23	沟槽	S2302M
FSS2302AM	A2sHB	N	0.9	20	+/-10	3.8	0.8		28	36		340	SOT-23	沟槽	S2302AM
FS2302S	A2.	N	1	20	+/-10	5	0.9		23	30		260	SOT-23	沟槽	SI2302
FS2302M	A2	N	1.2	20	+/-10	4.3	0.7		22	30		260	SOT-23	沟槽	SI2302
FS2302AM	A2	N	1.2	20	+/-10	4.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23	沟槽	SI2302
FS2303M	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.6	77	125			200	SOT-23	沟槽	SI2303
FS2303AM	S3	P	1.1	-30	+/-20	-3	-1.5	56	79			365	SOT-23	沟槽	SI2303
FS2304M	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23	沟槽	SI2304
FSS2305M	A5SHB	P	1	-20	+/-10	-3.5	-0.62		49	59	79	438	SOT-23	沟槽	S2305
FSS2305AM	A5SHB	P	1.1	-20	+/-10	-4	-0.62		39	49	73	438	SOT-23	沟槽	S2305A
FS2305M	A5	P	1.2	-20	+/-10	-5.5	-0.62		29	35	45	1010	SOT-23	沟槽	SI2305
FS2305LM	A5	P	1.2	-15	+/-10	-5.6	-0.62		25	32	44	1010	SOT-23	沟槽	SI2333
FSS2306M	A6SHB	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23	沟槽	S2306

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS2306M	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23	沟槽	SI2306
FS2307M	S7	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23	沟槽	SI2307
FS2308M	S08	N	1	60	+/-20	2	1.5	140	160			105	SOT-23	沟槽	SI2308
FS2309M	S09	P	1.5	-60	+/-20	-1.6	-1.5	138	170			450	SOT-23	沟槽	SI2309
FS2310A	S10	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	86	92			410	SOT-23	沟槽	SI2310
FS2310M	S10	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	86	92			410	SOT-23	沟槽	SI2310
FS2310AM	S10	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	70	83			410	SOT-23	沟槽	SI2310
FS2311M	A5	P	1.2	-15	+/-10	-5.6	-0.62		25	32	44	1010	SOT-23	沟槽	SI2311
FS2312M	A12	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23	沟槽	SI2312
FS2314M	A12	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23	沟槽	SI2314
FS2315M	A5	P	1.2	-15	+/-10	-5.6	-0.62		25	32	44	1010	SOT-23	沟槽	SI2315
FS2316M	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23	沟槽	SI2316
FS2318M	2318	N	1.4	40	+/-20	4	1.5	43	58			340	SOT-23	沟槽	SI2318
FS2319M	2319	P	1.2	-40	+/-20	-3	-1.5	69	90			573	SOT-23	沟槽	SI2319
FS2321M	A5SHB	P	1	-20	+/-10	-3.4	-0.62		49	59	79	438	SOT-23	沟槽	SI2321
FS2324M	S24	N	1.3	100	+/-20	2	1.8	200	215			388	SOT-23	沟槽	SI2324
FS2328M	2328	N	1.3	100	+/-20	2	1.8	250	280			388	SOT-23	沟槽	SI2328
FS3400S	A09T.	N	0.9	30	+/-12	5	0.83	26	28	36		630	SOT-23	沟槽	AO3400
FS3400M	A09T	N	1.2	30	+/-12	5.6	0.9	21	25	33		630	SOT-23	沟槽	AO3400
FS3400LM	AOL	N	1.3	30	+/-12	5.8	0.65	20	23	27		630	SOT-23	沟槽	AO3400
FS3401S	A19T.	P	0.9	-30	+/-12	-4	-0.9	48	54	66		580	SOT-23	沟槽	AO3401
FS3401M	A19T	P	1.2	-30	+/-12	-4.4	-0.9	46	52	64		1040	SOT-23	沟槽	AO3401
FSS3402M	A29T.	N	0.8	30	+/-12	1.5	0.9	77	84	108		200	SOT-23	沟槽	S3402

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS3402S	R2	N	1	30	+/-12	2.5	0.9	35	38	50		390	SOT-23	沟槽	AO3402
FS3402M	A29T	N	1.2	30	+/-12	5.6	0.9	21	25	33		630	SOT-23	沟槽	AO3402
FS3403M	A3	P	1.2	-30	+/-12	-2.6	-0.9	88	103	139		260	SOT-23	沟槽	AO3403
FS3404M	A4	N	1.2	30	+/-20	5.8	1.5	23	27			560	SOT-23	沟槽	AO3404
FS3405M	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23	沟槽	AO3405
FS3406M	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23	沟槽	AO3406
FS3407M	A7	P	1.2	-30	+/-20	-4.1	-1.5	40	53			572	SOT-23	沟槽	AO3407
FS3409M	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23	沟槽	AO3409
FS3413M	AD	P	1	-20	+/-10	-3.4	-0.62		49	59	79	438	SOT-23	沟槽	AO3413
FS3414M	AE	N	1	20	+/-12	3	0.7		51	68		220	SOT-23	沟槽	AO3414
FS3415M	3415	P	1.3	-20	+/-12	-5.6	-0.62		30	36		1180	SOT-23	沟槽ESD	AO3415
FS3416M	AG	N	1.3	20	+/-10	6.5	0.62		16	18	34	890	SOT-23	沟槽ESD	AO3416
FS3418M	AK	N	1	30	+/-12	3.6	0.9	39	44	66		390	SOT-23	沟槽	AO3418
FS3419M	AL	P	1	-20	+/-12	-2.2	-0.6	71	85	112	168	380	SOT-23	沟槽ESD	AO3419
FS3420S	AN	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62	18	19.5	25	33	418	SOT-23	沟槽	AO3420
FS3420M	AN	N	1.4	20	+/-10	6.5	0.65	14	18	22		888	SOT-23	沟槽	AO3420
FS3421M	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23	沟槽	AO3421
FS3422M	AR	N	1.2	60	+/-12	3	1.3		80	150		410	SOT-23	沟槽	AO3422
FS3423M	AS	P	0.9	-20	+/-12	-2	-0.8	76	94	128		380	SOT-23	沟槽ESD	AO3423
FS3424M	AT	N	1	30	+/-12	3.6	0.9	39	44	66		390	SOT-23	沟槽	AO3424
FS3434M	Y4	N	1.4	30	+/-12	4	1	42	47	59		245	SOT-23	沟槽ESD	AO3434
FS3435M	B5	P	1	-20	+/-10	-3.3	-0.62		49	59	79	438	SOT-23	沟槽	AO3435
FS3134K	34KA	N	0.4	20	+/-12	0.5	0.75		220	290	420	33	SOT-23	沟槽ESD	3134KA

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
BSS84	PD9	P	0.23	-60	+/-20	-0.17	-1.4	3300	3500			43	SOT-23	沟槽	BSS84
BSS123	SA	N	0.35	100	+/-20	0.2	1.8	3000	3500			32	SOT-23	沟槽	BSS123
BSS123K	:SA	N	0.35	100	+/-20	0.17	1.9	3600	3800			38	SOT-23	沟槽ESD	BSS123K
BSS138	SS	N	0.35	50	+/-20	0.34	1.2	1100	1200			28.5	SOT-23	沟槽	BSS138
BSS138K	138K	N	0.35	50	+/-20	0.22	1.1	1000	1300			30	SOT-23	沟槽ESD	BSS138K
BSS138W	SS	N	0.3	50	+/-20	0.2	1	3500				30	SOT-323	沟槽	BSS138W
2N7002	7002	N	0.35	60	+/-20	0.34	1.5	1200	1300			27.5	SOT-23	沟槽	2N7002
2N7002K	72K	N	0.35	60	+/-20	0.34	1.4	1300	1400			21	SOT-23	沟槽ESD	2N7002K
2N7002KCQ	72KC.	N	0.3	60	+/-20	0.3	1.5	1900	2000			27	SOT-23	车规	2N7002KCQ
2SK3018	KN	N	0.83	30	+/-20	0.5	1.0	380	530			21	SOT-23	沟槽ESD	2SK3018
2SK3018W	KN	N	0.2	30	+/-20	0.5	1.3	8000	13000			13	SOT-323	沟槽ESD	2SK3018W
FS2015	2015	P	0.7	-20	+/-10	-2	-0.62		90	115	165	327	SOT-23	沟槽	WPM2015
FS2016	2016	N	0.7	20	+/-10	2.5	0.75		45	58	68	120	SOT-23	沟槽	WNM2016
FSS6402P	S6402	P	0.7	-20	+/-10	-2	-0.62		90	115	165	327	SOT-23	沟槽	S6402
FS6402P	6402P	P	1	-20	+/-10	-3.3	-0.62		49	59	79	438	SOT-23	沟槽	IRLML6402
FS3N10M	3N10	N	1.4	100	+/-20	3.3	1.65	90	120			210	SOT-23	屏蔽栅	3N10
FS5N10A	MA6	N	1.4	100	+/-20	3.3	1.6	86	113			210	SOT-23	屏蔽栅	5N10
FSS2300	2300	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23-3L	沟槽	S2300
FSS2301	A1SHB	P	0.7	-20	+/-10	-2	-0.62		90	115	165	327	SOT-23-3L	沟槽	S2301
FSS2301A	2301	P	0.7	-23	+/-12	-3	-0.7		65	81		325	SOT-23-3L	沟槽	AP2301
FS2301	A1	P	0.9	-20	+/-12	-3.5	-0.75		64	87		325	SOT-23-3L	沟槽	SI2301
FSS2302	A2SHB	N	0.9	20	+/-10	3.5	0.78		40	55		220	SOT-23-3L	沟槽	S2302
FSS2302A	2302	N	0.9	20	+/-12	3.6	0.7		39	52		220	SOT-23-3L	沟槽	S2302

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS2302	A2	N	1.2	20	+/-10	4.3	0.7		21	29		260	SOT-23-3L	沟槽	SI2302
FS2302A	A2	N	1.2	20	+/-10	5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23-3L	沟槽	SI2302
FS2303	S3	P	1.1	-30	+/-20	-3	-1.5	56	79			365	SOT-23-3L	沟槽	SI2303
FS2304	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23-3L	沟槽	SI2304
FSS2305	A5SHB	P	1	-20	+/-10	-3.5	-0.62		49	59	79	438	SOT-23-3L	沟槽	S2305
FS2305	A5	P	1.2	-20	+/-10	-5.5	-0.62		29	35	45	1010	SOT-23-3L	沟槽	SI2305
FS2305L	A5	P	1.2	-15	+/-10	-5.6	-0.62		25	32	44	1010	SOT-23-3L	沟槽	SI2333
FSS2306	A6SHB	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23-3L	沟槽	S2306
FS2306	S6	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23-3L	沟槽	SI2306
FS2307	S7	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23-3L	沟槽	SI2307
FS2308	S08	N	1	60	+/-20	2	1.5	140	160			105	SOT-23-3L	沟槽	SI2308
FS2309	S09	P	1.5	-60	+/-20	-1.6	-1.5	138	170			450	SOT-23-3L	沟槽	SI2309
FS2310	S10	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	86	92			410	SOT-23-3L	沟槽	SI2310
FS2311	A5	P	1.2	-15	+/-10	-5.6	-0.62		25	32	44	1010	SOT-23-3L	沟槽	SI2311
FS2312	A12	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23-3L	沟槽	SI2312
FS2314	A12	N	1.2	20	+/-10	5.5	0.62		19.5	25	33	418	SOT-23-3L	沟槽	SI2314
FS2315	A5	P	1.2	-15	+/-10	-5.6	-0.62		25	32	44	1010	SOT-23-3L	沟槽	SI2315
FS2316	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23-3L	沟槽	SI2316
FS2318	2318	N	1.4	40	+/-20	4	1.5	43	58			340	SOT-23-3L	沟槽	SI2318
FS2319	2319	P	1.2	-40	+/-20	-3	-1.5	69	90			573	SOT-23-3L	沟槽	SI2319
FS2321	A5SHB	P	1	-20	+/-10	-3.4	-0.62		49	59	79	438	SOT-23-3L	沟槽	SI2321
FS2324	S24	N	1.3	100	+/-20	2	1.8	200	215			388	SOT-23	沟槽	SI2324
FS2328	2328	N	1.3	100	+/-20	2	1.8	250	280			388	SOT-23	沟槽	SI2328

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FSS3400	3400	N	1	30	+/-12	4	1	40	43	53		630	SOT-23-3L	沟槽	S3400
FS3400	AOLA	N	1.4	30	+/-12	5.8	0.9	21	25	33		630	SOT-23-3L	沟槽	AO3400
FS3400A	XOFS**	N	1.4	30	+/-12	6.2	0.95	20	23	30		630	SOT-23-3L	沟槽	AO3400A
FSS3401	.A19T	P	0.9	-30	+/-12	-4.2	-0.9	48	54	66		580	SOT-23-3L	沟槽	S3401
FS3401	A1LA	P	1.2	-30	+/-12	-4.4	-0.9	46	52	64		1040	SOT-23-3L	沟槽	AO3401
FS3401A	X1FS**	P	1.2	-30	+/-12	-4.4	-0.9	46	52	64		1040	SOT-23-3L	沟槽	AO3401A
FS3402	A2LA	N	1.4	30	+/-12	5.8	0.9	21	25	33		630	SOT-23-3L	沟槽	AO3402
FS3403	A3	P	1.2	-30	+/-12	-2.6	-0.9	88	103	139		260	SOT-23-3L	沟槽	AO3403
FS3404	A4LA	N	1.2	30	+/-20	5.8	1.5	23	27			560	SOT-23-3L	沟槽	AO3404
FS3405	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23-3L	沟槽	AO3405
FS3406	S4	N	1	30	+/-20	3.6	1.5	26	39			315	SOT-23-3L	沟槽	AO3406
FS3407	X7XB**	P	1.2	-30	+/-20	-4.2	-1.5	40	53			572	SOT-23-3L	沟槽	AO3407
FS3409	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23-3L	沟槽	AO3409
FS3413	AD	P	1	-20	+/-10	-3.4	-0.62		49	59	79	438	SOT-23-3L	沟槽	AO3413
FS3415	AFHV**	P	1.3	-20	+/-12	-5.6	-0.62		31	41		1180	SOT-23-3L	沟槽ESD	AO3415
FS3416	AG	N	1.3	20	+/-10	6.5	0.62		16	18	34	890	SOT-23-3L	沟槽ESD	AO3416
FS3418	AK	N	1	30	+/-12	3.6	0.9	39	44	66		390	SOT-23-3L	沟槽	AO3418
FS3419	AL	P	1	-20	+/-12	-2.2	-0.6	71	85	112	168	380	SOT-23-3L	沟槽ESD	AO3419
FS3420	AN	N	1.5	20	+/-10	6.8	0.65	14	18	22		888	SOT-23-3L	沟槽	AO3420
FS3421	S3	P	1	-30	+/-20	-2.6	-1.9	77	125			200	SOT-23-3L	沟槽	AO3421
FS3422	AR	N	1.2	60	+/-12	3	1.3		80	150		410	SOT-23-3L	沟槽	AO3422
FS3423	AS	P	0.9	-20	+/-12	-2	-0.8	76	94	128		380	SOT-23-3L	沟槽ESD	AO3423
FS3424	AT	N	1	30	+/-12	3.6	0.9	39	44	66		390	SOT-23-3L	沟槽	AO3424

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS3434	Y4	N	1.4	30	+/-12	4	1	42	47	59		245	SOT-23-3L	沟槽ESD	AO3434
FS3435	3435	P	1	-20	+/-10	-3.4	-0.62		49	59	79	438	SOT-23-3L	沟槽	AO3435
FS3442	3442	N	1.3	100	+/-20	2	1.8	250	280			388	SOT-23-3L	沟槽	AO3442
FS3N06	3N06	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	68	80			410	SOT-23-3L	沟槽	3N06
FS6003	6003	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	68	80			410	SOT-23-3L	沟槽	6003
FS4N06	4N06	N	1.2	60	+/-20	4	1.6	45	55			730	SOT-23-3L	沟槽	4N06
FSS6005AN	6005	N	1.3	60	+/-20	4.5	1.6	33	40			979	SOT-23-6L	沟槽	6005
FS5N06	5N06	N	1.4	60	+/-20	5	1.6	30	38			1018	SOT-23-3L	沟槽	5N06
FS4N10	4N10	N	1.5	100	+/-20	4	1.65	88	118			210	SOT-23-3L	屏蔽栅	4N10
FS8N02	2208	N	1.5	20	+/-12	8	0.75		11	14		1100	SOT-23-3L	沟槽	8N02
FS6P02	2106	P	1.4	-20	+/-12	-6	-0.65		19	22		1100	SOT-23-3L	沟槽	6P02
FS6P03	6P03	P	2	-30	+/-20	-6	-1.5	28	38			920	SOT-23-3L	沟槽	6P03
FS7P03	3107	P	1.9	-30	+/-20	-7	-1.5	18	22			1500	SOT-23-3L	沟槽	7P03
FS5P04	4105	P	1.5	-40	+/-20	-5	-1.6	66	109			550	SOT-23-3L	沟槽	5P04
FS4P06	.4P06.	P	1.5	-60	+/-20	-4	-1.6	72	89			930	SOT-23-3L	沟槽	4P06
FS3N15	FS3N15	N	0.5	300	+/-20	0.5	3	2710	2770			110	SOT-23-3L	VDMOS	05N30
FS3429E	3429E	P	1.4	-20	+/-10	-8	-0.6		21	24	38		SOT-23-6L	沟槽ESD	SI3429E
FS3440	3440	N	1.1	150	+/-20	1.5	3	375					SOT-23-6L	沟槽	SI3440
FS3483	3483	P	1.2	-30	+/-20	-4.1	-1.5	40	53			572	SOT-23-6L	沟槽	SI3483
FSL3407	R7	P	1.2	-30	+/-20	-4.1	-1.5	40	53			572	SOT-23-6L	沟槽	L3407
FS3590	3590	N+P	1.3	30	+/-12	3	0.9	77	120				SOT-23-6L	互补	SI3590
			1	-30	+/-12	-2	-0.9	170	300						
FS6400	6400	N	1.2	30	+/-12	5.6	0.9	21	25	33		630	SOT-23-6L	沟槽	AO6400

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS6401	6401	P	1.2	-30	+/-12	-4.4	-0.9	46	52	64		1040	SOT-23-6L	沟槽	AO6401
FS6402	6402	N	1.2	30	+/-20	5.6	1.5	23	27			560	SOT-23-6L	沟槽	AO6402
FS6403	6403	P	1.2	-30	+/-20	-4.1	-1.5	40	53			572	SOT-23-6L	沟槽	AO6403
FS6404	6404	N	1.3	20	+/-10	6.5	0.62		16	18	34	890	SOT-23-6L	沟槽ESD	AO6404
FS6405	6405	P	1.2	-30	+/-20	-5	-1.7	30	46			660	SOT-23-6L	沟槽	AO6405
FS6415	6415	P	1.3	-20	+/-12	-5.6	-0.62		31	41		1180	SOT-23-6L	沟槽ESD	AO6415
FS6420	6420	N	1.2	60	+/-20	3	1.3	86	92			410	SOT-23-6L	沟槽	AO6420
FS6420A	6420	N	1.2	60	+/-20	3	1.35	62	70			410	SOT-23-6L	沟槽	AO6420A
FS6005AN	6005AN	N	2	60	+/-20	5	1.6	33	40			979	SOT-23-6L	沟槽	NCE6005AN
FSL4P06	.4P06	P	1.5	-60	+/-20	-4	-1.6	72	89			930	SOT-23-6L	沟槽	L4P06
FSL4N10	.4N10	N	1.5	100	+/-20	4	1.65	88	118			210	SOT-23-6L	屏蔽栅	4N10
FS6602	6602	N+P	1	30	+/-20	3.6	1.5	40	50			40	SOT-23-6L	互补	AO6602
			1.1	-30	+/-20	-3	-1.5	56	79			56			
FS6604	6604	N+P	1.1	20	+/-10	3	0.7		60	80		60	SOT-23-6L	互补	AO6604
			1	-20	+/-10	-2.3	-0.6		80	110		80			
FS6604B	6604B	2N+2P	0.7	20	+/-10	3	0.78		40	55		40	SOT-23-6L	半桥	NP6604
			0.7	-20	+/-10	-2	-0.62		90	115		90			
FS6608	6608	N+P	1.3	30	+/-12	3.4	0.9	60	70	90			SOT-23-6L	互补	AO6608
			1.2	-20	+/-10	-3.3	-0.7		75	105	135				
FS6800	6800	N+N	1.2	30	+/-12	3.4	1	46	53	65		235	SOT-23-6L	双沟槽	AO6800
FSL2301	S1	P+P	0.4	-20	+/-10	-2.3	-0.7		58	80	120	385	SOT-23-6L	双沟槽	L2301
FSL2301A	S1A	P+P	1.2	-20	+/-10	-3.7	-0.7		42	55	86	438	SOT-23-6L	双沟槽	L2301A
FS6801	6801	P+P	1	-30	+/-20	-3	-1.6	77	125			200	SOT-23-6L	双沟槽	AO6801

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS6802	6802	N+N	1	30	+/-20	3.6	1.5	40	50			314	SOT-23-6L	双沟槽	AO6802
FS6808	6808	N+N	1.2	20	+/-10	6	0.62		23	30		418	SOT-23-6L	双沟槽	AO6808
FSS8205	8205	N+N	0.7	20	+/-10	3	0.7		51	73		120	SOT-23-6L	共漏双	S8205
FS8205	8205	N+N	1.5	20	+/-12	5	0.65		28	36		340	SOT-23-6L	共漏双	8205
FS8205A	8205A	N+N	1.5	20	+/-12	6	0.78		19	25	38	418	SOT-23-6L	共漏双	8205A
FS2007N	2007N	N+N	1.5	20	+/-12	6.5	0.65		16	20		418	SOT-23-6L	共漏双	8205D
FS8810	8810	N+N	1.5	20	+/-12	7	0.65		12	16	22	1300	SOT-23-6L	双ESD	AO8810
DMN2400UV	TV	N+N	0.3	20	+/-8	0.8	0.6		200	235	295	38	SOT-563	双ESD	DMN2400UV
FS4264	4264	N	3.5	60	+/-20	10	1.9	15	18			1370	SOP-8	沟槽	AO4264
FS4402A	4402	N	2.5	20	+/-12	25	0.75		3.5	4.2		5300	SOP-8	沟槽	AO4402
FS4406	4406	N	3	30	+/-20	15	1.9	11	14			2470	SOP-8	沟槽	AO4406
FS4406A	4406A	N	3	30	+/-20	15	1.9	8.5	14			2470	SOP-8	沟槽	AO4406A
FS4407	4407	P	3	-30	+/-20	-13	-1.4	12	15			3050	SOP-8	沟槽	AO4407
FS4407A	4407A	P	3	-30	+/-20	-13	-1.4	9	13			3050	SOP-8	沟槽	AO4407A
FS4409	4409	P	3	-30	+/-20	-14	-1.3	8.5	10			3887	SOP-8	沟槽	AO4409
FS4410	4410	N	3	30	+/-12	18	1.2	4.5	6			9720	SOP-8	沟槽	AO4410
FS4410E	4410E	N	1.4	30	+/-20	7.5	2	18	20				SOP-8	沟槽ESD	AO4410E
FS4419	4419	P	3	-30	+/-20	-9.7	-1.2	20	23			1573	SOP-8	沟槽	AO4419
FS4425	4425	P	1.5	-30	+/-20	-8.8	-2	17	23				SOP-8	沟槽	AO4425
FS4430	4430	N	3	30	+/-20	20	1.8	4.5	6			9500	SOP-8	沟槽	AO4430
FS4435	4435	P	2	-30	+/-20	-10	-1.8	18	22			1350	SOP-8	沟槽	AO4435
FS4436	4436	N	2.5	60	+/-20	7.6	2	40	46				SOP-8	沟槽	AO4436
FS4446A	4446A	N	3	30	+/-20	15	1.5	6.5	10			2450	SOP-8	沟槽	AO4446A

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS4447	4447	P	2	-30	+/-20	-16	-1.4	7.5	9.5			3050	SOP-8	沟槽	AO4447
FS4447A	4447A	P	2	-30	+/-20	-17	-1.4	6.8	9.5			3050	SOP-8	沟槽	AO4447A
FS4459	4459	P	2.5	-30	+/-20	-6.5	-1.6	38	56			980	SOP-8	沟槽	AO4459
FS4468	4468	N	2.8	30	+/-20	10	1.5	16	20			770	SOP-8	沟槽	AO4468
FS4480	4480	N	2.1	40	+/-20	12.5	1.8	8.5	11			1125	SOP-8	沟槽	AO4480
FS4484	4484	N	2.1	40	+/-20	12.5	1.8	8.5	10			1125	SOP-8	沟槽	AO4484
FS4485	4485	P	3.1	-40	+/-25	-11	-1.9	13	18			1500	SOP-8	沟槽	AO4485
FS4559	4559	N+P	1	60	+/-20	4.5	1.7	37	42			450	SOP-8	互补	SI4559
			1	-60	+/-20	-3.2	-1.8	70	93			930			
FS4606	4606	N+P	2	30	+/-20	7.7	1.5	19	24.8			373	SOP-8	互补	AO4606
			2	-30	+/-20	-5.3	-1.5	36	48			760			
FS4612	4612	N+P	2	60	+/-20	4.5	1.3	33	42			450	SOP-8	互补	AO4612
			2	-60	+/-20	-3.2	-1.65	75	85			930			
FS4614S	4614S	N+P	2	40	+/-20	6.5	1.5	25	30			815	SOP-8	互补	AO4614
			2	-40	+/-20	-5.5	-1.65	72	92			668			
FS4614	4614	N+P	2	40	+/-20	7.5	1.5	21	25			815	SOP-8	互补	AO4614
			2	-40	+/-20	-5.5	-1.65	33	43			668			
FS4616	4616	N+P	2	30	+/-20	7.7	1.8	17	24.8			373	SOP-8	互补	AO4616
			2	-30	+/-20	-7	-1.5	15	25			1040	SOP-8		
FS4620	4620	N+P	1.7	30	+/-20	8	2	23	42				SOP-8	互补	AO4620
			1.4	-30	+/-20	-6.5	-2	38	45				SOP-8		
FS4800	4800	N+N	1.7	30	+/-12	8	0.9	23	27	35		580	SOP-8	双沟槽	AO4800
FS4803	4803	P+P	1.2	-30	+/-20	-4.9	-1.5	36	50			625	SOP-8	双沟槽	AO4803

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS4805	4805	P+P	2.5	-30	+/-20	-8.9	-1.8	15	22			1004	SOP-8	双沟槽	AO4805
FS4805A	4805A	P+P	2.5	-30	+/-20	-8.9	-1.8	15	22			1004	SOP-8	双沟槽	AO4805
FS4812	4812	N	1.8	30	+/-20	6.5	1.5	25	35				SOP-8	沟槽	AO4812
FS4813	4813	P	1.8	-30	+/-20	-6.5	-2.4	25	45				SOP-8	沟槽	AO4813
FS4822	4822	N+N	1.7	30	+/-20	8	1.5	17	23			580	SOP-8	双沟槽	AO4822
FS4828	4828	N+N	2	60	+/-20	8	1.8	30	37			520	SOP-8	双沟槽	AO4828
FS4832	4832	N+N	2	30	+/-20	8.3	1.5	12	15			750	SOP-8	双沟槽	AO4832
FS4842	4842	N+N	1.7	30	+/-20	8	1.5	18	23			580	SOP-8	双沟槽	AO4842
FS4884	4884	N	2.2	40	+/-20	5	1.3	18	23				SOP-8	沟槽	AO4884
FS4946	4946	N+N	2.4	60	+/-20	5.3	2.4	38	43			840	SOP-8	沟槽	AO4946
FS4953	4953	P+P	1.2	-30	+/-20	-4.9	-1.5	36	50			625	SOP-8	双沟槽	AO4953
FS9435	9435	P	2.5	-30	+/-20	-5.1	-1.5	43	59			719	SOP-8	沟槽	AO9435
FS9926	9926	N+N	1.5	20	+/-12	6	0.7		22	30		850	SOP-8	双沟槽	AO9926
FS40N10	40N10	N	3	100	+/-20	10	2	15	20			980	SOP-8	沟槽	40N10
FS8205A	8205	N+N	1.5	20	+/-12	6.5	0.65		16	20		418	TSSOP-8	双沟槽	8205
FS8804	8804	N+N	1.5	20	+/-12	7	0.65		12	16	22	1300	TSSOP-8	双ESD	AO8804
FS8810	8810	N+N	1.5	20	+/-10	7	0.75		12.5	16	22	1300	TSSOP-8	双ESD	AO8810
FS8814	8814	N+N	1.5	20	+/-10	7	0.75		12.5	16	22	1300	TSSOP-8	双ESD	AO8814
FS8816L	8816	N+N	1.5	20	+/-10	7	0.75		12.5	16	18	1300	TSSOP-8	双沟槽	8816
FS8816	8816	N+N	1.5	30	+/-20	8	0.75		12	17		1130	TSSOP-8	双沟槽	AO8816
FS8820	8820	N+N	1.5	20	+/-12	7	0.75		12.5	16	22	1300	TSSOP-8	双ESD	AO8820
FS8822	8822	N+N	1.5	20	+/-10	7	0.75		12.5	16	22	1300	TSSOP-8	双ESD	AO8822
FSN130G04	130G04	N	6.25/114	40	+/-20	20/130	1.8	1.1	1.7			8300	DFN5X6	沟槽	130N04

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FSN40N03A	40N03A	N	5/21	30	+/-20	40	1.5	5.5	9.5			1015	DFN5X6	沟槽	40N03
FSN50N03A	50N03A	N	45	30	+/-20	50	1.5	3.9	5			2504	DFN5X6	沟槽	50N03
FSN2315	2135	P	2.3 /29.8	-30	+/-20	-20 /-50	-1.8	6	8.5			2830	DFN5X6	沟槽	AONS21357
FSN50P04	50P04	P	2.08/ 59.5	-40	+/-20	-16.5/ -50	-1.5	10	15			2960	DFN5X6	沟槽	50P04
FSN70P04	70P04	P	2.08/ 59.5	-40	+/-20	-20/ -70	-1.5	8.5	10			3125	DFN5X6	沟槽	70P04
FSN80P04	80P04	P	2.08/ 59.5	-40	+/-20	-20/ -80	-1.5	6.8	9			5500	DFN5X6	沟槽	80P04
FSN78N10G	78N10	N	4.2 /57	100	+/-20	17/78	1.9	7.2	9.5			2455	DFN5X6	屏蔽栅	78N10
FSN7400	7400	N	24	30	+/-20	40	1.8	7	9			740	DFN3X3	沟槽	AON7400A
FSN7401	7401	P	33	-30	+/-20	-39	-1.8	11	18			1380	DFN3X3	沟槽	AON7401
FSN7403	7403	P	3.1 /30	-30	+/-20	-16/ -32	-1.5	15	24			1000	DFN3X3	沟槽	AON7403
FSN7405	7405	P	3.1 /30	-30	+/-20	-16/ -50	-1.5	6	11			2300	DFN3X3	沟槽	AON7405
FSN7409	7409	P	3.1 /30	-30	+/-20	-15/ -44	-1.5	9	15			2147	DFN3X3	沟槽	AON7409
FSN7410	7410	N	1.56/ 17.8	30	+/-20	8/23	1.8	16	21			415	DFN3X3	沟槽	AON7410
FSN7534	7534	N	1.7 /27	30	+/-20	12/44	1.7	4.5	6.9			750	DFN3X3	沟槽	AON7534
FSN30P06AJ	30P06AJ	P	2/ 69	-60	+/-20	-6/ -30	-2	18	24			4300	DFN3X3	沟槽	30P06
FSN50N03	50N03	N	30	30	+/-20	50	1.8	8	10			2504	DFN3X3	沟槽	50N03
FSN60N03	60N03	N	37	30	+/-20	60	1.8	7	10			2300	DFN3X3	沟槽	60N03
FSN80N03	80N03	N	50	30	+/-20	80	1.8	4	6				DFN3X3	沟槽	80N03
FSN35N04	35N04	N	4.1 /40	40	+/-20	35	1.5	6.5	8.7			1860	DFN3X3	沟槽	35N04
FSN50N04	50N04	N	2.5 /50	40	+/-20	50	1.5	3.3	4.5			4150	DFN3X3	沟槽	50N04
FS5N06F	5N06	N	2	60	+/-20	5	1.3	70	83			410	SOT-89	沟槽	5N06
FS8N06F	8N06	N	3	60	+/-20	8	1.6	30	38			1018	SOT-89	沟槽	8N06
FS7P06F	7P06	P	3	-60	+/-20	-7	-1.5	55	65			1108	SOT-89	沟槽	7P06

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS5N10F	5N10	N	2	100	+/-20	5	1.65	86	113			210	SOT-89	沟槽	5N10
FS40N06F	40N06	N	25	60	+/-20	40	1.5	13	16.5				SOT-89	沟槽	40N06
FS10N03	10N03	N	18	30	+/-20	10	2	28	42				TO-251	沟槽	10N03
FS10P03	10P03	P	18	-30	+/-20	-10	-2	60	90				TO-251	沟槽	10P03
FS12N08	12N08	N	30	80	+/-20	12	2.2	22					TO-251	屏蔽栅	12N08
FS15N10	15N10	N	50	100	+/-20	15	2	20	30			765	TO-251	屏蔽栅	15N10
FS15P06	15P06	P	40	-60	+/-20	15	2	30	40				TO-251	沟槽	15P06
FS1N60	1N60	N	40	600	+/-30	1.2	3	11500					TO-251	VDMOS	1N60
FS20N06	20N06	N	30	60	+/-20	20	2	45				1018	TO-251	沟槽	20N06
FS20N20	20N20	N	150	200	+/-30	20	3	80					TO-251	屏蔽栅	20N20
FS20P03	20P03	P	30	-30	+/-20	-20	-2	33	40				TO-251	沟槽	20P03
FS2N20	2N20	N	10	200	+/-30	2	2	1900					TO-251	VDMOS	2N20
FS2N60	2N60	N	20	600	+/-30	2	3	4800					TO-251	VDMOS	2N60
FS2N65	2N65	N	20	650	+/-30	2	3	5000					TO-251	VDMOS	2N65
FS30N04	30N04	N	30	40	+/-20	30	2	20	30				TO-251	沟槽	30N04
FS30N06	30N06	N	38	60	+/-20	30	2	24	30				TO-251	沟槽	30N06
FS40N04	40N04	N	38	40	+/-20	40	2	12	15				TO-251	沟槽	40N04
FS40N06	40N06	N	46	60	+/-20	40	2	18	23				TO-251	沟槽	40N06
FS40P10	40P10	P	50	-100	+/-20	-40	-2	40	48				TO-251	屏蔽栅	40P10
FS407	407	P	50	-60	+/-20	-12	2	115	150			530	TO-251	沟槽	AO407
FS444	444	N	20	60	+/-20	12	2	60	85				TO-251	沟槽	AO444
FS446	446	N	20	75	+/-20	10	2	140	165				TO-251	沟槽	AO446
FS450	450	N	25	200	+/-30	3.8	3	700					TO-251	VDMOS	AO450

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FS474	474	N	20	75	+/-20	10	2.4	130	155				TO-251	沟槽	AO474
FS474A	474A	N	20	75	+/-16	10	1.6	130	155				TO-251	沟槽	AO474A
FS474B	474B	N	20	75	+/-20	10	2.3	132	155				TO-251	沟槽	AO474B
FS480	480	N	21	30	+/-20	25	2	23	33			1350	TO-251	沟槽	AO480
FS4N60	4N60	N	50	600	+/-30	4	3	2500					TO-251	VDMOS	4N60
FS4N65	4N65	N	75	650	+/-30	4	3	2600					TO-251	VDMOS	4N65
FS50P03	50P03	P	50	-30	+/-20	-50	-2	18	30			2886	TO-251	沟槽	50P03
FS50P06	50P06	P	60	-60	+/-20	-50	-2	15	20				TO-251	沟槽	50P06
FS50P06A	50P06A	P	75	-60	+/-25	-50	-3	28					TO-251	沟槽	50P06A
FS50N06	50N06	N	45	60	+/-20	50	1.5	17	25				TO-251	沟槽	50N06
FS50N06A	50N06A	N	54	60	+/-20	50	1.5	11	13.5			2585	TO-251	沟槽	50N06A
FS630	630	N	75	200	+/-30	9	2	300					TO-251	VDMOS	UTC630
FS730	730	N	75	400	+/-30	5.5	2	1000					TO-251	VDMOS	UTC730
FS65R900	65R900	N	100	650	+/-30	10	3	900					TO-251	超结	
FS65R600	65R600	N	150	650	+/-30	15	3	600					TO-251	超结	
FSD60N02	60N02	N	57	20	+/-12	60	0.7	4.3	7.4			2500	TO-252	沟槽	60N02
FSD10N03	10N03	N	18	30	+/-20	10	2	28	42				TO-252	沟槽	10N03
FSD12N08	12N08	N	30	80	+/-20	12	2.2	22					TO-252	屏蔽栅	12N08
FSD15N10	15N10	N	2/30	100	+/-20	3/15	1.5	85	96			765	TO-252	屏蔽栅	15N10
FSD15P06	15P06	P	40	-60	+/-20	-15	2	30	40				TO-252	沟槽	15P06
FSD1N60	1N60	N	40	600	+/-30	1.2	3	11500					TO-252	VDMOS	1N60
FSD20N06A	20N06A	N	28	60	+/-20	20	1.5	34	36			1018	TO-252	沟槽	20N06
FSD20N20	20N20	N	150	200	+/-30	20	3	80					TO-252	屏蔽栅	20N20

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(m				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FSD20P03	20P03	P	18	-30	+/-20	-20	-2	60	90				TO-252	沟槽	20P03
FSD30P03	30P03	P	2.5/50	-30	+/-20	-20/-35	-1.8	33	52			920	TO-252	沟槽	30P03
FSD2N20	2N20	N	10	200	+/-30	2	2	1900					TO-252	VDMOS	2N20
FSD2N60	2N60	N	20	600	+/-30	2	3	4800					TO-252	VDMOS	2N60
FSD2N65	2N65	N	20	650	+/-30	2	3	5000					TO-252	VDMOS	2N65
FSD30N04	30N04	N	30	40	+/-20	30	2	20	30				TO-252	沟槽	30N04
FSD30N06	30N06	N	38	60	+/-20	30	2	24	30				TO-252	沟槽	30N06
FSD40N04	40N04	N	38	40	+/-20	40	2	12	15				TO-252	沟槽	40N04
FSD40N06	40N06	N	46	60	+/-20	40	2	18	23				TO-252	沟槽	40N06
FSD40N10	40N10	N	50	100	+/-20	40	2	38	46				TO-252	屏蔽栅	40N10
FSD40P10	40P10	P	50	-100	+/-20	-40	-2	40	48				TO-252	屏蔽栅	40P10
FSD90N03A	90N03A	N	83	30	+/-20	90	1.6	3.6	4.8			2240	TO-252	沟槽	90N03
FSD120N04A	120N04A	N	108	40	+/-20	120	1.6	3.3	5.4			5595	TO-252	沟槽	120N04
FSD150N04	150N04	N	157	40	+/-20	150	1.9	2.5	3.1			5595	TO-252	沟槽	150N04
FSD403	403	P	2.5/90	-30	+/-25	-20/-70	-2	6	5(@-20V)			3000	TO-252	沟槽	AOD403
FSD407	407	P	6/45	-60	+/-25	-5.8/-15	-2	73	93			530	TO-252	沟槽	AOD407
FSD409	409	P	8/60	-60	+/-20	-16/-27	-1.8	30	40			1280	TO-252	沟槽	AOD409
FSD417	417	P	2.5/50	-30	+/-20	-20/-35	-1.8	33	52			920	TO-252	沟槽	AOD417
FSD444	444	N	20	60	+/-20	12	2	60	85				TO-252	沟槽	AOD444
FSD446	446	N	20	75	+/-20	10	2	140	165				TO-252	沟槽	AOD446
FSD450	450	N	25	200	+/-30	3.8	3	700					TO-252	VDMOS	AOD450
FSD474	474	N	20	75	+/-20	10	2.4	130	155				TO-252	沟槽	AOD474
FSD474A	474A	N	20	75	+/-16	10	1.6	130	155				TO-252	沟槽	AOD474A

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

MOS场效应管

型号	印字	极性	功率	漏源耐压	栅源耐压	漏极电流	开启电压	源导通电阻Rdson@Vgs(mΩ				输入电容	封装	特点	代替型号
Type	Marking	N/P	P_D(W)	BVdss(V)	Vgs(V)	I_D(A)	Vth(V)	10V	4.5V	2.5V	1.8V	Ciss(pF)	Package	Feature	Ins Type
FSD474B	474B	N	20	75	+/-20	10	2.3	132	155				TO-252	沟槽	AOD474B
FSD480	480	N	3.6/52	30	+/-20	20/42	1.8	18	26			1350	TO-252	沟槽	AOD480
FSD4132	4132	N	3.6/52	30	+/-20	30/85	1.5	2.7	3.5			4886	TO-252	沟槽	AOD4132
FSD20N03	20N03	N	3.6/52	30	+/-20	20/42	1.8	18	26			1350	TO-252	沟槽	20N03
FSD4185	4185	P	6.3/50	-40	+/-20	-15/-44	-1.9	11	14			1500	TO-252	沟槽	AOD4185
FSD4N60	4N60	N	35	600	+/-30	4	3	2000					TO-252	VDMOS	4N60
FSD4N65	4N65	N	33	650	+/-30	4	3	2000				520	TO-252	VDMOS	4N65
FSD50P03	50P03	P	2.5/70	-30	+/-20	-20/-50	-1.8	12	15			2886	TO-252	沟槽	50P03
FSD60P03	60P03	P	2.5/90	-30	+/-20	-25/-60	-1.8	8.3	13			3186	TO-252	沟槽	60P03
FSD80P03	80P03	P	31	-30	+/-20	-80	-1.6	6	9			4320	TO-252	沟槽	80P03
FSD50P06	50P06	P	60	-60	+/-20	-50	-2	15	20				TO-252	沟槽	50P06
FSD50P06A	50P06A	P	75	-60	+/-25	-50	-3	28					TO-252	沟槽	50P06A
FSD50N06	50N06	N	54	60	+/-20	50	1.5	11	13.5				TO-252	沟槽	50N06
FSD50N06A	50N06A	N	45	60	+/-20	50	1.5	17	25			2585	TO-252	沟槽	50N06A
FSD630	630	N	75	200	+/-30	9	2	300					TO-252	VDMOS	UTC630
FSD730	730	N	75	400	+/-30	5.5	2	1000					TO-252	VDMOS	UTC730
FSD65R900	65R900	N	100	650	+/-30	10	3	900					TO-252	超结	
FSD65R600	65R600	N	150	650	+/-30	15	3	600					TO-252	超结	

开关二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
1N4148W	T4	1	350	150	100	1.25	1	SOD-123	单芯
1N4148WS	T4	1	200	150	100	1.25	1	SOD-323	单芯
1N4148WT	T4	1	150	125	100	1.25	1	SOD-523	单芯
1N4448W	W1	4	400	150	100	1.25	2.5	SOD-123	单芯
1N4448WS	T4	0.5	200	150	100	1.25	2.5	SOD-323	单芯
1N4448WT	A	0.5	150	125	100	1.25	1	SOD-523	单芯
LL4148	\\		200	150	75	1.25	1	LL-34	单芯
LL4448	\\		200	250	75	1.25	2.5	LL-34	单芯
1SS181	A3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	共阳
1SS184	B3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	共阴
1SS187	D3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	反左单芯
1SS190	E3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	反右单芯
1SS193	F3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	单芯
1SS196	G3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	反右单芯
1SS226	C3	0.3	150	100	80	1.2	0.5	SOT-23	串联
1SS355	A	0.225	200	100	80	1.2	0.1	SOD-323	单芯
BAS16	A6	0.3	225	200	75	1.25	2.5	SOT-23	单芯
BAL99	JF	0.3	225	200	75	1.25	2.5	SOT-23	反右单芯
BAS16X	A6	0.5	150	200	75	1.25	1	SOD-523	单芯
BAS19	JP	0.625	250	200	100	1.25	0.1	SOT-23	单芯
BAS20	JR	0.625	250	200	200	1.25	0.1	SOT-23	单芯
BAS21	JS	0.625	225	200	250	1.25	0.1	SOT-23	单芯
BAS21A	JS2	0.625	225	200	250	1.25	0.1	SOT-23	共阳
BAS21C	JS3	0.625	225	200	250	1.25	0.1	SOT-23	共阴
BAS21S	JS4	0.625	225	200	250	1.25	0.1	SOT-23	串联

开关二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
BAS316	A6	0.5	250	250	100	1.25	1	SOD-323	单芯
BAS16H	A6	1.5	200	250	100	1.25	1	SOD-323	单芯
BAV16W	T6	1	400	150	75	1.25	1	SOD-123	单芯
BAV16WS	T6	1	200	150	75	1.25	1	SOD-323	单芯
BAV19W	A8	1	500	200	100	1.25	0.1	SOD-123	单芯
BAV19WS	A8	1	250	200	100	1.25	0.1	SOD-323	单芯
BAV20W	T2	1	500	200	150	1.25	0.1	SOD-123	单芯
BAV20WS	T2	1	250	200	150	1.25	0.1	SOD-323	单芯
BAV21W	T3	1	500	200	200	1.25	0.1	SOD-123	单芯
BAV21WS	T3	1	250	200	200	1.25	0.1	SOD-323	单芯
BAV23A	KT7	0.625	350	225	250	1.25	0.1	SOT-23	共阳
BAV23C	KT6	0.625	350	225	250	1.25	0.1	SOT-23	共阴
BAV23S	KL31	0.625	350	225	250	1.25	0.1	SOT-23	串联
BAV3004A	KAD	4	350	225	300	1.25	0.1	SOT-23	共阳
BAV3004C	KAC	4	350	225	300	1.25	0.1	SOT-23	共阴
BAV3004S	KAE	4	350	225	300	1.25	0.1	SOT-23	串联
BAV70	A4	0.3	225	200	70	1.25	2.5	SOT-23	共阴
BAV99	A7	0.3	225	200	70	1.25	2.5	SOT-23	串联
BAW56	A1	0.3	225	200	70	1.25	2.5	SOT-23	共阳
MMBD914	5D	0.3	225	200	100	1	5	SOT-23	单芯
MMBD4148	KA2	0.3	350	150	75	1.25	2.5	SOT-23	单芯
MMBD4148A	5H	0.3	350	200	100	1	5	SOT-23	单芯
MMBD4148CA	D6	0.3	350	200	100	1	5	SOT-23	共阳
MMBD4148CC	D5	0.3	350	200	100	1	5	SOT-23	共阴
MMBD4148SE	D4	0.3	350	200	100	1	5	SOT-23	串联

开关二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
MMBD4448	KA3	0.5	350	250	75	1.25	2.5	SOT-23	单芯
BAV74	JA	2	225	200	50	1	0.1	SOT-23	共阴
MMBD7000	M5C	0.3	225	200	100	1.1	3	SOT-23	串联
DB3W	DB3	2	150	100	32		10	SOD-123	触发管
DB4W	DB4	2	150	100	40		10	SOD-123	触发管
DB6W	DB6	2	150	100	60		10	SOD-123	触发管
LLDB3	\\	2	150	100	32		10	LL-34	触发管
LLDB4	\\	2	150	100	40		10	LL-34	触发管
LLDB6	\\	2	150	100	60		10	LL-34	触发管

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84B2V4	2Z11	2.4	2.35	2.45	5	80	325	1	50	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B2V7	2Z12	2.7	2.64	2.76	5	80	325	1	20	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B3V0	2Z13	3	2.94	3.06	5	80	325	1	10	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B3V3	2Z14	3.3	3.23	3.37	5	85	350	1	5	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B3V6	2Z15	3.6	3.52	3.68	5	85	375	1	5	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B3V9	2Z16	3.9	3.82	3.98	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B4V3	2Z17	4.3	4.21	4.39	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B4V7	2Z1	4.7	4.6	4.8	5	80	410	1	3	2	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B5V1	2Z2	5.1	4.99	5.2	5	50	425	1	2	2	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B5V6	2Z3	5.6	5.49	5.71	5	40	400	1	1	2	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B6V2	2Z4	6.2	6.07	6.32	5	15	80	1	3	4	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B6V8	2Z5	6.8	6.66	6.94	5	6	40	1	2	4	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B7V5	2Z6	7.5	7.35	7.65	5	6	30	1	1	5	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B8V2	2Z7	8.2	8.04	8.36	5	6	30	1	0.7	5	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B9V1	2Z8	9.1	8.92	9.28	5	6	40	1	0.5	6	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B10	2Z9	10	9.8	10.2	5	6	40	1	0.2	7	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B11	2Y1	11	10.8	11.2	5	8	50	1	0.1	8	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B12	2Y2	12	11.8	12.2	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B13	2Y3	13	12.7	13.3	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B15	2Y4	15	14.7	15.3	5	10	50	1	0.05	10.5	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B16	2Y5	16	15.7	16.3	5	10	50	1	0.05	11.2	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B18	2Y6	18	17.6	18.4	5	10	50	1	0.05	12.6	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B20	2Y7	20	19.6	20.4	5	10	50	1	0.05	14	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B22	2Y8	22	21.6	22.5	5	15	60	1	0.05	15.4	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B24	2Y9	24	23.5	24.5	5	20	60	1	0.05	16.8	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B27	2Y10	27	26.4	27.6	2	25	65	0.5	0.05	18.9	300	SOT-23	2%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84B30	2Y11	30	29.4	30.6	2	30	70	0.5	0.05	21	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B33	2Y12	33	32.3	33.7	2	35	75	0.5	0.05	23.1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B36	2Y13	36	35.2	36.8	2	35	80	0.5	0.05	25.2	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B39	2Y14	39	38.2	39.8	2	40	80	0.5	0.05	27.3	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B43	2Y15	43	42.1	43.9	2	45	85	0.5	0.05	30.1	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B47	2Y16	47	46	48	2	50	85	0.5	0.05	32.9	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B51	2Y17	51	49.9	52.1	2	60	95	0.5	0.05	35.7	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B56	2Y18	56	54.8	57.2	2	75	110	0.5	0.05	39.2	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B62	2Y19	62	60.7	63.3	2	90	130	0.5	0.05	43.4	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B68	2Y20	68	66.6	69.4	2	110	160	0.5	0.05	47.6	300	SOT-23	2%单芯
BZX84B75	2Y21	75	73.5	76.5	2	150	200	0.5	0.05	52.5	300	SOT-23	2%单芯
MMBZ5221B	18A	2.4	2.28	2.52	20	30	1200	0.25	100	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5222B	18B	2.5	2.38	2.63	20	30	1250	0.25	100	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5223B	18C	2.7	2.57	2.84	20	30	1300	0.25	75	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5224B	18D	2.8	2.66	2.94	20	30	1400	0.25	75	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5225B	18E	3	2.85	3.15	20	30	1600	0.25	50	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5226B	8A	3.3	3.14	3.47	20	28	1600	0.25	25	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5227B	8B	3.6	3.42	3.78	20	24	1700	0.25	15	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5228B	8C	3.9	3.71	4.1	20	23	1900	0.25	10	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5229B	8D	4.3	4.09	4.52	20	22	2000	0.25	5	1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5230B	8E	4.7	4.47	4.94	20	19	1900	0.25	5	2	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5231B	8F	5.1	4.85	5.36	20	17	1600	0.25	5	2	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5232B	8G	5.6	5.32	5.88	20	11	1600	0.25	5	3	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5233B	8H	6	5.7	6.3	20	7	1600	0.25	5	3.5	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5234B	8J	6.2	5.89	6.51	20	7	1000	0.25	5	4	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5235B	8K	6.8	6.46	7.14	20	5	750	0.25	3	5	350	SOT-23	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MMBZ5236B	8L	7.5	7.13	7.88	20	6	500	0.25	3	6	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5237B	8M	8.2	7.79	8.61	20	8	500	0.25	3	6	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5238B	8N	8.7	8.27	9.13	20	8	600	0.25	3	6	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5239B	8P	9.1	8.65	9.56	20	10	600	0.25	3	6.5	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5240B	8Q	10	9.5	10.5	20	17	600	0.25	3	8	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5241B	8R	11	10.45	11.55	20	22	600	0.25	3	8.4	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5242B	8S	12	11.4	12.6	20	30	600	0.25	2	9.1	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5243B	8T	13	12.35	13.65	9.5	13	600	0.25	1	9.9	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5244B	8U	14	13.3	14.7	9	15	600	0.25	1	10.5	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5245B	8V	15	14.25	15.75	8.5	16	600	0.25	0.5	11	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5246B	8W	16	15.2	16.8	7.8	17	600	0.25	0.1	12	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5247B	8X	17	16.15	17.85	7.4	19	600	0.25	0.1	13	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5248B	8Y	18	17.1	18.9	7	21	600	0.25	0.1	14	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5249B	8Z	19	18.05	19.95	6.6	23	600	0.25	0.1	14	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5250B	81A	20	19	21	6.2	25	600	0.25	0.1	15	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5251B	81B	22	20.9	23.1	5.6	29	600	0.25	0.1	17	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5252B	81C	24	22.8	25.2	5.2	33	600	0.25	0.1	18	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5253B	81D	25	23.75	26.25	5	35	600	0.25	0.1	19	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5254B	81E	27	25.65	28.35	5	41	600	0.25	0.1	21	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5255B	81F	28	26.6	29.4	4.5	44	600	0.25	0.1	21	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5256B	81G	30	28.5	31.5	4.2	49	600	0.25	0.1	23	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5257B	81H	33	31.35	34.65	3.8	58	700	0.25	0.1	25	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5258B	81J	36	34.2	37.8	3.4	70	700	0.25	0.1	27	350	SOT-23	5%单芯
MMBZ5259B	81K	39	37.05	40.95	3.2	80	800	0.25	0.1	30	350	SOT-23	5%单芯
BZX84C2V4	Z11	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C2V7	Z12	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	300	SOT-23	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84C3V0	Z13	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C3V3	Z14	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C3V6	Z15	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C3V9	Z16	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C4V3	Z17	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C4V7	Z1	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C5V1	Z2	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C5V6	Z3	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C6V2	Z4	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C6V8	Z5	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C7V5	Z6	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C8V2	Z7	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C9V1	Z8	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C10	Z9	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C11	Y1	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C12	Y2	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C13	Y3	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C15	Y4	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C16	Y5	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C18	Y6	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C20	Y7	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C22	Y8	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C24	Y9	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C27	Y10	27	25.1	28.9	2	25	65	0.5	0.05	18.9	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C30	Y11	30	28	32	2	30	70	0.5	0.05	21	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C33	Y12	33	31	35	2	35	75	0.5	0.05	23.1	300	SOT-23	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84C36	Y13	36	34	38	2	35	80	0.5	0.05	25.2	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C39	Y14	39	37	41	2	40	80	0.5	0.05	27.3	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C43	Y15	43	40	46	2	45	85	0.5	0.05	30.1	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C47	Y16	47	44	50	2	50	85	0.5	0.05	32.9	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C51	Y17	51	48	54	2	60	95	0.5	0.05	35.7	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C56	Y18	56	52	60	2	75	110	0.5	0.05	39.2	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C62	Y19	62	58	66	2	90	130	0.5	0.05	43.4	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C68	Y20	68	64	72	2	110	160	0.5	0.05	47.6	300	SOT-23	6%单芯
BZX84C75	Y21	75	70	79	2	150	200	0.5	0.05	52.5	300	SOT-23	6%单芯
MMBZ5V1A	5A1	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	5	2	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ5V6A	5A6	5.6	5.32	5.88	5	40	400	1	5	3	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ6V2A	6A2	6.2	5.89	6.51	5	15	80	1	0.5	3	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ6V8A	6A8	6.8	6.46	7.14	5	6	40	1	0.5	4.5	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ9V1A	9A1	9.1	8.65	9.56	5	6	30	1	0.3	6	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ12VA	12A	12	11.4	12.7	50	150	10	20	0.1	8	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ15VA	15A	15	13.8	15.6	50	170	10	30	0.05	10.5	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ20VA	20A	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ27VA	27A	27	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	200	SOT-23	6%共阳
MMBZ33VA	33A	33	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	200	SOT-23	6%共阳
BZX84C2V4CA	7H	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C2V7CA	7J	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C3V0CA	MR	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C3V3CA	MX	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C3V6CA	MY	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C3V9CA	MZ	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C4V3CA	NA	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	6%共阳

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84C4V7CA	NB	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C5V1CA	NC	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C5V6CA	ND	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C6V2CA	NE	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C6V8CA	NF	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C7V5CA	NH	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C8V2CA	NJ	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C9V1CA	NK	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C10CA	NM	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C11CA	NN	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C12CA	NP	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C13CA	NX	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C15CA	NY	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C16CA	NZ	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C18CA	PA	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C20CA	PB	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C22CA	PC	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C24CA	PD	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C27CA	PE	27	25.1	28.9	2	25	65	0.5	0.05	18.9	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C30CA	PF	30	28	32	2	30	70	0.5	0.05	21	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C33CA	PH	33	31	35	2	35	75	0.5	0.05	23.1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C36CA	PJ	36	34	38	2	35	80	0.5	0.05	25.2	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C39CA	PM	39	37	41	2	40	80	0.5	0.05	27.3	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C43CA	PN	43	40	46	2	45	85	0.5	0.05	30.1	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C47CA	PP	47	44	50	2	50	85	0.5	0.05	32.9	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C51CA	7K	51	48	54	2	60	95	0.5	0.05	35.7	300	SOT-23	6%共阳

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84C56CA	7M	56	52	60	2	75	110	0.5	0.05	39.2	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C62CA	7N	62	58	66	2	90	130	0.5	0.05	43.4	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C68CA	7P	68	64	72	2	110	160	0.5	0.05	47.6	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C75CA	7R	75	70	79	2	150	200	0.5	0.05	52.5	300	SOT-23	6%共阳
BZX84C2V4CC	JH	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C2V7CC	JJ	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C3V0CC	JK	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C3V3CC	JM	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C3V6CC	JN	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C3V9CC	JP	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C4V3CC	JR	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C4V7CC	JX	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C5V1CC	JY	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C5V6CC	JZ	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C6V2CC	KA	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C6V8CC	KB	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C7V5CC	KC	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C8V2CC	KD	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C9V1CC	KE	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C10CC	KF	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C11CC	KH	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C12CC	KJ	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C13CC	KK	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C15CC	KM	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C16CC	KN	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C18CC	KP	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	300	SOT-23	6%共阴

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX84C20CC	KR	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C22CC	KX	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C24CC	KY	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C27CC	KZ	27	25.1	28.9	2	25	65	0.5	0.05	18.9	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C30CC	MA	30	28	32	2	30	70	0.5	0.05	21	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C33CC	MB	33	31	35	2	35	75	0.5	0.05	23.1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C36CC	MC	36	34	38	2	35	80	0.5	0.05	25.2	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C39CC	MD	39	37	41	2	40	80	0.5	0.05	27.3	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C43CC	ME	43	40	46	2	45	85	0.5	0.05	30.1	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C47CC	MF	47	44	50	2	50	85	0.5	0.05	32.9	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C51CC	MH	51	48	54	2	60	95	0.5	0.05	35.7	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C56CC	MJ	56	52	60	2	75	110	0.5	0.05	39.2	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C62CC	MK	62	58	66	2	90	130	0.5	0.05	43.4	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C68CC	MM	68	64	72	2	110	160	0.5	0.05	47.6	300	SOT-23	6%共阴
BZX84C75CC	MN	75	70	79	2	150	200	0.5	0.05	52.5	300	SOT-23	6%共阴
ZMM2V7	空	2.7	2.5	2.9	5	85	600	1	10	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM3V0	空	3	2.8	3.2	5	85	600	1	4	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM3V3	空	3.3	3.1	3.5	5	85	600	1	2	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM3V6	空	3.6	3.4	3.8	5	85	600	1	2	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM3V9	空	3.9	3.7	4.1	5	85	600	1	2	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM4V3	空	4.3	4	4.6	5	75	600	1	1	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM4V7	空	4.7	4.4	5	5	60	600	1	0.5	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM5V1	空	5.1	4.8	5.4	5	35	550	1	0.1	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM5V6	空	5.6	5.2	6	5	25	450	1	0.1	1	500	LL-34	玻封停产
ZMM6V2	空	6.2	5.8	6.6	5	10	200	1	0.1	2	500	LL-34	玻封停产
ZMM6V8	空	6.8	6.4	7.2	5	8	150	1	0.1	3	500	LL-34	玻封停产

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
ZMM7V5	空	7.5	7	7.9	5	7	50	1	0.1	5	500	LL-34	玻封停产
ZMM8V2	空	8.2	7.7	8.7	5	7	50	1	0.1	6.2	500	LL-34	玻封停产
ZMM9V1	空	9.1	8.5	9.6	5	10	50	1	0.1	6.8	500	LL-34	玻封停产
ZMM10	空	10	9.4	10.6	5	15	70	1	0.1	7.5	500	LL-34	玻封停产
ZMM11	空	11	10.4	11.6	5	20	70	1	0.1	8.2	500	LL-34	玻封停产
ZMM12	空	12	11.4	12.7	5	20	90	1	0.1	9.1	500	LL-34	玻封停产
ZMM13	空	13	12.4	14.1	5	26	110	1	0.1	10	500	LL-34	玻封停产
ZMM15	空	15	13.8	15.6	5	30	110	1	0.1	11	500	LL-34	玻封停产
ZMM16	空	16	15.3	17.1	5	40	170	1	0.1	12	500	LL-34	玻封停产
ZMM18	空	18	16.8	19.1	5	50	170	1	0.1	13	500	LL-34	玻封停产
ZMM20	空	20	18.8	21.2	5	55	220	1	0.1	15	500	LL-34	玻封停产
ZMM22	空	22	20.8	23.3	5	55	220	1	0.1	16	500	LL-34	玻封停产
ZMM24	空	24	22.8	25.6	5	80	220	1	0.1	18	500	LL-34	玻封停产
ZMM27	空	27	25.1	28.9	5	80	220	1	0.1	20	500	LL-34	玻封停产
ZMM30	空	30	28	32	5	80	220	1	0.1	22	500	LL-34	玻封停产
ZMM33	空	33	31	35	5	80	220	1	0.1	24	500	LL-34	玻封停产
ZMM36	空	36	34	38	5	80	220	1	0.1	27	500	LL-34	玻封停产
ZMM39	空	39	37	41	5	90	500	1	0.1	30	500	LL-34	玻封停产
ZMM43	空	43	40	46	5	90	500	1	0.1	33	500	LL-34	玻封停产
ZMM47	空	47	44	50	5	110	600	1	0.1	36	500	LL-34	玻封停产
ZMM51	空	51	48	54	5	125	700	1	0.1	39	500	LL-34	玻封停产
ZM4728A	空	3.3			76	10	400	1	100	1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4729A	空	3.6			69	10	400	1	100	1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4730A	空	3.9			64	9	400	1	50	1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4731A	空	4.3			58	9	400	1	10	1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4732A	空	4.7			53	8	500	1	10	1	1000	LL-41	玻封停产

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
ZM4733A	空	5.1			49	7	550	1	10	1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4734A	空	5.6			45	5	600	1	10	2	1000	LL-41	玻封停产
ZM4735A	空	6.2			41	2	700	1	10	3	1000	LL-41	玻封停产
ZM4736A	空	6.8			37	3.5	700	1	10	4	1000	LL-41	玻封停产
ZM4737A	空	7.5			34	4	700	0.5	10	5	1000	LL-41	玻封停产
ZM4738A	空	8.2			31	4.5	700	0.5	10	6	1000	LL-41	玻封停产
ZM4739A	空	9.1			28	5	700	0.5	10	7	1000	LL-41	玻封停产
ZM4740A	空	10			25	7	700	0.25	10	7.6	1000	LL-41	玻封停产
ZM4741A	空	11			23	8	700	0.25	5	8.4	1000	LL-41	玻封停产
ZM4742A	空	12			21	9	700	0.25	5	9.1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4743A	空	13			19	10	700	0.25	5	9.9	1000	LL-41	玻封停产
ZM4744A	空	15			17	14	700	0.25	5	11.4	1000	LL-41	玻封停产
ZM4745A	空	16			15.5	16	700	0.25	5	12.2	1000	LL-41	玻封停产
ZM4746A	空	18			14	20	700	0.25	5	13.7	1000	LL-41	玻封停产
ZM4747A	空	20			12.5	22	750	0.25	5	15.2	1000	LL-41	玻封停产
ZM4748A	空	22			11.5	23	750	0.25	5	16.7	1000	LL-41	玻封停产
ZM4749A	空	24			10.5	25	750	0.25	5	18.2	1000	LL-41	玻封停产
ZM4750A	空	27			9.5	35	750	0.25	5	20.6	1000	LL-41	玻封停产
ZM4751A	空	30			8.5	40	1000	0.25	5	22.8	1000	LL-41	玻封停产
ZM4752A	空	33			7.5	45	1000	0.25	5	25.1	1000	LL-41	玻封停产
ZM4753A	空	36			7	50	1000	0.25	5	27.4	1000	LL-41	玻封停产
ZM4754A	空	39			6.5	60	1000	0.25	5	29.7	1000	LL-41	玻封停产
ZM4755A	空	43			6	70	1500	0.25	5	32.7	1000	LL-41	玻封停产
ZM4756A	空	47			5.5	80	1500	0.25	5	35.8	1000	LL-41	玻封停产
ZM4757A	空	51			5	95	1500	0.25	5	38.8	1000	LL-41	玻封停产
ZM4758A	空	56			4.5	110	2000	0.25	5	42.6	1000	LL-41	玻封停产

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MMSZ5221B	C1	2.4	2.28	2.52	20	30	1200	0.25	100	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5222B	C2	2.5	2.38	2.63	20	30	1250	0.25	100	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5223B	C3	2.7	2.57	2.84	20	30	1300	0.25	75	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5224B	C4	2.8	2.66	2.94	20	30	1400	0.25	75	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5225B	C5	3	2.85	3.15	20	30	1600	0.25	50	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5226B	G1	3.3	3.14	3.47	20	28	1600	0.25	25	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5227B	G2	3.6	3.42	3.78	20	24	1700	0.25	15	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5228B	G3	3.9	3.71	4.1	20	23	1900	0.25	10	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5229B	G4	4.3	4.09	4.52	20	22	2000	0.25	5	1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5230B	G5	4.7	4.47	4.94	20	19	1900	0.25	5	2	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5231B	E1	5.1	4.85	5.36	20	17	1600	0.25	5	2	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5232B	E2	5.6	5.32	5.88	20	11	1600	0.25	5	3	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5233B	E3	6	5.7	6.3	20	7	1600	0.25	5	3.5	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5234B	E4	6.2	5.89	6.51	20	7	1000	0.25	5	4	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5235B	E5	6.8	6.46	7.14	20	5	750	0.25	3	5	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5236B	F1	7.5	7.13	7.88	20	6	500	0.25	3	6	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5237B	F2	8.2	7.79	8.61	20	8	500	0.25	3	6	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5238B	F3	8.7	8.27	9.13	20	8	600	0.25	3	6	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5239B	F4	9.1	8.65	9.56	20	10	600	0.25	3	6.5	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5240B	F5	10	9.5	10.5	20	17	600	0.25	3	8	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5241B	H1	11	10.45	11.55	20	22	600	0.25	3	8.4	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5242B	H2	12	11.4	12.6	20	30	600	0.25	2	9.1	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5243B	H3	13	12.35	13.65	9.5	13	600	0.25	1	9.9	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5244B	H4	14	13.3	14.7	9	15	600	0.25	1	10.5	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5245B	H5	15	14.25	15.75	8.5	16	600	0.25	0.5	11	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5246B	J1	16	15.2	16.8	7.8	17	600	0.25	0.1	12	500	SOD-123	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MMSZ5247B	J2	17	16.15	17.85	7.4	19	600	0.25	0.1	13	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5248B	J3	18	17.1	18.9	7	21	600	0.25	0.1	14	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5249B	J4	19	18.05	19.95	6.6	23	600	0.25	0.1	14	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5250B	J5	20	19	21	6.2	25	600	0.25	0.1	15	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5251B	K1	22	20.9	23.1	5.6	29	600	0.25	0.1	17	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5252B	K2	24	22.8	25.2	5.2	33	600	0.25	0.1	18	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5253B	K3	25	23.75	26.25	5	35	600	0.25	0.1	19	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5254B	K4	27	25.65	28.35	5	41	600	0.25	0.1	21	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5255B	K5	28	26.6	29.4	4.5	44	600	0.25	0.1	21	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5256B	M1	30	28.5	31.5	4.2	49	600	0.25	0.1	23	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5257B	M2	33	31.35	34.65	3.8	58	700	0.25	0.1	25	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5258B	M3	36	34.2	37.8	3.4	70	700	0.25	0.1	27	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5259B	M4	39	37.05	40.95	3.2	80	800	0.25	0.1	30	500	SOD-123	5%单芯
MMSZ5221BS	C1	2.4	2.28	2.52	20	30	1200	0.25	100	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5222BS	C2	2.5	2.38	2.63	20	30	1250	0.25	100	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5223BS	C3	2.7	2.57	2.84	20	30	1300	0.25	75	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5224BS	C4	2.8	2.66	2.94	20	30	1400	0.25	75	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5225BS	C5	3	2.85	3.15	20	30	1600	0.25	50	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5226BS	G1	3.3	3.14	3.47	20	28	1600	0.25	25	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5227BS	G2	3.6	3.42	3.78	20	24	1700	0.25	15	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5228BS	G3	3.9	3.71	4.1	20	23	1900	0.25	10	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5229BS	G4	4.3	4.09	4.52	20	22	2000	0.25	5	1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5230BS	G5	4.7	4.47	4.94	20	19	1900	0.25	5	2	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5231BS	E1	5.1	4.85	5.36	20	17	1600	0.25	5	2	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5232BS	E2	5.6	5.32	5.88	20	11	1600	0.25	5	3	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5233BS	E3	6	5.7	6.3	20	7	1600	0.25	5	3.5	300	SOD-323	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MMSZ5234BS	E4	6.2	5.89	6.51	20	7	1000	0.25	5	4	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5235BS	E5	6.8	6.46	7.14	20	5	750	0.25	3	5	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5236BS	F1	7.5	7.13	7.88	20	6	500	0.25	3	6	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5237BS	F2	8.2	7.79	8.61	20	8	500	0.25	3	6	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5238BS	F3	8.7	8.27	9.13	20	8	600	0.25	3	6	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5239BS	F4	9.1	8.65	9.56	20	10	600	0.25	3	6.5	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5240BS	F5	10	9.5	10.5	20	17	600	0.25	3	8	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5241BS	H1	11	10.45	11.55	20	22	600	0.25	3	8.4	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5242BS	H2	12	11.4	12.6	20	30	600	0.25	2	9.1	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5243BS	H3	13	12.35	13.65	9.5	13	600	0.25	1	9.9	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5244BS	H4	14	13.3	14.7	9	15	600	0.25	1	10.5	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5245BS	H5	15	14.25	15.75	8.5	16	600	0.25	0.5	11	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5246BS	J1	16	15.2	16.8	7.8	17	600	0.25	0.1	12	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5247BS	J2	17	16.15	17.85	7.4	19	600	0.25	0.1	13	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5248BS	J3	18	17.1	18.9	7	21	600	0.25	0.1	14	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5249BS	J4	19	18.05	19.95	6.6	23	600	0.25	0.1	14	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5250BS	J5	20	19	21	6.2	25	600	0.25	0.1	15	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5251BS	K1	22	20.9	23.1	5.6	29	600	0.25	0.1	17	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5252BS	K2	24	22.8	25.2	5.2	33	600	0.25	0.1	18	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5253BS	K3	25	23.75	26.25	5	35	600	0.25	0.1	19	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5254BS	K4	27	25.65	28.35	5	41	600	0.25	0.1	21	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5255BS	K5	28	26.6	29.4	4.5	44	600	0.25	0.1	21	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5256BS	M1	30	28.5	31.5	4.2	49	600	0.25	0.1	23	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5257BS	M2	33	31.35	34.65	3.8	58	700	0.25	0.1	25	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5258BS	M3	36	34.2	37.8	3.4	70	700	0.25	0.1	27	300	SOD-323	5%单芯
MMSZ5259BS	M4	39	37.05	40.95	3.2	80	800	0.25	0.1	30	300	SOD-323	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZT52B2V4	WX	2.4	2.35	2.45	5	80	325	1	50	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B2V7	W1	2.7	2.64	2.76	5	80	325	1	20	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B3V0	W2	3	2.94	3.06	5	80	325	1	10	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B3V3	W3	3.3	3.23	3.37	5	85	350	1	5	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B3V6	W4	3.6	3.52	3.68	5	85	375	1	5	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B3V9	W5	3.9	3.82	3.98	5	85	400	1	3	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B4V3	W6	4.3	4.21	4.39	5	85	400	1	3	1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B4V7	W7	4.7	4.6	4.8	5	80	410	1	3	2	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B5V1	W8	5.1	4.99	5.2	5	50	425	1	2	2	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B5V6	W9	5.6	5.49	5.71	5	40	400	1	1	2	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B6V2	WA	6.2	6.07	6.32	5	15	80	1	3	4	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B6V8	WB	6.8	6.66	6.94	5	6	40	1	2	4	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B7V5	WC	7.5	7.35	7.65	5	6	30	1	1	5	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B8V2	WD	8.2	8.04	8.36	5	6	30	1	0.7	5	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B9V1	WE	9.1	8.92	9.28	5	6	40	1	0.5	6	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B10	WF	10	9.8	10.2	5	6	40	1	0.2	7	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B11	WG	11	10.8	11.2	5	8	50	1	0.1	8	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B12	WH	12	11.8	12.2	5	10	50	1	0.1	8	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B13	WI	13	12.7	13.3	5	10	50	1	0.1	8	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B15	WJ	15	14.7	15.3	5	10	50	1	0.05	10.5	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B16	WK	16	15.7	16.3	5	10	50	1	0.05	11.2	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B18	WL	18	17.6	18.4	5	10	50	1	0.05	12.6	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B20	WM	20	19.6	20.4	5	10	50	1	0.05	14	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B22	WN	22	21.6	22.5	5	15	60	1	0.05	15.4	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B24	WO	24	23.5	24.5	5	20	60	1	0.05	16.8	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B27	WP	27	26.4	27.6	2	25	65	0.5	0.05	18.9	500	SOD-123	2%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZT52B30	WQ	30	29.4	30.6	2	30	70	0.5	0.05	21	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B33	WR	33	32.3	33.7	2	35	75	0.5	0.05	23.1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B36	WS	36	35.2	36.8	2	35	80	0.5	0.05	25.2	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B39	WT	39	38.2	39.8	2	40	80	0.5	0.05	27.3	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B43	WU	43	42.1	43.9	2	45	85	0.5	0.05	30.1	500	SOD-123	2%单芯
BZT52B2V4S	WX	2.4	2.35	2.45	5	80	325	1	50	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B2V7S	W1	2.7	2.64	2.76	5	80	325	1	20	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B3V0S	W2	3	2.94	3.06	5	80	325	1	10	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B3V3S	W3	3.3	3.23	3.37	5	85	350	1	5	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B3V6S	W4	3.6	3.52	3.68	5	85	375	1	5	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B3V9S	W5	3.9	3.82	3.98	5	85	400	1	3	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B4V3S	W6	4.3	4.21	4.39	5	85	400	1	3	1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B4V7S	W7	4.7	4.6	4.8	5	80	410	1	3	2	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B5V1S	W8	5.1	4.99	5.2	5	50	425	1	2	2	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B5V6S	W9	5.6	5.49	5.71	5	40	400	1	1	2	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B6V2S	WA	6.2	6.07	6.32	5	15	80	1	3	4	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B6V8S	WB	6.8	6.66	6.94	5	6	40	1	2	4	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B7V5S	WC	7.5	7.35	7.65	5	6	30	1	1	5	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B8V2S	WD	8.2	8.04	8.36	5	6	30	1	0.7	5	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B9V1S	WE	9.1	8.92	9.28	5	6	40	1	0.5	6	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B10S	WF	10	9.8	10.2	5	6	40	1	0.2	7	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B11S	WG	11	10.8	11.2	5	8	50	1	0.1	8	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B12S	WH	12	11.8	12.2	5	10	50	1	0.1	8	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B13S	WI	13	12.7	13.3	5	10	50	1	0.1	8	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B15S	WJ	15	14.7	15.3	5	10	50	1	0.05	10.5	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B16S	WK	16	15.7	16.3	5	10	50	1	0.05	11.2	300	SOD-323	2%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZT52B18S	WL	18	17.6	18.4	5	10	50	1	0.05	12.6	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B20S	WM	20	19.6	20.4	5	10	50	1	0.05	14	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B22S	WN	22	21.6	22.5	5	15	60	1	0.05	15.4	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B24S	WO	24	23.5	24.5	5	20	60	1	0.05	16.8	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B27S	WP	27	26.4	27.6	2	25	65	0.5	0.05	18.9	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B30S	WQ	30	29.4	30.6	2	30	70	0.5	0.05	21	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B33S	WR	33	32.3	33.7	2	35	75	0.5	0.05	23.1	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B36S	WS	36	35.2	36.8	2	35	80	0.5	0.05	25.2	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B39S	WT	39	38.2	39.8	2	40	80	0.5	0.05	27.3	300	SOD-323	2%单芯
BZT52B43S	WU	43	42.1	43.9	2	45	85	0.5	0.05	30.1	300	SOD-323	2%单芯
MM1W3V3	FHD	3.3	3.10	3.50	75	10	IZM (mA)	285	100	1	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W3V6	FHE	3.6	3.40	3.80	69	10		263	100	1	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W3V9	FHF	3.9	3.70	4.10	64	9		243	50	1	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W4V3	FHG	4.3	4.06	4.56	58	9		219	25	1	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W4V7	FHJ	4.7	4.50	4.93	53	8		203	10	1	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W5V1	FHK	5.1	4.84	5.36	49	7		186	10	1	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W5V6	FHL	5.6	5.32	5.92	45	5		170	10	2	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W6V2	FHN	6.2	5.86	6.51	41	2		154	10	3	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W6V8	FHO	6.8	6.46	7.18	37	3.5		140	10	4	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W7V5	FHQ	7.5	7.12	7.88	34	4		127	10	5	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W8V2	FHR	8.2	7.79	8.67	31	4.5		116	10	6	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W9V1	FHT	9.1	8.60	9.59	28	5		104	10	7	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W10	FHU	10	9.50	10.5	25	7		95	10	7	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W11	FHV	11	10.4	11.6	23	8		86	5	8	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W12	FHW	12	11.4	12.6	21	9		79	5	9	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W13	FHX	13	12.4	14.1	19	10		71	5	10	1000	SOD-123	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM1W15	FHZ	15	13.8	15.8	17	14		63	5	11	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W16	FJA	16	15.2	17.1	16	16		58	5	12	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W18	FJF	18	16.8	19.2	14	20		52	5	13	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W20	FJG	20	19.0	21.2	13	22		47	5	15	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W22	FJK	22	20.8	23.3	12	23		43	5	17	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W24	FJL	24	22.8	26.0	11	25		38	5	18	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W27	FJN	27	25.3	28.9	9.5	35		35	5	21	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W30	FJQ	30	28.2	32.0	8.5	40		31	5	23	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W33	FJR	33	31.3	34.9	7.5	45		28	5	25	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W36	FJS	36	34.2	37.9	7	50		26	5	27	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W39	FJT	39	37.2	41.5	6.5	60		24	5	30	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W43	FLG	43	40.9	45.6	6	70		22	1	32	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W47	FLJ	47	44.9	49.8	5.5	80		20	1	35	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W51	FLK	51	48.6	54.0	5	95		18	1	38	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W56	FLL	56	53.6	58.8	4.5	110		17	1	42	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W62	FLN	62	58.9	65.6	4	125		15	1	47	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W68	FLO	68	64.6	71.7	3.7	150		14	1	52	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W75	FLQ	75	71.2	78.8	3.3	175		12	1	56	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W82	FLR	82	77.9	87.0	3	200		11	1	62	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W91	FLT	91	86.0	96.0	2.8	250		10	1	69	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W100	FLU	100	95.0	105	2.5	350		9.5	1	76	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W110	FLV	110	104	116	2.3	450		8.6	1	84	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W120	FLW	120	114	127	2	550		7.8	1	91	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W135	FLX	135	125	142	1.9	700		7	1	100	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W150	FLZ	150	140	157	1.7	900		6.3	1	110	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W165	FPA	165	155	172	1.6	1100		5.8	1	120	1000	SOD-123	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM1W180	FPF	180	170	191	1.4	1200		5.2	1	135	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W200	FPG	200	189	211	1.2	1400		4.7	1	150	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W220	FPK	220	209	231	1	1600		4.3	1	165	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W240	FPL	240	229	251	1	1800		3.9	1	180	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W260	FPM	260	249	271	1	2000		3.7	1	190	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W280	FPN	280	269	291	1	2100		3.4	1	205	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W300	FPQ	300	289	315	1	2300		3.1	1	230	1000	SOD-123	5%单芯
MM1W330	FLR	330	313	346	1	2500		2.8	1	250	1000	SOD-123	5%单芯
BZT52C2V0	WY	2	1.91	2.09	5	80	325	1	150	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C2V4	WX	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C2V7	W1	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C3V0	W2	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C3V3	W3	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C3V6	W4	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C3V9	W5	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C4V3	W6	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C4V7	W7	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C5V1	W8	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C5V6	W9	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C6V2	WA	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C6V8	WB	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C7V5	WC	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C8V2	WD	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C9V1	WE	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C10	WF	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C11	WG	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	500	SOD-123	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZT52C12	WH	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C13	WI	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C15	WJ	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C16	WK	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C18	WL	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C20	WM	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C22	WN	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C24	WO	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C27	WP	27	25.1	28.9	5	25	65	1	0.05	18.9	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C30	WQ	30	28	32	5	30	70	1	0.05	21	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C33	WR	33	31	35	5	35	75	1	0.05	23.1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C36	WS	36	34	38	5	35	80	1	0.05	25.2	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C39	WT	39	37	41	5	40	80	1	0.05	27.3	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C43	6A	43	40	46	5	45	85	1	0.05	30.1	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C47	6B	47	44	50	5	50	85	1	0.05	32.9	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C51	6C	51	48	54	5	60	95	1	0.05	35.7	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C56	6D	56	52	60	5	75	110	1	0.05	39.2	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C62	6E	62	58	66	5	90	130	1	0.05	43.4	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C68	6F	68	64	72	5	110	160	1	0.05	47.6	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C75	6H	75	70	79	5	150	200	1	0.05	52.5	500	SOD-123	6%单芯
BZT52C2V0S	WY	2	1.91	2.09	5	80	325	1	150	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C2V4S	WX	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C2V7S	W1	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C3V0S	W2	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C3V3S	W3	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C3V6S	W4	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	300	SOD-323	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZT52C3V9S	W5	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C4V3S	W6	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C4V7S	W7	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C5V1S	W8	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C5V6S	W9	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C6V2S	WA	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C6V8S	WB	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C7V5S	WC	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C8V2S	WD	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C9V1S	WE	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C10S	WF	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C11S	WG	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C12S	WH	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C13S	WI	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C15S	WJ	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C16S	WK	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C18S	WL	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C20S	WM	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C22S	WN	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C24S	WO	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C27S	WP	27	25.1	28.9	5	25	65	1	0.05	18.9	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C30S	WQ	30	28	32	5	30	70	1	0.05	21	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C33S	WR	33	31	35	5	35	75	1	0.05	23.1	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C36S	WS	36	34	38	5	35	80	1	0.05	25.2	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C39S	WT	39	37	41	5	40	80	1	0.05	27.3	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C43S	6A	43	40	46	5	45	85	1	0.05	30.1	300	SOD-323	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZT52C47S	6B	47	44	50	5	50	85	1	0.05	32.9	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C51S	6C	51	48	54	5	60	95	1	0.05	35.7	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C56S	6D	56	52	60	5	75	110	1	0.05	39.2	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C62S	6E	62	58	66	5	90	130	1	0.05	43.4	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C68S	6F	68	64	72	5	110	160	1	0.05	47.6	300	SOD-323	6%单芯
BZT52C75S	6H	75	70	79	5	150	200	1	0.05	52.5	300	SOD-323	6%单芯
BZX584B2V4	2V1	2.4	2.35	2.45	5	80	325	1	50	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B2V7	2V2	2.7	2.64	2.76	5	80	325	1	20	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B3V0	2V3	3	2.94	3.06	5	80	325	1	10	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B3V3	2V4	3.3	3.23	3.37	5	85	350	1	5	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B3V6	2V5	3.6	3.52	3.68	5	85	375	1	5	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B3V9	2V6	3.9	3.82	3.98	5	85	400	1	3	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B4V3	2V7	4.3	4.21	4.39	5	85	400	1	3	1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B4V7	2Z1	4.7	4.6	4.8	5	80	410	1	3	2	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B5V1	2Z2	5.1	4.99	5.2	5	50	425	1	2	2	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B5V6	2Z3	5.6	5.49	5.71	5	40	400	1	1	2	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B6V2	2Z3	6.2	6.07	6.32	5	15	80	1	3	4	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B6V8	2Z4	6.8	6.66	6.94	5	6	40	1	2	4	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B7V5	2Z5	7.5	7.35	7.65	5	6	30	1	1	5	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B8V2	2Z6	8.2	8.04	8.36	5	6	30	1	0.7	5	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B9V1	2Z7	9.1	8.92	9.28	5	6	40	1	0.5	6	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B10	2Z8	10	9.8	10.2	5	6	40	1	0.2	7	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B11	2Z9	11	10.8	11.2	5	8	50	1	0.1	8	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B12	2Y1	12	11.8	12.2	5	10	50	1	0.1	8	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B13	2T2	13	12.7	13.3	5	10	50	1	0.1	8	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B15	2Y4	15	14.7	15.3	5	10	50	1	0.05	10.5	200	SOD-523	2%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX584B16	2Y5	16	15.7	16.3	5	10	50	1	0.05	11.2	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B18	2Y6	18	17.6	18.4	5	10	50	1	0.05	12.6	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B20	2Y7	20	19.6	20.4	5	10	50	1	0.05	14	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B22	2Y8	22	21.6	22.5	5	15	60	1	0.05	15.4	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B24	2Y9	24	23.5	24.5	5	20	60	1	0.05	16.8	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B27	2X1	27	26.4	27.6	2	25	65	0.5	0.05	18.9	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B30	2X2	30	29.4	30.6	2	30	70	0.5	0.05	21	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B33	2X3	33	32.3	33.7	2	35	75	0.5	0.05	23.1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B36	2X4	36	35.2	36.8	2	35	80	0.5	0.05	25.2	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B39	2X5	39	38.2	39.8	2	40	80	0.5	0.05	27.3	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B43	Y5	43	42.1	43.9	2	45	85	0.5	0.05	30.1	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B47	Z5	47	46	48	2	50	85	0.5	0.05	32.9	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B51	-5	51	49.9	52.1	2	60	95	0.5	0.05	35.7	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B56	X2	56	54.8	57.2	2	75	110	0.5	0.05	39.2	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B62	X3	62	60.7	63.3	2	90	130	0.5	0.05	43.4	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B68	X4	68	66.6	69.4	2	110	160	0.5	0.05	47.6	200	SOD-523	2%单芯
BZX584B75	X5	75	73.5	76.5	2	150	200	0.5	0.05	52.5	200	SOD-523	2%单芯
BZX584C2V4	Z11	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C2V7	Z12	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C3V0	Z13	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C3V3	Z14	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C3V6	Z15	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C3V9	Z16	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C4V3	Z17	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C4V7	Z1	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C5V1	Z2	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	200	SOD-523	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX584C5V6	Z3	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C6V2	Z4	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C6V8	Z5	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C7V5	Z6	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C8V2	Z7	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C9V1	Z8	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C10	Z9	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C11	Y1	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C12	Y2	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C13	Y3	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C15	Y4	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C16	Y5	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C18	Y6	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C20	Y7	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C22	Y8	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C24	Y9	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C27	Y10	27	25.1	28.9	2	25	65	0.5	0.05	18.9	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C30	Y11	30	28	32	2	30	70	0.5	0.05	21	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C33	Y12	33	31	35	2	35	75	0.5	0.05	23.1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C36	Y13	36	34	38	2	35	80	0.5	0.05	25.2	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C39	Y14	39	37	41	2	40	80	0.5	0.05	27.3	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C43	Y15	43	40	46	2	45	85	0.5	0.05	30.1	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C47	Y16	47	44	50	2	50	85	0.5	0.05	32.9	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C51	Y17	51	48	54	2	60	95	0.5	0.05	35.7	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C56	Y18	56	52	60	2	75	110	0.5	0.05	39.2	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C62	Y19	62	58	66	2	90	130	0.5	0.05	43.4	200	SOD-523	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
BZX584C68	Y20	68	64	72	2	110	160	0.5	0.05	47.6	200	SOD-523	6%单芯
BZX584C75	Y21	75	70	79	2	150	200	0.5	0.05	52.5	200	SOD-523	6%单芯
MM1Z2V0B	4A	2	1.96	2.04	5	100			120	0.5	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z2V2B	4B	2.2	2.16	2.24	5	100	参数相当于		120	0.7	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z2V4B	4C	2.4	2.35	2.45	5	100	BZT52B2V4		120	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z2V7B	4D	2.7	2.65	2.75	5	110	BZT52B2V7		120	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z3V0B	4E	3	2.94	3.06	5	120	BZT52B3V0		50	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z3V3B	4F	3.3	3.23	3.37	5	130	BZT52B3V3		20	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z3V6B	4H	3.6	3.53	3.67	5	130	BZT52B3V6		10	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z3V9B	4J	3.9	3.82	3.98	5	130	BZT52B3V9		5	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z4V3B	4K	4.3	4.21	4.39	5	130	BZT52B4V3		5	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z4V7B	4M	4.7	4.61	4.79	5	130	BZT52B4V7		2	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z5V1B	4N	5.1	5	5.2	5	130	BZT52B5V1		2	1	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z5V6B	4P	5.6	5.49	5.71	5	80	BZT52B5V6		1	2	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z6V2B	4R	6.2	6.08	6.32	5	50	BZT52B6V2		1	3	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z6V8B	4X	6.8	6.66	6.94	5	30	BZT52B6V8		0.5	4	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z7V5B	4Y	7.5	7.35	7.65	5	30	BZT52B7V5		0.5	5	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z8V2B	4Z	8.2	8.04	8.36	5	30	BZT52B8V2		0.5	6	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z9V1B	5A	9.1	8.92	9.28	5	30	BZT52B9V1		0.5	7	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z10B	5B	10	9.8	10.2	5	30	BZT52B10		0.1	7	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z11B	5C	11	10.78	11.22	5	30	BZT52B11		0.1	8	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z12B	5D	12	11.76	12.24	5	35	BZT52B12		0.1	9	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z13B	5E	13	12.74	13.26	5	35	BZT52B13		0.1	10	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z15B	5F	15	14.7	15.3	5	40	BZT52B15		0.1	11	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z16B	5H	16	15.68	16.32	5	40	BZT52B16		0.1	12	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z18B	5J	18	17.64	18.36	5	45	BZT52B18		0.1	13	500	SOD-123	2%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM1Z20B	5K	20	19.6	20.4	5	50	BZT52B20		0.1	15	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z22B	5M	22	21.56	22.44	5	55	BZT52B22		0.1	17	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z24B	5N	24	23.52	24.48	5	60	BZT52B24		0.1	18	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z27B	5P	27	26.46	27.54	2	70	BZT52B27		0.1	21	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z30B	5R	30	29.4	30.6	2	80	BZT52B30		0.1	23	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z33B	5X	33	32.34	33.66	2	80	BZT52B33		0.1	25	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z36B	5Y	36	35.28	36.72	2	90	BZT52B36		0.1	27	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z39B	5Z	39	38.22	39.78	2	100	BZT52B39		0.1	30	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z43B	6A	43	42.14	43.86	2	130	BZT52B43		0.1	32	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z47B	6B	47	46.06	47.94	2	150			0.1	35	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z51B	6C	51	49.98	52.02	2	180			0.1	38	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z56B	6D	56	54.88	57.12	2	200			0.1	42	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z62B	6E	62	60.76	63.24	2	215			0.1	47	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z68B	6F	68	66.64	69.36	2	240			0.1	52	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z75B	6H	75	73.5	76.5	2	265			0.1	56	500	SOD-123	2%单芯
MM1Z2V0	4A	2	1.8	2.15	5	100			120	0.5	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z2V2	4B	2.2	2.08	2.33	5	100	参数相当于		120	0.7	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z2V4	4C	2.4	2.28	2.56	5	100	BZT52C2V4		120	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z2V7	4D	2.7	2.5	2.9	5	110	BZT52C2V7		120	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z3V0	4E	3	2.8	3.2	5	120	BZT52C3V0		50	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z3V3	4F	3.3	3.1	3.5	5	130	BZT52C3V3		20	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z3V6	4H	3.6	3.4	3.8	5	130	BZT52C3V6		10	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z3V9	4J	3.9	3.7	4.1	5	130	BZT52C3V9		5	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z4V3	4K	4.3	4	4.6	5	130	BZT52C4V3		5	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z4V7	4M	4.7	4.4	5	5	130	BZT52C4V7		2	1	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z5V1	4N	5.1	4.8	5.4	5	130	BZT52C5V1		2	1	500	SOD-123	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM1Z5V6	4P	5.6	5.2	6	5	80	BZT52C5V6		1	2	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z6V2	4R	6.2	5.8	6.6	5	50	BZT52C6V2		1	3	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z6V8	4X	6.8	6.4	7.2	5	30	BZT52C6V8		0.5	4	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z7V5	4Y	7.5	7	7.9	5	30	BZT52C7V5		0.5	5	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z8V2	4Z	8.2	7.7	8.7	5	30	BZT52C8V2		0.5	6	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z9V1	5A	9.1	8.5	9.6	5	30	BZT52C9V1		0.5	7	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z10	5B	10	9.4	10.6	5	30	BZT52C10		0.1	7	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z11	5C	11	10.4	11.6	5	30	BZT52C11		0.1	8	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z12	5D	12	11.4	12.7	5	35	BZT52C12		0.1	9	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z13	5E	13	12.4	14.1	5	35	BZT52C13		0.1	10	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z15	5F	15	13.8	16.2	5	40	BZT52C15		0.1	11	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z16	5H	16	15.3	17.1	5	40	BZT52C16		0.1	12	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z18	5J	18	16.8	19.1	5	45	BZT52C18		0.1	13	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z20	5K	20	18.8	21.2	5	50	BZT52C20		0.1	15	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z22	5M	22	20.8	23.3	5	55	BZT52C22		0.1	17	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z24	5N	24	22.8	25.6	5	60	BZT52C24		0.1	18	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z27	5P	27	25.1	28.9	2	70	BZT52C27		0.1	21	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z30	5R	30	28	32	2	80	BZT52C30		0.1	23	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z33	5X	33	31	35	2	80	BZT52C33		0.1	25	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z36	5Y	36	34	38	2	90	BZT52C36		0.1	27	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z39	5Z	39	37	41	2	100	BZT52C39		0.1	30	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z43	6A	43	40	46	2	130	BZT52C43		0.1	32	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z47	6B	47	44	50	2	150			0.1	35	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z51	6C	51	48	54	2	180			0.1	38	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z56	6D	56	52	60	2	200			0.1	42	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z62	6E	62	58	66	2	215			0.1	47	500	SOD-123	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM1Z68	6F	68	64	72	2	240			0.1	52	500	SOD-123	6%单芯
MM1Z75	6H	75	70	79	2	265			0.1	56	500	SOD-123	6%单芯
MM3Z2V0B	B0	2	1.96	2.04	5	100			120	0.5	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z2V2B	C0	2.2	2.16	2.24	5	100	参数相当于		120	0.7	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z2V4B	1C	2.4	2.35	2.45	5	100	BZT52B2V4S		120	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z2V7B	1D	2.7	2.65	2.75	5	110	BZT52B2V7S		120	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z3V0B	1E	3	2.94	3.06	5	120	BZT52B3V0S		50	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z3V3B	1F	3.3	3.23	3.37	5	130	BZT52B3V3S		20	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z3V6B	1H	3.6	3.53	3.67	5	130	BZT52B3V6S		10	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z3V9B	1J	3.9	3.82	3.98	5	130	BZT52B3V9S		5	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z4V3B	1K	4.3	4.21	4.39	5	130	BZT52B4V3S		5	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z4V7B	1M	4.7	4.61	4.79	5	130	BZT52B4V7S		2	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z5V1B	1N	5.1	5	5.2	5	130	BZT52B5V1S		2	1	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z5V6B	1P	5.6	5.49	5.71	5	80	BZT52B5V6S		1	2	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z6V2B	1R	6.2	6.08	6.32	5	50	BZT52B6V2S		1	3	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z6V8B	1X	6.8	6.66	6.94	5	30	BZT52B6V8S		0.5	4	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z7V5B	1Y	7.5	7.35	7.65	5	30	BZT52B7V5S		0.5	5	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z8V2B	1Z	8.2	8.04	8.36	5	30	BZT52B8V2S		0.5	6	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z9V1B	2A	9.1	8.92	9.28	5	30	BZT52B9V1S		0.5	7	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z10B	2B	10	9.8	10.2	5	30	BZT52B10S		0.1	7	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z11B	2C	11	10.78	11.22	5	30	BZT52B11S		0.1	8	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z12B	2D	12	11.76	12.24	5	35	BZT52B12S		0.1	9	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z13B	2E	13	12.74	13.26	5	35	BZT52B13S		0.1	10	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z15B	2F	15	14.7	15.3	5	40	BZT52B15S		0.1	11	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z16B	2H	16	15.68	16.32	5	40	BZT52B16S		0.1	12	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z18B	2J	18	17.64	18.36	5	45	BZT52B18S		0.1	13	300	SOD-323	2%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM3Z20B	2K	20	19.6	20.4	5	50	BZT52B20S		0.1	15	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z22B	2M	22	21.56	22.44	5	55	BZT52B22S		0.1	17	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z24B	2N	24	23.52	24.48	5	60	BZT52B24S		0.1	18	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z27B	2P	27	26.46	27.54	2	70	BZT52B27S		0.1	21	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z30B	2R	30	29.4	30.6	2	80	BZT52B30S		0.1	23	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z33B	2X	33	32.34	33.66	2	80	BZT52B33S		0.1	25	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z36B	2Y	36	35.28	36.72	2	90	BZT52B36S		0.1	27	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z39B	2Z	39	38.22	39.78	2	100	BZT52B39S		0.1	30	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z43B	3A	43	42.14	43.86	2	130	BZT52B43S		0.1	32	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z47B	3B	47	46.06	47.94	2	150			0.1	35	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z51B	3C	51	49.98	52.02	2	180			0.1	38	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z56B	3D	56	54.88	57.12	2	200			0.1	42	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z62B	3E	62	60.76	63.24	2	215			0.1	47	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z68B	3F	68	66.64	69.36	2	240			0.1	52	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z75B	3H	75	73.5	76.5	2	265			0.1	56	300	SOD-323	2%单芯
MM3Z2V0	B0	2	1.8	2.15	5	100			120	0.5	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z2V2	C0	2.2	2.08	2.33	5	100	参数相当于		120	0.7	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z2V4	1C	2.4	2.28	2.56	5	100	BZT52C2V4S		120	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z2V7	1D	2.7	2.5	2.9	5	110	BZT52C2V7S		120	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z3V0	1E	3	2.8	3.2	5	120	BZT52C3V0S		50	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z3V3	1F	3.3	3.1	3.5	5	130	BZT52C3V3S		20	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z3V6	1H	3.6	3.4	3.8	5	130	BZT52C3V6S		10	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z3V9	1J	3.9	3.7	4.1	5	130	BZT52C3V9S		5	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z4V3	1K	4.3	4	4.6	5	130	BZT52C4V3S		5	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z4V7	1M	4.7	4.4	5	5	130	BZT52C4V7S		2	1	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z5V1	1N	5.1	4.8	5.4	5	130	BZT52C5V1S		2	1	300	SOD-323	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM3Z5V6	1P	5.6	5.2	6	5	80	BZT52C5V6S		1	2	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z6V2	1R	6.2	5.8	6.6	5	50	BZT52C6V2S		1	3	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z6V8	1X	6.8	6.4	7.2	5	30	BZT52C6V8S		0.5	4	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z7V5	1Y	7.5	7	7.9	5	30	BZT52C7V5S		0.5	5	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z8V2	1Z	8.2	7.7	8.7	5	30	BZT52C8V2S		0.5	6	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z9V1	2A	9.1	8.5	9.6	5	30	BZT52C9V1S		0.5	7	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z10	2B	10	9.4	10.6	5	30	BZT52C10S		0.1	7	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z11	2C	11	10.4	11.6	5	30	BZT52C11S		0.1	8	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z12	2D	12	11.4	12.7	5	35	BZT52C12S		0.1	9	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z13	2E	13	12.4	14.1	5	35	BZT52C13S		0.1	10	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z15	2F	15	13.8	16.2	5	40	BZT52C15S		0.1	11	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z16	2H	16	15.3	17.1	5	40	BZT52C16S		0.1	12	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z18	2J	18	16.8	19.1	5	45	BZT52C18S		0.1	13	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z20	2K	20	18.8	21.2	5	50	BZT52C20S		0.1	15	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z22	2M	22	20.8	23.3	5	55	BZT52C22S		0.1	17	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z24	2N	24	22.8	25.6	5	60	BZT52C24S		0.1	18	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z27	2P	27	25.1	28.9	2	70	BZT52C27S		0.1	21	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z30	2R	30	28	32	2	80	BZT52C30S		0.1	23	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z33	2X	33	31	35	2	80	BZT52C33S		0.1	25	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z36	2Y	36	34	38	2	90	BZT52C36S		0.1	27	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z39	2Z	39	37	41	2	100	BZT52C39S		0.1	30	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z43	3A	43	40	46	2	130	BZT52C43S		0.1	32	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z47	3B	47	44	50	2	150			0.1	35	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z51	3C	51	48	54	2	180			0.1	38	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z56	3D	56	52	60	2	200			0.1	42	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z62	3E	62	58	66	2	215			0.1	47	300	SOD-323	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM3Z68	3F	68	64	72	2	240			0.1	52	300	SOD-323	6%单芯
MM3Z75	3H	75	70	79	2	265			0.1	56	300	SOD-323	6%单芯
MM5Z2V0	RD	2	1.8	2.15	5	80	325	1	120	0.5	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z2V2	RE	2.2	2.08	2.33	5	80	325	1	120	0.7	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z2V4	Z7	2.4	2.2	2.6	5	80	325	1	50	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z2V7	A8	2.7	2.5	2.9	5	80	325	1	20	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z3V0	B8	3	2.8	3.2	5	80	325	1	10	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z3V3	C8	3.3	3.1	3.5	5	85	350	1	5	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z3V6	D8	3.6	3.4	3.8	5	85	375	1	5	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z3V9	E8	3.9	3.7	4.1	5	85	400	1	3	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z4V3	F8	4.3	4	4.6	5	85	400	1	3	1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z4V7	G8	4.7	4.4	5	5	80	410	1	3	2	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z5V1	H8	5.1	4.8	5.4	5	50	425	1	2	2	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z5V6	I8	5.6	5.2	6	5	40	400	1	1	2	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z6V2	J8	6.2	5.8	6.6	5	15	80	1	3	4	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z6V8	K8	6.8	6.4	7.2	5	6	40	1	2	4	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z7V5	L8	7.5	7	7.9	5	6	30	1	1	5	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z8V2	M8	8.2	7.7	8.7	5	6	30	1	0.7	5	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z9V1	N8	9.1	8.5	9.6	5	6	40	1	0.5	6	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z10	O8	10	9.4	10.6	5	6	40	1	0.2	7	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z11	P8	11	10.4	11.6	5	8	50	1	0.1	8	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z12	Q8	12	11.4	12.7	5	10	50	1	0.1	8	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z13	R8	13	12.4	14.1	5	10	50	1	0.1	8	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z15	S8	15	13.8	15.6	5	10	50	1	0.05	10.5	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z16	T8	16	15.3	17.1	5	10	50	1	0.05	11.2	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z18	U8	18	16.8	19.1	5	10	50	1	0.05	12.6	200	SOD-523	6%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
MM5Z20	V8	20	18.8	21.2	5	10	50	1	0.05	14	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z22	W8	22	20.8	23.3	5	15	60	1	0.05	15.4	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z24	X8	24	22.8	25.6	5	20	60	1	0.05	16.8	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z27	Y8	27	25.1	28.9	2	25	65	0.5	0.05	18.9	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z30	Z8	30	28	32	2	30	70	0.5	0.05	21	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z33	A9	33	31	35	2	35	75	0.5	0.05	23.1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z36	B9	36	34	38	2	35	80	0.5	0.05	25.2	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z39	C9	39	37	41	2	40	80	0.5	0.05	27.3	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z43	D9	43	40	46	2	45	85	0.5	0.05	30.1	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z47	E9	47	44	50	2	50	85	0.5	0.05	32.9	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z51	F9	51	48	54	2	60	95	0.5	0.05	35.7	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z56	G9	56	52	60	2	75	110	0.5	0.05	39.2	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z62	H9	62	58	66	2	90	130	0.5	0.05	43.4	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z68	I9	68	64	72	2	110	160	0.5	0.05	47.6	200	SOD-523	6%单芯
MM5Z75	J9	75	70	79	2	150	200	0.5	0.05	52.5	200	SOD-523	6%单芯
1SMA4728A	728A	3.3	3.1	3.5	75	10	SMAZ4728A	100	1	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4729A	729A	3.6	3.4	3.8	69	10	SMAZ4729A	100	1	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4730A	730A	3.9	3.7	4.1	64	9	SMAZ4730A	50	1	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4731A	731A	4.3	4.06	4.56	58	9	SMAZ4731A	25	1	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4732A	732A	4.7	4.5	4.93	53	8	SMAZ4732A	10	1	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4733A	733A	5.1	4.84	5.36	49	7	SMAZ4733A	10	1	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4734A	734A	5.6	5.32	5.92	45	5	SMAZ4734A	10	2	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4735A	735A	6.2	5.86	6.51	41	2	SMAZ4735A	10	3	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4736A	736A	6.8	6.46	7.18	37	3.5	SMAZ4736A	10	4	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4737A	737A	7.5	7.12	7.88	34	4	SMAZ4737A	10	5	1000	SMA	5%单芯	
1SMA4738A	738A	8.2	7.79	8.67	31	4.5	SMAZ4738A	10	6	1000	SMA	5%单芯	

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
1SMA4739A	739A	9.1	8.6	9.59	28	5	SMAZ4739A		10	7	1000	SMA	5%单芯
1SMA4740A	740A	10	9.5	10.5	25	7	SMAZ4740A		10	7	1000	SMA	5%单芯
1SMA4741A	741A	11	10.4	11.6	23	8	SMAZ4741A		5	8	1000	SMA	5%单芯
1SMA4742A	742A	12	11.4	12.6	21	9	SMAZ4742A		5	9	1000	SMA	5%单芯
1SMA4743A	743A	13	12.4	14.1	19	10	SMAZ4743A		5	10	1000	SMA	5%单芯
1SMA4744A	744A	15	13.8	15.8	17	14	SMAZ4744A		5	11	1000	SMA	5%单芯
1SMA4745A	745A	16	15.2	17.1	16	16	SMAZ4745A		5	12	1000	SMA	5%单芯
1SMA4746A	746A	18	16.8	19.2	14	20	SMAZ4746A		5	13	1000	SMA	5%单芯
1SMA4747A	747A	20	19	21.2	13	22	SMAZ4747A		5	15	1000	SMA	5%单芯
1SMA4748A	748A	22	20.8	23.3	12	23	SMAZ4748A		5	17	1000	SMA	5%单芯
1SMA4749A	749A	24	22.8	26	11	25	SMAZ4749A		5	18	1000	SMA	5%单芯
1SMA4750A	750A	27	25.3	28.9	9.5	35	SMAZ4750A		5	21	1000	SMA	5%单芯
1SMA4751A	751A	30	28.2	32	8.5	40	SMAZ4751A		5	23	1000	SMA	5%单芯
1SMA4752A	752A	33	31.3	34.9	7.5	45	SMAZ4752A		5	25	1000	SMA	5%单芯
1SMA4753A	753A	36	34.2	37.9	7	50	SMAZ4753A		5	27	1000	SMA	5%单芯
1SMA4754A	754A	39	37.2	41.5	6.5	60	SMAZ4754A		5	30	1000	SMA	5%单芯
1SMA4755A	755A	43	40.9	45.6	6	70	SMAZ4755A		1	32	1000	SMA	5%单芯
1SMA4756A	756A	47	44.9	49.8	5.5	80	SMAZ4756A		1	35	1000	SMA	5%单芯
1SMA4757A	757A	51	48.6	54	5	95	SMAZ4757A		1	38	1000	SMA	5%单芯
1SMA4758A	758A	56	53.6	58.8	4.5	110	SMAZ4758A		1	42	1000	SMA	5%单芯
1SMA4759A	759A	62	58.9	65.6	4	125	SMAZ4759A		1	47	1000	SMA	5%单芯
1SMA4760A	760A	68	64.6	71.7	3.7	150	SMAZ4760A		1	52	1000	SMA	5%单芯
1SMA4761A	761A	75	71.2	78.8	3.3	175	SMAZ4761A		1	56	1000	SMA	5%单芯
1SMA4762A	762A	82	77.9	87	3	200	SMAZ4762A		1	62	1000	SMA	5%单芯
1SMA4763A	763A	91	86	96	2.8	250	SMAZ4763A		1	69	1000	SMA	5%单芯
1SMA4764A	764A	100	95	105	2.5	350	SMAZ4764A		1	76	1000	SMA	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
1SMA4765A	765A	110	104	116	2.3	450	SMAZ4765A		1	84	1000	SMA	5%单芯
1SMA4766A	766A	120	114	127	2	550	SMAZ4766A		1	91	1000	SMA	5%单芯
1SMA4767A	767A	135	125	142	1.9	700	SMAZ4767A		1	100	1000	SMA	5%单芯
1SMA4768A	768A	150	140	157	1.7	900	SMAZ4768A		1	110	1000	SMA	5%单芯
1SMA4769A	769A	165	155	172	1.6	1100	SMAZ4769A		1	120	1000	SMA	5%单芯
1SMA4770A	770A	180	170	191	1.4	1200	SMAZ4770A		1	135	1000	SMA	5%单芯
1SMA4771A	771A	200	189	211	1.2	1400	SMAZ4771A		1	1500	1000	SMA	5%单芯
1SMA4772A	772A	220	209	231	1	1600	SMAZ4772A		1	165	1000	SMA	5%单芯
1SMA4773A	773A	240	229	251	1	1800	SMAZ4773A		1	180	1000	SMA	5%单芯
1SMA4774A	774A	260	249	271	1	2000	SMAZ4774A		1	190	1000	SMA	5%单芯
1SMA4775A	775A	280	269	291	1	2100	SMAZ4775A		1	205	1000	SMA	5%单芯
1SMA4776A	776A	300	289	315	1	2300	SMAZ4776A		1	230	1000	SMA	5%单芯
1SMA4777A	777A	330	313	346	1	2500	SMAZ4777A		1	250	1000	SMA	5%单芯
1SMAF4728A	728A	3.3	3.1	3.5	75	10			100	1	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4729A	729A	3.6	3.4	3.8	69	10			100	1	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4730A	730A	3.9	3.7	4.1	64	9			50	1	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4731A	731A	4.3	4.06	4.56	58	9			25	1	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4732A	732A	4.7	4.5	4.93	53	8			10	1	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4733A	733A	5.1	4.84	5.36	49	7			10	1	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4734A	734A	5.6	5.32	5.92	45	5			10	2	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4735A	735A	6.2	5.86	6.51	41	2			10	3	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4736A	736A	6.8	6.46	7.18	37	3.5			10	4	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4737A	737A	7.5	7.12	7.88	34	4			10	5	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4738A	738A	8.2	7.79	8.67	31	4.5			10	6	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4739A	739A	9.1	8.6	9.59	28	5			10	7	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4740A	740A	10	9.5	10.5	25	7			10	7	1000	SMAF	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
1SMAF4741A	741A	11	10.4	11.6	23	8			5	8	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4742A	742A	12	11.4	12.6	21	9			5	9	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4743A	743A	13	12.4	14.1	19	10			5	10	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4744A	744A	15	13.8	15.8	17	14			5	11	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4745A	745A	16	15.2	17.1	16	16			5	12	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4746A	746A	18	16.8	19.2	14	20			5	13	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4747A	747A	20	19	21.2	13	22			5	15	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4748A	748A	22	20.8	23.3	12	23			5	17	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4749A	749A	24	22.8	26	11	25			5	18	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4750A	750A	27	25.3	28.9	9.5	35			5	21	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4751A	751A	30	28.2	32	8.5	40			5	23	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4752A	752A	33	31.3	34.9	7.5	45			5	25	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4753A	753A	36	34.2	37.9	7	50			5	27	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4754A	754A	39	37.2	41.5	6.5	60			5	30	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4755A	755A	43	40.9	45.6	6	70			1	32	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4756A	756A	47	44.9	49.8	5.5	80			1	35	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4757A	757A	51	48.6	54	5	95			1	38	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4758A	758A	56	53.6	58.8	4.5	110			1	42	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4759A	759A	62	58.9	65.6	4	125			1	47	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4760A	760A	68	64.6	71.7	3.7	150			1	52	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4761A	761A	75	71.2	78.8	3.3	175			1	56	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4762A	762A	82	77.9	87	3	200			1	62	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4763A	763A	91	86	96	2.8	250			1	69	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4764A	764A	100	95	105	2.5	350			1	76	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4765A	765A	110	104	116	2.3	450			1	84	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4766A	766A	120	114	127	2	550			1	91	1000	SMAF	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
1SMAF4767A	767A	135	125	142	1.9	700			1	100	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4768A	768A	150	140	157	1.7	900			1	110	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4769A	769A	165	155	172	1.6	1100			1	120	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4770A	770A	180	170	191	1.4	1200			1	135	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4771A	771A	200	189	211	1.2	1400			1	1500	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4772A	772A	220	209	231	1	1600			1	165	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4773A	773A	240	229	251	1	1800			1	180	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4774A	774A	260	249	271	1	2000			1	190	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4775A	775A	280	269	291	1	2100			1	205	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4776A	776A	300	289	315	1	2300			1	230	1000	SMAF	5%单芯
1SMAF4777A	777A	330	313	346	1	2500			1	250	1000	SMAF	5%单芯
1SMA5913B	913B	3.3	3.1	3.5	75	10			100	1	1500	SMA	5%单芯
1SMA5914B	914B	3.6	3.4	3.8	69	10			100	1	1500	SMA	5%单芯
1SMA5915B	915B	3.9	3.7	4.1	64	9			50	1	1500	SMA	5%单芯
1SMA5916B	916B	4.3	4.06	4.56	58	9			25	1	1500	SMA	5%单芯
1SMA5917B	917B	4.7	4.5	4.93	53	8			10	1	1500	SMA	5%单芯
1SMA5918B	918B	5.1	4.84	5.36	49	7			10	1	1500	SMA	5%单芯
1SMA5919B	919B	5.6	5.32	5.92	45	5			10	2	1500	SMA	5%单芯
1SMA5920B	920B	6.2	5.86	6.51	41	2			10	3	1500	SMA	5%单芯
1SMA5921B	921B	6.8	6.46	7.18	37	3.5			10	4	1500	SMA	5%单芯
1SMA5922B	922B	7.5	7.12	7.88	34	4			10	5	1500	SMA	5%单芯
1SMA5923B	923B	8.2	7.79	8.67	31	4.5			10	6	1500	SMA	5%单芯
1SMA5924B	924B	9.1	8.6	9.59	28	5			10	7	1500	SMA	5%单芯
1SMA5925B	925B	10	9.5	10.5	25	7			10	7	1500	SMA	5%单芯
1SMA5926B	926B	11	10.4	11.6	23	8			5	8	1500	SMA	5%单芯
1SMA5927B	927B	12	11.4	12.6	21	9			5	9	1500	SMA	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
1SMA5928B	928B	13	12.4	14.1	19	10			5	10	1500	SMA	5%单芯
1SMA5929B	929B	15	13.8	15.8	17	14			5	11	1500	SMA	5%单芯
1SMA5930B	930B	16	15.2	17.1	16	16			5	12	1500	SMA	5%单芯
1SMA5931B	931B	18	16.8	19.2	14	20			5	13	1500	SMA	5%单芯
1SMA5932B	932B	20	19	21.2	13	22			5	15	1500	SMA	5%单芯
1SMA5933B	933B	22	20.8	23.3	12	23			5	17	1500	SMA	5%单芯
1SMA5934B	934B	24	22.8	26	11	25			5	18	1500	SMA	5%单芯
1SMA5935B	935B	27	25.3	28.9	9.5	35			5	21	1500	SMA	5%单芯
1SMA5936B	936B	30	28.2	32	8.5	40			5	23	1500	SMA	5%单芯
1SMA5937B	937B	33	31.3	34.9	7.5	45			5	25	1500	SMA	5%单芯
1SMA5938B	938B	36	34.2	37.9	7	50			5	27	1500	SMA	5%单芯
1SMA5939B	939B	39	37.2	41.5	6.5	60			5	30	1500	SMA	5%单芯
1SMA5940B	940B	43	40.9	45.6	6	70			1	32	1500	SMA	5%单芯
1SMA5941B	941B	47	44.9	49.8	5.5	80			1	35	1500	SMA	5%单芯
1SMA5942B	942B	51	48.6	54	5	95			1	38	1500	SMA	5%单芯
1SMA5943B	943B	56	53.6	58.8	4.5	110			1	42	1500	SMA	5%单芯
1SMA5944B	944B	62	58.9	65.6	4	125			1	47	1500	SMA	5%单芯
1SMA5945B	945B	68	64.6	71.7	3.7	150			1	52	1500	SMA	5%单芯
1SMA5946B	946B	75	71.2	78.8	3.3	175			1	56	1500	SMA	5%单芯
1SMA5947B	947B	82	77.9	87	3	200			1	62	1500	SMA	5%单芯
1SMA5948B	948B	91	86	96	2.8	250			1	69	1500	SMA	5%单芯
1SMA5949B	949B	100	95	105	2.5	350			1	76	1500	SMA	5%单芯
1SMA5950B	950B	110	104	116	2.3	450			1	84	1500	SMA	5%单芯
1SMA5951B	951B	120	114	127	2	550			1	91	1500	SMA	5%单芯
1SMA5952B	952B	135	125	142	1.9	700			1	100	1500	SMA	5%单芯
1SMA5953B	953B	150	140	157	1.7	900			1	110	1500	SMA	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
1SMA5954B	954B	165	155	172	1.6	1000			1	120	1500	SMA	5%单芯
1SMA5955B	955B	180	170	191	1.4	1100			1	135	1500	SMA	5%单芯
1SMA5956B	956B	200	189	211	1.2	1200			1	150	1500	SMA	5%单芯
1SMA5957B	957B	240	228	252	1.2	1400			1	185	1500	SMA	5%单芯
SMB5913B	913B	3.3	3.1	3.5	75	10			100	1	2000	SMB	5%单芯
SMB5914B	914B	3.6	3.4	3.8	69	10			100	1	2000	SMB	5%单芯
SMB5915B	915B	3.9	3.7	4.1	64	9			50	1	2000	SMB	5%单芯
SMB5916B	916B	4.3	4.06	4.56	58	9			25	1	2000	SMB	5%单芯
SMB5917B	917B	4.7	4.5	4.93	53	8			10	1	2000	SMB	5%单芯
SMB5918B	918B	5.1	4.84	5.36	49	7			10	1	2000	SMB	5%单芯
SMB5919B	919B	5.6	5.32	5.92	45	5			10	2	2000	SMB	5%单芯
SMB5920B	920B	6.2	5.86	6.51	41	2			10	3	2000	SMB	5%单芯
SMB5921B	921B	6.8	6.46	7.18	37	3.5			10	4	2000	SMB	5%单芯
SMB5922B	922B	7.5	7.12	7.88	34	4			10	5	2000	SMB	5%单芯
SMB5923B	923B	8.2	7.79	8.67	31	4.5			10	6	2000	SMB	5%单芯
SMB5924B	924B	9.1	8.6	9.59	28	5			10	7	2000	SMB	5%单芯
SMB5925B	925B	10	9.5	10.5	25	7			10	7	2000	SMB	5%单芯
SMB5926B	926B	11	10.4	11.6	23	8			5	8	2000	SMB	5%单芯
SMB5927B	927B	12	11.4	12.6	21	9			5	9	2000	SMB	5%单芯
SMB5928B	928B	13	12.4	14.1	19	10			5	10	2000	SMB	5%单芯
SMB5929B	929B	15	13.8	15.8	17	14			5	11	2000	SMB	5%单芯
SMB5930B	930B	16	15.2	17.1	16	16			5	12	2000	SMB	5%单芯
SMB5931B	931B	18	16.8	19.2	14	20			5	13	2000	SMB	5%单芯
SMB5932B	932B	20	19	21.2	13	22			5	15	2000	SMB	5%单芯
SMB5933B	933B	22	20.8	23.3	12	23			5	17	2000	SMB	5%单芯
SMB5934B	934B	24	22.8	26	11	25			5	18	2000	SMB	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
SMB5935B	935B	27	25.3	28.9	9.5	35			5	21	2000	SMB	5%单芯
SMB5936B	936B	30	28.2	32	8.5	40			5	23	2000	SMB	5%单芯
SMB5937B	937B	33	31.3	34.9	7.5	45			5	25	2000	SMB	5%单芯
SMB5938B	938B	36	34.2	37.9	7	50			5	27	2000	SMB	5%单芯
SMB5939B	939B	39	37.2	41.5	6.5	60			5	30	2000	SMB	5%单芯
SMB5940B	940B	43	40.9	45.6	6	70			1	32	2000	SMB	5%单芯
SMB5941B	941B	47	44.9	49.8	5.5	80			1	35	2000	SMB	5%单芯
SMB5942B	942B	51	48.6	54	5	95			1	38	2000	SMB	5%单芯
SMB5943B	943B	56	53.6	58.8	4.5	110			1	42	2000	SMB	5%单芯
SMB5944B	944B	62	58.9	65.6	4	125			1	47	2000	SMB	5%单芯
SMB5945B	945B	68	64.6	71.7	3.7	150			1	52	2000	SMB	5%单芯
SMB5946B	946B	75	71.2	78.8	3.3	175			1	56	2000	SMB	5%单芯
SMB5947B	947B	82	77.9	87	3	200			1	62	2000	SMB	5%单芯
SMB5948B	948B	91	86	96	2.8	250			1	69	2000	SMB	5%单芯
SMB5949B	949B	100	95	105	2.5	350			1	76	2000	SMB	5%单芯
SMB5950B	950B	110	104	116	2.3	450			1	84	2000	SMB	5%单芯
SMB5951B	951B	120	114	127	2	550			1	91	2000	SMB	5%单芯
SMB5952B	952B	135	125	142	1.9	700			1	100	2000	SMB	5%单芯
SMB5953B	953B	150	140	157	1.7	900			1	110	2000	SMB	5%单芯
SMB5954B	954B	165	155	172	1.6	1000			1	120	2000	SMB	5%单芯
SMB5955B	955B	180	170	191	1.4	1100			1	135	2000	SMB	5%单芯
SMB5956B	956B	200	189	211	1.2	1200			1	150	2000	SMB	5%单芯
SMBZ5913B	913B	3.3	3.1	3.5	75	10			100	1	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5914B	914B	3.6	3.4	3.8	69	10			100	1	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5915B	915B	3.9	3.7	4.1	64	9			50	1	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5916B	916B	4.3	4.06	4.56	58	9			25	1	3000	SMB	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
SMBZ5917B	917B	4.7	4.5	4.93	53	8			10	1	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5918B	918B	5.1	4.84	5.36	49	7			10	1	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5919B	919B	5.6	5.32	5.92	45	5			10	2	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5920B	920B	6.2	5.86	6.51	41	2			10	3	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5921B	921B	6.8	6.46	7.18	37	3.5			10	4	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5922B	922B	7.5	7.12	7.88	34	4			10	5	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5923B	923B	8.2	7.79	8.67	31	4.5			10	6	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5924B	924B	9.1	8.6	9.59	28	5			10	7	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5925B	925B	10	9.5	10.5	25	7			10	7	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5926B	926B	11	10.4	11.6	23	8			5	8	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5927B	927B	12	11.4	12.6	21	9			5	9	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5928B	928B	13	12.4	14.1	19	10			5	10	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5929B	929B	15	13.8	15.8	17	14			5	11	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5930B	930B	16	15.2	17.1	16	16			5	12	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5931B	931B	18	16.8	19.2	14	20			5	13	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5932B	932B	20	19	21.2	13	22			5	15	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5933B	933B	22	20.8	23.3	12	23			5	17	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5934B	934B	24	22.8	26	11	25			5	18	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5935B	935B	27	25.3	28.9	9.5	35			5	21	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5936B	936B	30	28.2	32	8.5	40			5	23	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5937B	937B	33	31.3	34.9	7.5	45			5	25	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5938B	938B	36	34.2	37.9	7	50			5	27	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5939B	939B	39	37.2	41.5	6.5	60			5	30	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5940B	940B	43	40.9	45.6	6	70			1	32	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5941B	941B	47	44.9	49.8	5.5	80			1	35	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5942B	942B	51	48.6	54	5	95			1	38	3000	SMB	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
SMBZ5943B	943B	56	53.6	58.8	4.5	110			1	42	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5944B	944B	62	58.9	65.6	4	125			1	47	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5945B	945B	68	64.6	71.7	3.7	150			1	52	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5946B	946B	75	71.2	78.8	3.3	175			1	56	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5947B	947B	82	77.9	87	3	200			1	62	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5948B	948B	91	86	96	2.8	250			1	69	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5949B	949B	100	95	105	2.5	350			1	76	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5950B	950B	110	104	116	2.3	450			1	84	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5951B	951B	120	114	127	2	550			1	91	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5952B	952B	135	125	142	1.9	700			1	100	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5953B	953B	150	140	157	1.7	900			1	110	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5954B	954B	165	155	172	1.6	1000			1	120	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5955B	955B	180	170	191	1.4	1100			1	135	3000	SMB	5%单芯
SMBZ5956B	956B	200	189	211	1.2	1200		IZM(mA)	1	150	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z3.3A	3H0	3.3	3.14	3.47	227	10	500	817	100	1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z3.6A	3H1	3.6	3.42	3.78	208	9	500	749	100	1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z3.9A	3H2	3.9	3.71	4.1	192	4.5	400	691	100	1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z4.3A	3H3	4.3	4.09	4.52	174	4.5	400	627	50	1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z4.7A	3H4	4.7	4.47	4.94	160	4	500	573	50	1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z5.1A	3H5	5.1	4.85	5.36	147	3.5	550	528	10	1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z5.6A	3H6	5.6	5.32	5.88	134	2.5	600	481	10	2	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z6.2A	3A0	6.2	5.89	6.51	121	1.5	700	435	10	3	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z6.8A	3A1	6.8	6.46	7.14	110	2	700	393	10	4	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z7.5A	3A2	7.5	7.13	7.88	100	2	700	360	10	5	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z8.2A	3A3	8.2	7.79	8.61	91	2.3	700	330	10	6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z9.1A	3A4	9.1	8.65	9.56	82	2.5	700	297	10	7	3000	SMB	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
SMB3Z10A	3A5	10	9.5	10.5	75	3.5	700	270	10	7.6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z11A	3A6	11	10.45	11.55	68	4	700	225	0.5	8.4	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z12A	3A7	12	11.4	12.6	63	4.5	700	246	0.5	9.1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z13A	3A8	13	12.35	13.65	58	4.5	700	208	0.5	9.9	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z14A	3A9	14	13.3	14.7	53	5	700	193	0.5	10.6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z15A	3B0	15	14.25	15.75	50	5.5	700	180	0.5	11.4	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z16A	3B1	16	15.2	16.8	47	5.5	700	169	0.5	12.2	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z17A	3B2	17	16.15	17.85	44	6	750	159	0.5	13	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z18A	3B3	18	17.1	18.9	42	6	750	150	0.5	13.7	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z19A	3B4	19	18.05	19.95	40	7	750	142	0.5	14.4	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z20A	3B5	20	19	21	37	7	750	135	0.5	15.2	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z22A	3B6	22	20.9	23.1	34	8	750	123	0.5	16.7	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z24A	3B7	24	22.8	25.2	31	9	750	112	0.5	18.2	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z27A	3B8	27	25.65	28.35	28	10	750	100	0.5	20.6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z30A	3B9	30	28.5	31.5	25	16	1000	90	0.5	22.5	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z33A	3C0	33	31.35	34.65	23	20	1000	82	0.5	25.1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z36A	3C1	36	34.2	37.8	21	22	1000	75	0.5	27.4	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z39A	3C2	39	37.05	40.95	19	28	1000	69	0.5	29.7	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z43A	3C3	43	40.85	45.15	17	33	1500	63	0.5	32.7	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z47A	3C4	47	44.65	49.35	16	38	1500	57	0.5	35.6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z51A	3C5	51	48.45	53.55	15	45	1500	53	0.5	38.8	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z56A	3C6	56	53.2	58.8	13	50	2000	48	0.5	42.6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z62A	3C7	62	58.9	65.1	12	55	2000	44	0.5	47.1	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z68A	3C8	68	64.6	71.4	11	70	2000	40	0.5	51.7	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z75A	3C9	75	71.25	78.75	10	85	2000	36	0.5	56	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z82A	3F0	82	77.9	86.1	9.1	95	3000	33	0.5	62.2	3000	SMB	5%单芯

稳压二极管

型号	印字	稳压值Vz@Iz (V)				阻抗(Ω)			漏电流(μA)		功耗	封装	特点
Type	Marking	典型值	最小值	最大值	IZ(mA)	ZZ@IZ	ZZK@IZK	IZK(mA)	IR	@VR(V)	PD(mW)	Package	Feature
SMB3Z91A	3F1	91	86.45	95.55	8.2	115	3000	30	0.5	69.2	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z100A	3F2	100	95	105	7.5	160	3000	27	0.5	76	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z110A	3F3	110	104.5	115.5	6.8	225	4000	25	0.5	83.6	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z120A	3F4	120	114	126	6.3	300	4500	22	0.5	91.2	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z130A	3F5	130	123.5	136.5	5.8	375	5000	21	0.5	98.8	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z140A	3F6	140	133	147	5.3	475	5000	19	0.5	106	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z150A	3F7	150	142.5	157.5	5	550	6000	18	0.5	114	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z160A	3F8	160	152	168	4.7	625	6500	17	0.5	122	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z170A	3F9	170	161.5	178.5	4.4	650	7000	16	0.5	130	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z180A	3G1	180	171	189	4.2	700	7000	15	0.5	137	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z190A	3G2	190	180.5	199.5	4	800	8000	14	0.5	145	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z200A	3G3	200	190	210	3.7	875	8000	13	0.5	152	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z210A	3G4	210	199.5	220.5	3.5	950	8300	12.3	0.5	169	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z220A	3G5	220	209	231	3.3	1600	8500	11.6	0.5	178	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z230A	3G6	230	218.5	241.5	3.1	2000	9000	10.9	0.5	186	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z240A	3G7	240	228	252	2.9	2500	9000	10.2	0.5	195	3000	SMB	5%单芯
SMB3Z250A	3G8	250	237.5	262.5	2.7	3000	9500	9.5	0.5	205	3000	SMB	5%单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
BAS40	43	0.6	225	200	40	0.38	0.2	SOT-23	单芯
BAS40-04	44	0.6	200	200	40	0.38	0.2	SOT-23	串联
BAS40-05	45	0.6	200	200	40	0.38	0.2	SOT-23	共阴
BAS40-06	46	0.6	200	200	40	0.38	0.2	SOT-23	共阳
BAS70	73	0.1	200	70	70	0.41	0.1	SOT-23	单芯
BAS70-04	74	0.1	200	70	70	0.41	0.1	SOT-23	串联
BAS70-05	75	0.1	200	70	70	0.41	0.1	SOT-23	共阴
BAS70-06	76	0.1	200	70	70	0.41	0.1	SOT-23	共阳
BAT54	KL1	0.6	200	200	30	0.8	2	SOT-23	单芯
BAT54A	KL2	0.6	200	200	30	0.8	2	SOT-23	共阳
BAT54C	KL3	0.6	200	200	30	0.8	2	SOT-23	共阴
BAT54S	KL4	0.6	200	200	30	0.8	2	SOT-23	串联
BAT54TW	KL5/L4	0.6	200	200	30	1	2	SOT-323	单芯
BAT54AW	KL6/L42	0.6	200	200	30	1	2	SOT-323	共阳
BAT54CW	KL7/L43	0.6	200	200	30	1	2	SOT-323	共阴
BAT54SW	KL8/L44	0.6	200	200	30	1	2	SOT-323	串联
B0520LW	SD	5.5	500	500	20	0.385	250	SOD-123	单芯
B0530W	SE	5.5	500	500	30	0.43	130	SOD-123	单芯
B0540W	SF	5.5	500	500	40	0.62	20	SOD-123	单芯
B1040W	SZ		350	1000	40	0.55	50	SOD-123	单芯
B5817W	SJ	25	250	1000	20	0.45	50	SOD-123	单芯
B5818W	SK	25	250	1000	30	0.5	50	SOD-123	单芯
B5819W	SL	25	250	1000	40	0.55	50	SOD-123	单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
BAT42W	S7	0.5	500	200	30	1	0.5	SOD-123	单芯
BAT43W	S8	0.5	500	200	40	1	0.5	SOD-123	单芯
BAT46W	S9	0.35	500	150	100	1	2	SOD-123	单芯
BAT54W	L9	0.35	500	200	30	1	2	SOD-123	单芯
MBR0520	R2	5.5	410	500	20	0.45	80	SOD-123	单芯
MBR0530	R3	5.5	410	500	30	0.55	80	SOD-123	单芯
MBR0540	R4	5.5	410	500	40	0.55	80	SOD-123	单芯
MBR0560	R6	5.5	410	500	60	0.7	80	SOD-123	单芯
MBR0580	R8	5.5	410	500	80	0.8	80	SOD-123	单芯
RB160M-30	73		450	1000	30	0.48	50	SOD-123	单芯
RB160M-40	74		350	1000	40	0.51	30	SOD-123	单芯
RB160M-60	76		350	1000	60	0.58	30	SOD-123	单芯
SD101AW	S1	0.2	400	15	60	1	0.2	SOD-123	单芯
SD101BW	S2	0.2	400	15	50	0.95	0.2	SOD-123	单芯
SD101CW	S3	0.2	400	15	40	0.9	0.2	SOD-123	单芯
SD103AW	S4	2	400	350	40	0.6	5	SOD-123	单芯
SD103BW	S5	2	400	350	30	0.6	5	SOD-123	单芯
SD103CW	S6	2	400	350	20	0.6	5	SOD-123	单芯
B0530WS	SE		200	500	30	0.45	500	SOD-323	单芯
B0540WS	SF		200	500	40	0.62	20	SOD-323	单芯
B1040WS	SZ		250	1000	40	0.55	50	SOD-323	单芯
B16WS	B16		300	1000	60	0.7	20	SOD-323	单芯
B110WS	B110		300	1000	100	0.85	20	SOD-323	单芯

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
B5817WS	SJ	9	250	1000	20	0.45	1000	SOD-323	单芯
B5818WS	SK	9	250	1000	30	0.55	1000	SOD-323	单芯
B5819WS	SL	9	250	1000	40	0.6	1000	SOD-323	单芯
BAS40WS	43	0.6	200	200	40	1	0.2	SOD-323	单芯
BAS70WS	K73	0.1	200	70	70	1	0.1	SOD-323	单芯
BAT42WS	S7	0.5	200	200	30	0.65	0.5	SOD-323	单芯
BAT43WS	S8	0.5	200	200	30	0.65	0.5	SOD-323	单芯
BAT46WS	S9	0.75	200	150	100	1	2	SOD-323	单芯
BAT54WS	L9	0.6	200	100	30	1	2	SOD-323	单芯
MBRX0520	2.	5	250	500	20	0.45	80	SOD-323	单芯
MBRX0530	3.	5	250	500	30	0.55	80	SOD-323	单芯
MBRX0540	4.	5	250	500	40	0.55	80	SOD-323	单芯
MBRX0560	6.	5	250	500	60	0.7	80	SOD-323	单芯
RB500V-40	2		200	100	40	0.45	1	SOD-323	单芯
RB501V-40	4		200	100	40	0.55	30	SOD-323	单芯
RB550V-30	SS		200	1000	30	0.52	30	SOD-323	单芯
RB551V-30	D		200	500	30	0.47	100	SOD-323	单芯
RB551V-40	D4		200	500	40	0.47	100	SOD-323	单芯
RB751V-40	5		200	30	40	0.37	0.5	SOD-323	单芯
SD101AWS	S1	2	200	15	60	1	0.2	SOD-323	单芯
SD101BWS	S2	2	200	15	50	0.95	0.2	SOD-323	单芯
SD101CWS	S3	2	200	15	40	0.9	0.2	SOD-323	单芯
SD103AWS	S4	2	200	350	40	0.6	50	SOD-323	单芯

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SD103BWS	S5	2	200	350	30	0.6	5	SOD-323	单芯
SD103CWS	S6	2	200	350	20	0.6	5	SOD-323	单芯
BAT54X	JV	0.6	150	200	30	1	2	SOD-523	单芯
RB520S-30	B	1	150	200	30	0.6	1	SOD-523	单芯
RB520S-40	D1	1	150	200	40	0.55	10	SOD-523	单芯
RB521S-30	C	1	150	200	30	0.5	1	SOD-523	单芯
RB521S-40	S	1	150	200	40	0.41~0.54	90	SOD-523	单芯
RB751S-40	5	0.2	150	30	40	0.37	0.5	SOD-523	单芯
SD103AWT	S4	2	150	350	40	0.6	5	SOD-523	单芯
SD103BWT	S5	2	150	350	30	0.6	5	SOD-523	单芯
SD103CWT	S6	2	150	350	20	0.6	5	SOD-523	单芯
DSK12W	K12	25	1000	1000	20	0.55	300	SOD-123FL	单芯
DSK14W	K14	25	1000	1000	40	0.55	300	SOD-123FL	单芯
DSK16W	K16	25	1000	1000	60	0.7	300	SOD-123FL	单芯
DSK18W	K18	25	1000	1000	80	0.7	300	SOD-123FL	单芯
DSK110W	K110	25	1000	1000	100	0.85	200	SOD-123FL	单芯
DSK115W	K115	25	1000	1000	150	0.9	100	SOD-123FL	单芯
DSK120W	K120	25	1000	1000	200	0.9	100	SOD-123FL	单芯
K12	K12	30	1000	1000	20	0.55	300	SOD-123FL	单芯
K14	K14	30	1000	1000	40	0.55	300	SOD-123FL	单芯
K16	K16	30	1000	1000	60	0.7	300	SOD-123FL	单芯
K18	K18	30	1000	1000	80	0.7	300	SOD-123FL	单芯
K110	K110	30	1000	1000	100	0.85	200	SOD-123FL	单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
K115	K115	50	1000	1000	150	0.92	100	SOD-123FL	单芯
K120	K120	50	1000	1000	200	0.92	100	SOD-123FL	单芯
DSK22W	K22	50	1500	2000	20	0.55	500	SOD-123FL	单芯
DSK24W	K24	50	1500	2000	40	0.55	500	SOD-123FL	单芯
DSK26W	K26	50	1500	2000	60	0.7	500	SOD-123FL	单芯
DSK28W	K28	50	1500	2000	80	0.7	300	SOD-123FL	单芯
DSK210W	K210	50	1500	2000	100	0.85	300	SOD-123FL	单芯
DSK215W	K215	50	1500	2000	150	0.95	300	SOD-123FL	单芯
DSK220W	K220	50	1500	2000	200	0.95	300	SOD-123FL	单芯
DSK32W	K32	80	12500	3000	20	0.55	500	SOD-123FL	单芯
DSK34W	K34	80	12500	3000	40	0.55	500	SOD-123FL	单芯
DSK36W	K36	80	12500	3000	60	0.7	300	SOD-123FL	单芯
DSK38W	K38	80	12500	3000	80	0.7	300	SOD-123FL	单芯
DSK310W	K310	80	12500	3000	100	0.85	300	SOD-123FL	单芯
DSK315W	K315	80	12500	3000	150	0.95	300	SOD-123FL	单芯
DSK320W	K320	80	12500	3000	200	0.95	300	SOD-123FL	单芯
SS12F	SS12	30	2500	1000	20	0.55	200	SMAF	单芯
SS14F	SS14	30	2500	1000	40	0.55	200	SMAF	单芯
SS16F	SS16	30	2500	1000	60	0.7	200	SMAF	单芯
SS18F	SS18	30	2500	1000	80	0.7	200	SMAF	单芯
SS110F	SS110	30	2500	1000	100	0.85	200	SMAF	单芯
SS115F	SS115	30	2500	1000	150	0.9	50	SMAF	单芯
SS120F	SS120	30	2500	1000	200	0.9	50	SMAF	单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SS12	SS12	30	2500	1000	20	0.55	100	SMA	单芯
SS14	SS14	30	2500	1000	40	0.55	100	SMA	单芯
SS16	SS16	30	2500	1000	60	0.7	100	SMA	单芯
SS18	SS18	30	2500	1000	80	0.7	20	SMA	单芯
SS110	SS110	30	2500	1000	100	0.85	20	SMA	单芯
SS115	SS115	30	2500	1000	150	0.9	50	SMA	单芯
SS120	SS120	30	2500	1000	200	0.9	50	SMA	单芯
SS22	SS22	50	1500	2000	20	0.55	100	SMA	单芯
SS24	SS24	50	1500	2000	40	0.55	100	SMA	单芯
SS26	SS26	50	1500	2000	60	0.7	100	SMA	单芯
SS28	SS28	50	1500	2000	80	0.7	20	SMA	单芯
SS210	SS210	50	1500	2000	100	0.85	20	SMA	单芯
SS215	SS215	50	1250	2000	150	0.92	20	SMA	单芯
SS220	SS220	50	1250	2000	200	0.92	20	SMA	单芯
SS22F	SS22	50	1500	2000	20	0.55	100	SMAF	单芯
SS24F	SS24	50	1500	2000	40	0.55	100	SMAF	单芯
SS26F	SS26	50	1500	2000	60	0.7	100	SMAF	单芯
SS28F	SS28	50	1500	2000	80	0.7	20	SMAF	单芯
SS210F	SS210	50	1500	2000	100	0.85	20	SMAF	单芯
SS215F	SS215	50	1250	2000	150	0.92	20	SMAF	单芯
SS220F	SS220	50	1250	2000	200	0.92	20	SMAF	单芯
SS32A	SS32	80	12500	3000	20	0.55	100	SMA	单芯
SS34A	SS34	80	12500	3000	40	0.55	100	SMA	单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SS36A	SS36	80	12500	3000	60	0.7	100	SMA	单芯
SS38A	SS38	80	12500	3000	80	0.7	20	SMA	单芯
SS310A	SS310	80	12500	3000	100	0.85	20	SMA	单芯
SS315A	SS315	80	12500	3000	150	0.95	20	SMA	单芯
SS320A	SS320	80	12500	3000	200	0.95	20	SMA	单芯
SS52A	SS52	120	12500	5000	20	0.55	100	SMA	单芯
SS54A	SS54	120	12500	5000	40	0.55	100	SMA	单芯
SS56A	SS56	120	12500	5000	60	0.7	100	SMA	单芯
SS56AQ	SS56A	120	6000	5000	60	0.7	100	SMA	车规
SS58A	SS58	120	12500	5000	80	0.7	20	SMA	单芯
SS510A	SS510	120	12500	5000	100	0.85	20	SMA	单芯
SS515A	SS515	120	12500	5000	150	0.95	50	SMA	单芯
SS520A	SS520	120	12500	5000	200	0.95	50	SMA	单芯
SS32F	SS32	80	12500	3000	20	0.55	100	SMAF	单芯
SS34F	SS34	80	12500	3000	40	0.55	100	SMAF	单芯
SS36F	SS36	80	12500	3000	60	0.7	100	SMAF	单芯
SS38F	SS38	80	12500	3000	80	0.85	20	SMAF	单芯
SS310F	SS310	80	12500	3000	100	0.85	20	SMAF	单芯
SS315F	SS315	80	15000	3000	150	0.92	20	SMAF	单芯
SS320F	SS320	80	15000	3000	200	0.92	20	SMAF	单芯
SS52F	SS52	120	12500	5000	20	0.55	100	SMAF	单芯
SS54F	SS54	120	12500	5000	40	0.55	100	SMAF	单芯
SS56F	SS56	120	12500	5000	60	0.7	100	SMAF	单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SS58F	SS58	120	12500	5000	80	0.85	20	SMAF	单芯
SS510F	SS510	120	12500	5000	100	0.85	20	SMAF	单芯
SS515F	SS515	150	15000	5000	150	0.92	20	SMAF	单芯
SS520F	SS520	150	15000	5000	200	0.92	20	SMAF	单芯
SS22B	SS22	55	1500	2000	20	0.55	100	SMB	单芯
SS24B	SS24	55	1500	2000	40	0.55	100	SMB	单芯
SS26B	SS26	55	1500	2000	60	0.7	100	SMB	单芯
SS28B	SS28	55	1500	2000	80	0.7	20	SMB	单芯
SS210B	SS210	45	1500	2000	100	0.85	20	SMB	单芯
SS215B	SS215	50	2273	2000	150	0.92	20	SMB	单芯
SS220B	SS220	50	2273	2000	200	0.92	20	SMB	单芯
SS32	SS32	100	12500	3000	20	0.55	100	SMB	单芯
SS34	SS34	100	12500	3000	40	0.55	100	SMB	单芯
SS36	SS36	100	12500	3000	60	0.7	100	SMB	单芯
SS38	SS38	100	12500	3000	80	0.7	20	SMB	单芯
SS310	SS310	100	12500	3000	100	0.85	20	SMB	单芯
SS315	SS315B	80	12500	3000	150	0.92	20	SMB	单芯
SS320	SS320B	80	12500	3000	200	0.92	20	SMB	单芯
SS52B	SS52B	150	12500	5000	20	0.55	100	SMB	单芯
SS54B	SS54B	150	12500	5000	40	0.55	100	SMB	单芯
SS56B	SS56B	150	12500	5000	60	0.7	100	SMB	单芯
SS58B	SS58B	150	12500	5000	80	0.7	20	SMB	单芯
SS510B	SS510B	150	12500	5000	100	0.85	20	SMB	单芯

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SS515B	SS515B	150	12500	5000	150	0.85	50	SMB	单芯
SS520B	SS520B	150	12500	5000	200	0.85	50	SMB	单芯
SS52BF	SS52BF	120	12500	5000	20	0.55	100	SMBF	单芯
SS54BF	SS54BF	120	12500	5000	40	0.55	100	SMBF	单芯
SS56BF	SS56BF	120	12500	5000	60	0.7	100	SMBF	单芯
SS58BF	SS58BF	120	12500	5000	80	0.85	20	SMBF	单芯
SS510BF	SS510BF	120	12500	5000	100	0.85	20	SMBF	单芯
SS515BF	SS515BF	150	12500	5000	150	0.92	20	SMBF	单芯
SS520BF	SS520BF	150	12500	5000	200	0.92	20	SMBF	单芯
SS32BF	SS32BF	80	12500	3000	20	0.55	100	SMBF	单芯
SS34BF	SS34BF	80	12500	3000	40	0.55	100	SMBF	单芯
SS36BF	SS36BF	80	12500	3000	60	0.7	100	SMBF	单芯
SS38BF	SS38BF	80	12500	3000	80	0.85	20	SMBF	单芯
SS310BF	SS310BF	80	12500	3000	100	0.85	20	SMBF	单芯
SS32C	SS32	80	12500	3000	20	0.55	100	SMC	单芯
SS34C	SS34	80	12500	3000	40	0.55	100	SMC	单芯
SS36C	SS36	80	12500	3000	60	0.7	100	SMC	单芯
SS38C	SS38	80	12500	3000	80	0.7	20	SMC	单芯
SS310C	SS310	80	12500	3000	100	0.85	20	SMC	单芯
SS315C	SS315	80	12500	3000	150	0.95	50	SMC	单芯
SS320C	SS320	80	12500	3000	200	0.95	50	SMC	单芯
SS52C	SS52	175	12500	5000	20	0.55	100	SMC	单芯
SS54C	SS54	175	12500	5000	40	0.55	100	SMC	单芯

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SS56C	SS56	175	12500	5000	60	0.7	100	SMC	单芯
SS58C	SS58	175	12500	5000	80	0.7	20	SMC	单芯
SS510C	SS510	150	12500	5000	100	0.85	20	SMC	单芯
SS515C	SS515	150	12500	5000	150	0.85	100	SMC	单芯
SS520C	SS520	150	12500	5000	200	0.85	100	SMC	单芯
SK82C	SK82	175	12500	8000	20	0.55	100	SMC	单芯
SK84C	SK84	175	12500	8000	40	0.55	100	SMC	单芯
SK86C	SK86	175	12500	8000	60	0.7	100	SMC	单芯
SK88C	SK88	175	12500	8000	80	0.7	20	SMC	单芯
SK810C	SK810	175	12500	8000	100	0.85	20	SMC	单芯
SS1045C	SS1045	175	2000	10000	45	0.55	100	SMC	单芯
SS1060C	SS1060	175	2000	10000	60	0.7	100	SMC	单芯
SS10100C	SS10100	175	2000	10000	100	0.85	20	SMC	单芯
SS10150C	SS10150	175	2000	10000	150	0.92	20	SMC	单芯
SS10200C	SS10200	175	2000	10000	200	0.92	20	SMC	单芯
MBRN4020	4020	12	600	2000	40	0.72	10	DFN1608	单芯
MBRD1045	MBRD1045	150	15625	10000	45	0.55	100	TO-252	共阴
MBRD1060	MBRD1060	150	15625	10000	60	0.7	100	TO-252	共阴
MBRD10100	MBRD10100	150	15625	10000	100	0.85	20	TO-252	共阴
MBRD10150	MBRD10150	150	15625	10000	150	0.9	20	TO-252	共阴
MBRD10200	MBRD10200	150	15625	10000	200	0.9	20	TO-252	共阴
MBRD2045	MBRD2045	175	15625	20000	45	0.55	100	TO-252	共阴
MBRD2060	MBRD2060	175	15625	20000	60	0.7	100	TO-252	共阴

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
MBRD20100	MBRD20100	175	15625	20000	100	0.85	20	TO-252	共阴
MBRD20150	MBRD20150	175	15625	20000	150	0.9	20	TO-252	共阴
MBRD20200	MBRD20200	175	15625	20000	200	0.9	20	TO-252	共阴
SB1045L.	1045L.	150	2080	10000	45	0.53	150	TO-277	单芯
SB1045L	1045L	180	2080	10000	45	0.48	150	TO-277	单芯
SB10100L		150	2080	10000	100	0.7	100	TO-277	单芯
DSL14W	SL14	30		1000	40	0.45	200	SOD-123FL	低压降
DSL16W	SL16	30		1000	60	0.5	200	SOD-123FL	低压降
DSL24W	SL24	50		2000	40	0.45	500	SOD-123FL	低压降
DSL26W	SL26	50		2000	60	0.5	300	SOD-123FL	低压降
SSL12F	SSL12	30		1000	20	0.45	300	SMAF	低压降
SSL14F	SSL14	30		1000	40	0.45	200	SMAF	低压降
SSL16F	SSL16	30		1000	60	0.5	200	SMAF	低压降
SSL24F	SSL24	50		2000	40	0.45	500	SMAF	低压降
SSL26F	SSL26	50		2000	60	0.52	300	SMAF	低压降
SSL210F	SSL210	50		2000	100	0.6	300	SMAF	低压降
SSL34F	SSL34	80		3000	40	0.45	300	SMAF	低压降
SSL345F	SSL345	80		3000	45	0.45	300	SMAF	低压降
SSL36F	SSL36	70		3000	60	0.5	500	SMAF	低压降
SSL310F	SSL310	100		3000	100	0.6	100	SMAF	低压降
SSL54F	SSL54	150		5000	40	0.45	1000	SMAF	低压降
SSL545F	SSL545	150		5000	45	0.45	500	SMAF	低压降
SSL55F	SSL55	150		5000	50	0.53	150	SMAF	低压降

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SSL56F	SSL56	150		5000	60	0.5	1000	SMAF	低压降
SSL510F	SSL510	150		5000	100	0.6	1000	SMAF	低压降
SSL550F	SSL550	150		5000	50	0.5	1000	SMAF	低压降
SSL24BF	SSL24B	50		2000	40	0.45	500	SMBF	低压降
SSL210BF	SSL210B	50		2000	100	0.6	300	SMBF	低压降
SSL34BF	SSL34B	80		3000	40	0.45	300	SMBF	低压降
SSL345BF	SSL345B	80		3000	45	0.45	500	SMBF	低压降
SSL310BF	SSL310B	80		3000	100	0.6	100	SMBF	低压降
SSL510BF	SSL510B	150		5000	100	0.6	1000	SMBF	低压降
SS510BFL	SS510BL	120		5000	100	0.67	100	SMBF	低压降
SSL54BF	SSL54B	130		5000	40	0.45	300	SMBF	低压降
SSL545BF	SSL545B	150		5000	45	0.43	500	SMBF	低压降
SSL56BF	SSL56B	150		5000	60	0.5	1000	SMBF	低压降
SSL24	SSL24	50		2000	40	0.45	500	SMA	低压降
SS24L	SS24L	50		2000	40	0.46	200	SMA	低压降
SSL26	SSL26	50		2000	60	0.52	300	SMA	低压降
SS26L	SS26L	50		2000	60	0.55	150	SMA	低压降
SSL34	SSL34	80		3000	40	0.45	300	SMA	低压降
SS34L	SS34L	80		3000	40	0.46	200	SMA	低压降
SSL345	SSL345	80		3000	45	0.45	300	SMA	低压降
SS36L	SS36L	80		3000	60	0.55	150	SMA	低压降
SSL36	SSL36	80		3000	60	0.5	300	SMA	低压降
SSL54	SSL54	150		5000	40	0.45	1000	SMA	低压降

肖特基二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
SSL510	SSL510	150		5000	100	0.6	1000	SMA	低压降
SSL24B	SSL24	50		2000	40	0.45	500	SMB	低压降
SSL26B	SSL26	50		2000	60	0.5	500	SMB	低压降
SSL210B	SSL210	50		2000	100	0.6	1000	SMB	低压降
SSL34B	SSL34	80		3000	40	0.45	300	SMB	低压降
SSL36B	SSL36	70		3000	60	0.5	500	SMB	低压降
SSL310B	SSL310	80		3000	100	0.6	300	SMB	低压降
SSL54B	SSL54	150		5000	40	0.45	1000	SMB	低压降
SSL545B	SSL545	150		5000	45	0.45	1000	SMB	低压降
SSL56B	SSL56	150		5000	60	0.5	1000	SMB	低压降
SSL510B	SSL510	150		5000	100	0.6	1000	SMB	低压降
SSL34C	SSL34	80		3000	40	0.45	300	SMC	低压降
SSL36C	SSL36	80		3000	60	0.5	300	SMC	低压降
SSL310C	SSL310	80		3000	100	0.6	300	SMC	低压降
SSL54C	SSL54	150		5000	40	0.45	500	SMC	低压降
SSL56C	SSL56	150		5000	60	0.5	500	SMC	低压降
SSL510C	SSL510	150		5000	100	0.6	500	SMC	低压降

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

可控硅

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	触发电流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_{TM}(V)	I_{GT}(mA)	Package	Feature
MCR100-4	100-4	8	800	500	200	1.6	0.2	SOT-23	单向可控硅
MCR100-4L	100-4	8	800	500	200	1.6	0.2	SOT-23-3L	单向可控硅
MCR100-6	100-6	8	800	500	400	1.6	0.2	SOT-23	单向可控硅
MCR100-6L	100-6	8	800	500	400	1.6	0.2	SOT-23-3L	单向可控硅
MCR100-8	100-8	8	800	500	600	1.6	0.2	SOT-23	单向可控硅
MCR100-8L	100-8	8	800	500	600	1.6	0.2	SOT-23-3L	单向可控硅
PCR406	406	6	800	600	400	1.7	0.15	SOT-23	单向可控硅
BT169-400	BT169-400	8	800	800	400	1.6	0.2	SOT-23	单向可控硅
BT169-400L	BT169-400	8	800	800	400	1.6	0.2	SOT-23-3L	单向可控硅
BT136S-500D	BT136S-500	25	3000	4000	500	2	10	TO-252	单向可控硅
BT136S-500	BT136S-500	25	3000	4000	500	2	10	TO-251	单向可控硅
BT136S-600D	BT136S-600	25	3000	4000	600	2	10	TO-252	单向可控硅
BT136S-600	BT136S-600	25	3000	4000	600	2	10	TO-251	单向可控硅
BT136S-800D	BT136S-800	25	3000	4000	800	2	10	TO-252	单向可控硅
BT136S-800	BT136S-800	25	3000	4000	800	2	10	TO-251	单向可控硅
BT137S-500D	BT137S-500	65	5000	8000	500	2	10	TO-252	单向可控硅
BT137S-500	BT137S-500	65	5000	8000	500	2	10	TO-251	单向可控硅
BT137S-600D	BT137S-600	65	5000	8000	600	2	10	TO-252	单向可控硅
BT137S-600	BT137S-600	65	5000	8000	600	2	10	TO-251	单向可控硅
BT137S-800D	BT137S-800	65	5000	8000	800	2	10	TO-252	单向可控硅
BT137S-800	BT137S-800	65	5000	8000	800	2	10	TO-251	单向可控硅

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
1N4001WS	1A	25	3571	1000	50	1.1	5	SOD-323	普通整流
1N4004WS	4A	25	3571	1000	400	1.1	5	SOD-323	普通整流
1N4007WS	7A	25	3571	1000	1000	1.1	5	SOD-323	普通整流
1N4001W	A1	25	1565	1000	50	1.1	5	SOD-123FL	普通整流
1N4004W	A4	25	1565	1000	400	1.1	5	SOD-123FL	普通整流
1N4007W	A7	25	1565	1000	1000	1.1	5	SOD-123FL	普通整流
1N4001W	1A	25	3571	1000	50	1.1	5	SOD-123	普通整流
1N4004W	4A	25	3571	1000	400	1.1	5	SOD-123	普通整流
1N4007W	7A	25	3571	1000	1000	1.1	5	SOD-123	普通整流
DSR1A	S1A	30	1565	1000	50	1.1	5	SOD-123FL	普通整流
DSR1G	S1G	30	1565	1000	400	1.1	5	SOD-123FL	普通整流
DSR1M	S1M	30	1565	1000	1000	1.1	5	SOD-123FL	普通整流
S1AW	S1A	35	1565	1000	50	0.98	5	SOD-123FL	普通整流
S1GW	S1G	35	1565	1000	400	0.98	5	SOD-123FL	普通整流
S1MW	S1M	35	1565	1000	1000	0.98	5	SOD-123FL	普通整流
M1F	M1F	30	1500	1000	50	1.1	5	SMAF	普通整流
M4F	M4F	30	1500	1000	400	1.1	5	SMAF	普通整流
M7F	M7F	30	1500	1000	1000	1.1	5	SMAF	普通整流
S2AF	S2A	50	2660	2000	50	1.1	5	SMAF	普通整流
S2BF	S2B	50	2660	2000	100	1.1	5	SMAF	普通整流
S2DF	S2D	50	2660	2000	200	1.1	5	SMAF	普通整流
S2GF	S2G	50	2660	2000	400	1.1	5	SMAF	普通整流

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
S2JF	S2J	50	2660	2000	600	1.1	5	SMAF	普通整流
S2KF	S2K	50	2660	2000	800	1.1	5	SMAF	普通整流
S2MF	S2M	50	2660	2000	1000	1.1	5	SMAF	普通整流
1N4001 M1	M1	30	2500	1000	50	1.1	5	SMA	普通整流
1N4004 M4	M4	30	2500	1000	400	1.1	5	SMA	普通整流
1N4007 M7	M7	30	2500	1000	1000	1.1	5	SMA	普通整流
S1A	M1	30	2500	1000	50	1.1	5	SMA	普通整流
S1G	M4	30	2500	1000	400	1.1	5	SMA	普通整流
S1M	M7	30	2500	1000	1000	1.1	5	SMA	普通整流
GS1Y	GS1Y	30	1316	1500	1600	1.15	5	SMA	高压整流
GS1Z	GS1Z	30	1316	1500	2000	1.15	5	SMA	高压整流
S2ABF	S2AB	60	7813	2000	50	1.1	5	SMBF	普通整流
S2BBF	S2BB	60	7813	2000	100	1.1	5	SMBF	普通整流
S2DBF	S2DB	60	7813	2000	200	1.1	5	SMBF	普通整流
S2GBF	S2GB	60	7813	2000	400	1.1	5	SMBF	普通整流
S2JBF	S2JB	60	7813	2000	600	1.1	5	SMBF	普通整流
S2KBF	S2KB	60	7813	2000	800	1.1	5	SMBF	普通整流
S2MBF	S2MB	60	7813	2000	1000	1.1	5	SMBF	普通整流
S3ABF	S3AB	100	9615	3000	50	1.1	5	SMBF	普通整流
S3BBF	S3BB	100	9615	3000	100	1.1	5	SMBF	普通整流
S3DBF	S3DB	100	9615	3000	200	1.1	5	SMBF	普通整流
S3GBF	S3GB	100	9615	3000	400	1.1	5	SMBF	普通整流

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
S3JBF	S3JB	100	9615	3000	600	1.1	5	SMBF	普通整流
S3KBF	S3KB	100	9615	3000	800	1.1	5	SMBF	普通整流
S3MBF	S3MB	100	9615	3000	1000	1.1	5	SMBF	普通整流
S2AA	S2A	50	2660	2000	50	1.1	1	SMA	普通整流
S2BA	S2B	50	2660	2000	100	1.1	1	SMA	普通整流
S2DA	S2D	50	2660	2000	200	1.1	1	SMA	普通整流
S2GA	S2G	50	2660	2000	400	1.1	1	SMA	普通整流
S2JA	S2J	50	2660	2000	600	1.1	1	SMA	普通整流
S2KA	S2K	50	2660	2000	800	1.1	1	SMA	普通整流
S2MA	S2M	50	2660	2000	1000	1.1	1	SMA	普通整流
S2A	S2A	60	7813	2000	50	1.1	5	SMB	普通整流
S2B	S2B	60	7813	2000	100	1.1	5	SMB	普通整流
S2D	S2D	60	7813	2000	200	1.1	5	SMB	普通整流
S2G	S2G	60	7813	2000	400	1.1	5	SMB	普通整流
S2J	S2J	60	7813	2000	600	1.1	5	SMB	普通整流
S2K	S2K	60	7813	2000	800	1.1	5	SMB	普通整流
S2M	S2M	60	7813	2000	1000	1.1	5	SMB	普通整流
S3AB	S3A	100	9615	3000	50	1.1	5	SMB	普通整流
S3BB	S3B	100	9615	3000	100	1.1	5	SMB	普通整流
S3DB	S3D	100	9615	3000	200	1.1	5	SMB	普通整流
S3GB	S3G	100	9615	3000	400	1.1	5	SMB	普通整流
S3JB	S3J	100	9615	3000	600	1.1	5	SMB	普通整流

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
S3KB	S3K	100	9615	3000	800	1.1	5	SMB	普通整流
S3MB	S3M	100	9615	3000	1000	1.1	5	SMB	普通整流
S5AB	S5A	120	9615	5000	50	1.1	5	SMB	普通整流
S5BB	S5B	120	9615	5000	100	1.1	5	SMB	普通整流
S5DB	S5D	120	9615	5000	200	1.1	5	SMB	普通整流
S5GB	S5G	120	9615	5000	400	1.1	5	SMB	普通整流
S5JB	S5J	120	9615	5000	600	1.1	5	SMB	普通整流
S5KB	S5K	120	9615	5000	800	1.1	5	SMB	普通整流
S5MB	S5M	120	9615	5000	1000	1.1	5	SMB	普通整流
S5AC	S5A	120	9615	5000	50	1.1	5	SMC	普通整流
S5BC	S5B	120	9615	5000	100	1.1	5	SMC	普通整流
S5DC	S5D	120	9615	5000	200	1.1	5	SMC	普通整流
S5GC	S5G	120	9615	5000	400	1.1	5	SMC	普通整流
S5JC	S5J	120	9615	5000	600	1.1	5	SMC	普通整流
S5KC	S5K	120	9615	5000	800	1.1	5	SMC	普通整流
S5MC	S5M	120	9615	5000	1000	1.1	5	SMC	普通整流
S3AC	S3A	100	9615	3000	50	1.1	5	SMC	普通整流
S3BC	S3B	100	9615	3000	100	1.1	5	SMC	普通整流
S3DC	S3D	100	9615	3000	200	1.1	5	SMC	普通整流
S3GC	S3G	100	9615	3000	400	1.1	5	SMC	普通整流
S3JC	S3J	100	9615	3000	600	1.1	5	SMC	普通整流
S3KC	S3K	100	9615	3000	800	1.1	5	SMC	普通整流

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流二极管

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
S3MC	S3M	100	9615	3000	1000	1.1	5	SMC	普通整流
1N4001	4001	30	2500	1000	50	1	5	DO-41	普通整流
1N4002	4002	30	2500	1000	100	1	5	DO-41	普通整流
1N4003	4003	30	2500	1000	200	1	5	DO-41	普通整流
1N4004	4004	30	2500	1000	400	1	5	DO-41	普通整流
1N4005	4005	30	2500	1000	600	1	5	DO-41	普通整流
1N4006	4006	30	2500	1000	800	1	5	DO-41	普通整流
1N4007	4007	30	2500	1000	1000	1	5	DO-41	普通整流

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSHC3D15V1U	15	16.5	20	80	400	1横+TDN	SOD-323		
FSLC3D3V1B	3.3	4.5	8.5	19	0.8	CC	SOD-323		
FSLC3D3V1BA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	CC/3B	SOD-323	GBLC03C-N	BORN伯恩半导体
FSLC3D3V1BA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	CC/3C	SOD-323	RLSD32A031LC	RUILON(瑞隆源)
FSLC3D3V1BA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	CC/3C	SOD-323	UCD32C03L01	Brightking台湾君耀
FSLC3D3V1BA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	CC/3C	SOD-323	ESDSLC3V3D3B-TP	MCC(美微科)
FSLC3D3V1BB	3	3.5	8	10	0.8	CC	SOD-323		
FSLC3D3V1BC	3	3.5	8	15	1.2	CC	SOD-323		
FSLC3D3V1BD	3.3	4	12	20	1	C03	SOD-323		
FSLC3D3V1BL	3	3.8	8.5	20	1	CC	SOD-323		
FSLC3D3V1UA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	‖S3	SOD-323	CESD3V3D3	CJ（江苏长电/长晶）
FSLC3D3V1UA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	‖S3	SOD-323	ESD7351HT1G	ON(安森美)
FSLC3D3V1UA	3.3	4.5	8.5	14	0.8	‖S3	SOD-323	PESD3V3U1UA,115	Nexperia(安世)
ES05D1HA03	5	5.6	16	20	50	05C	SOD-323		
FSLC3D5V1B	5	6.5	9.5	18	0.8	AC	SOD-323		
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	ESD5V0B03-323	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	GBLC05C-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	BSD3C361V	BORN伯恩半导体
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	SESD3Z5CL	SINO-IC(光宇睿芯)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	RLSD32A051LC	RUILON(瑞隆源)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	UCD32C05L01	Brightking台湾君耀
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	UCD32C05L01-AT	Brightking台湾君耀
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	UBD32C05L01	Brightking台湾君耀
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	ESD05V32D-LC	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	PESD5V0U1BA-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	TPDESD5V0U1BA	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D5V1BA	5	6.5	9.5	12	0.8	AC/5C	SOD-323	GBLC05C	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D5V1BB	5	6.5	9.5	8	0.8	3B/LC	SOD-323		
FSLC3D5V1BC	5	6.5	8.5	6	1	AC	SOD-323		

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSLC3D5V1BD	5	8	12	20	1	C05	SOD-323		
FSLC3D8V1B	8	8.5	12	14	0.8	BC	SOD-323		
FSLC3D8V1BA	8	8.5	12	10	0.8	BC/8C	SOD-323	ESDLC8V0D3B	Yint(音特电子)
FSLC3D8V1BA	8	8.5	12	10	0.8	BC/8C	SOD-323	UCD32C08L01	Brightking(君耀)
FSLC3D12V1B	12	13.3	19	9	0.8	DC	SOD-323		
FSLC3D12V1BA	12	13.3	19	8	0.8	DC/2C	SOD-323	UCD32C12L01	Brightking(君耀)
FSLC3D12V1BA	12	13.3	19	8	0.8	DC/2C	SOD-323	CESD323LC12VB-M	CREATEK(达晶微)
FSLC3D12V1BA	12	13.3	19	8	0.8	DC/2C	SOD-323	GBLC12C-MS	MSKSEMI(美森科)
FSLC3D12V1BA	12	13.3	19	8	0.8	DC/2C	SOD-323	ESDLC12VD3B	Yint(音特电子)
FSLC3D15V1B	15	16.5	24	7	0.8	EC	SOD-323		
FSLC3D15V1BA	15	16.5	24	6	0.8	EC	SOD-323	UDD32C15L01	Brightking(君耀)
FSLC3D15V1BA	15	16.5	24	6	0.8	EC	SOD-323	UCD32C15L01	Brightking(君耀)
FSLC3D18V1B	18	20	30	6	0.8	FC	SOD-323		
FSLC3D24V1B	24	26	34	5	0.8	HC	SOD-323		
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	SDD32C24L01	Brightking(君耀)
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	UDD32C24L01	Brightking(君耀)
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	SELC24CI	SEMIWARE(赛米微尔)
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	TPE32C24L01	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	PDYL240B-SOD323	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	RLSD32A241LC	RUILON(瑞隆源)
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	GBLC24C	Protek Devices
FSLC3D24V1BA	24	26	34	3	0.8	HC	SOD-323	UCD32C24L01	Brightking(君耀)
FSLC3D36V1B	36	38	55	3	0.8	KC	SOD-323		
FSLC3D5V1UA	5	6.5	9.5	12	0.8	2横+S5	SOD-323		
FSLC3D8V1UA	8	8.5	12	10	0.8	2横+S8	SOD-323		
FSLC3D12V1UA	12	13.3	19	8	0.8	2横+S12	SOD-323		
FSLC3D15V1UA	15	16.5/26	24	6	0.8	2横+S15	SOD-323		
FSLC3D24V1UA	24	26	34	3	0.8	2横+S24	SOD-323		
FSNC3D3V1U	3.3	4.5	19	24	300	1横+03W	SOD-323	SD05T1G	ON(安森美)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC3D3V1U	3.3	4.5	19	24	300	1横+03W	SOD-323	BSD3A031V	BORN伯恩半导体
FSNC3D3V1UA	3.3	4.5	8	25	200	1横+03W	SOD-323		
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	CESD5V0D3	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	SDD32A05L01	Brightking(君耀)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	LESD3Z5.0T1G	LRC(乐山无线电)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	SESD3Z5V	SINO-IC(光宇睿芯)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	RLSD32A051V	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	ESD3Z5.0	AnBon(台湾安邦)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	SD05.TCT	UMW(友台半导体)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	CESD323NC5VU-M	CREATEK(达晶微)
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	BSD3A051V	BORN伯恩半导体
FSNC3D5V1U	5	6.5	20	20	300	1横+05W	SOD-323	PESDNC3D5VU	Prisemi 芯导
FSNC3D5V1UA	5	5.5	15	30	300	1横+05W	SOD-323		
FSNC3D5V1UB	5	5.5	8	80	660	1横+HU	SOD-323		
FSNC3D5V1UC	5	7	11	110	850	1横+HU	SOD-323		
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	CESD12VD3 ZC	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	SD12T1G	ON(安森美)
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	RLSD32A121V	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	SESD3Z12V	SINO-IC(光宇睿芯)
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	ESD12VD3-TP	MCC(美微科)
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	SDD32A12L01	Brightking(君耀)
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	CESD323NC12VU-M	CREATEK(达晶微)
FSNC3D12V1U	12	13.3	33	12	150	1横+12W	SOD-323	PJSD12W	PANJIT(强茂)
FSNC3D15V1U	15	16.5	50	9	120	1横+15W	SOD-323	RLSD32A151V	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D15V1U	15	16.5	50	9	120	1横+15W	SOD-323	PJSD15W	PANJIT(强茂)
FSNC3D24V1U	24	26	60	6	80	1横+24W	SOD-323	PJSD24W	PANJIT(强茂)
FSNC3D24V1U	24	26	60	6	80	1横+24W	SOD-323	RLSD32A241V	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D24V1U	24	26	60	6	80	1横+24W	SOD-323	SD24	Leiditech(雷卯电子)
FSNC3D36V1U	36	45	50	3	50	1横+36W	SOD-323	CESD36VD3	CJ（江苏长电/长晶）

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC3D36V1U	36	45	50	3	50	1横+36W	SOD-323	RLSD32A361V	RUILON 瑞隆源
FSNC3D36V1U	36	45	50	3	50	1横+36W	SOD-323	PJSD36W	PANJIT(强茂)
FSNC3D36V1UA	36	40	50	2.5	50	1横+36W	SOD-323		
FSNC3D3V1B	3.3	4.5	8.5	24	150	2A	SOD-323		
FSNC3D3V1BA	3.3	4.5	8.5	16	100	5横+AB	SOD-323		
FSNC3D3V1BB	3.3	3.5	8	20	60	2A	SOD-323		
FSNC3D3V1BC	3.3	3.5	8	30	60	2A	SOD-323		
FSNC3D3V1BD	3.3	3.7	7	6	15	3CW	SOD-323		
FSNC3D5V1B	5	6.5	9.5	20	120	2B	SOD-323		
FSNC3D5V1BC	5	6	11	8	15	E6/H	SOD-323	CESDBLC5V0D3	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC3D5V1BC	5	6	11	8	15	E6/B5	SOD-323	ESD5V0D3B-TP	MCC(美微科)
FSNC3D5V1BC	5	6	11	8	15	E6/1K	SOD-323	PESD5V0V1BA	Nexperia(安世)
FSNC3D5V1BC	5	6	11	8	15	E6/A/V	SOD-323	DESD5V0S1BA-7	达尔-Diodes
FSNC3D5V1BB	5	6	18	16	30	5横+E6	SOD-323	PESD5V0L1BA,115	Nexperia(安世)
FSNC3D5V1BB	5	6	18	16	30	5横+E6	SOD-323	PESD5V0V1BA-N	BORN伯恩半导体
FSNC3D5V1BB	5	6	18	16	30	5横+E6	SOD-323	TPCESD5V0D3	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC3D5V1BB	5	6	18	16	30	5横+E6	SOD-323	ESDLC5V0D3B-TP	MCC(美微科)
FSNC3D5V1BA	5	6.5	9.5	15	90	5横+AC	SOD-323	RLSD32A051C	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D5V1BA	5	6.5	9.5	15	90	5横+AC	SOD-323	CESDB5V0D3	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC3D5V1BA	5	6.5	9.5	15	90	5横+AC	SOD-323	SDD32C05L01	Brightking(君耀)
FSNC3D5V1BA	5	6.5	9.5	15	90	5横+AC	SOD-323	PESD5V0S1BAF	Nexperia(安世)
FSNC3D5V1BA	5	6.5	9.5	15	90	5横+AC	SOD-323	ESDB5V0D3	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC3D8V1B	8	8.5	11	15	110	2C	SOD-323		
FSNC3D8V1BA	8	8.5	11	12	110	2C	SOD-323		
FSNC3D12V1B	12	13.3	20	12	110	2D/AD/K	SOD-323		
FSNC3D12V1BA	12	13.3	35	8	50	5横+AD	SOD-323	PESD12VL1BA,115	Nexperia(安世)
FSNC3D12V1BA	12	13.3	35	8	50	5横+AD	SOD-323	SESD3Z12C	SINO-IC(光宇睿芯)
FSNC3D12V1BA	12	13.3	35	8	50	5横+AD	SOD-323	RLSD32A121C	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D12V1BA	12	13.3	35	8	50	5横+AD	SOD-323	CESD323NC12VB	CREATEK(达晶微)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC3D12V1BC	12	13.3	16	6	8	12B	SOD-323		
FSNC3D15V1B	15	16.5	25	9	40	2J	SOD-323		
FSNC3D15V1B	15	16.5	25	9	40	BB	SOD-323	BSD3C151V	BORN伯恩半导体
FSNC3D15V1BA	15	16.5	45	6	30	5横+AE/15B	SOD-323	PESD15VL1BA,115	Nexperia(安世)
FSNC3D15V1BA	15	16.5	45	6	30	5横+AE/15B	SOD-323	PESD1LIN,115	Nexperia(安世)
FSNC3D15V1BA	15	16.5	45	6	30	5横+AE/15B	SOD-323	GBLC15C-N	BORN伯恩半导体
FSNC3D15V1BA	15	16.5	45	6	30	5横+AE/15B	SOD-323	RLSD32A151C	RUILON(瑞隆源)
FSNC3D15V1BA	15	16.5	45	6	30	5横+AE/15B	SOD-323	SESD3Z15C	SINO-IC(光宇睿芯)
FSNC3D24V1B	24	26	40	6	30	2H	SOD-323		
FSNC3D24V1BA	24	26	55	4	20	5横+AF	SOD-323	PESD1IVN24-AX	Nexperia(安世)
FSNC3D24V1BA	24	26	55	4	20	5横+AF	SOD-323	PESD24VL1BA,115	Nexperia(安世)
FSNC3D36V1B	36	38	55	4	25	2N	SOD-323		
FSNC1524	15/24	16.5/26	25/40	9/6	30	|||||AM	SOD-323		
FSLC5D5V1B	5	6	12	4	0.35	L05B	SOD-523		
FSLC5D5V1U	5	6	15	4	0.6	1横+L05U	SOD-523		
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	ESD5Z3.3T1G	ON(安森美)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	LESD5Z3.3T1G	LRC(乐山无线电)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	ESD5Z3.3	SHIKUES(时科)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	ESD5Z3.3T1G	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	PESD5Z3.3,115	Nexperia(安世)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	ESD3V3D5-TP	MCC(美微科)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	RLSD52A031V	RUILON(瑞隆源)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	ESD5Z3.3	AnBon(台湾安邦)
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	PESDNC5D3V3U	Prisemi 芯导
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	18	16	200	4横+N1	SOD-523	PESD3V3L1UB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5Z5.0T1G	BORN伯恩半导体
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	CESD5V0D5	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5Z5.0T1G	ON(安森美)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	CESD3V3D5	CJ（江苏长电/长晶）

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	RLSD52A051V	RUILON(瑞隆源)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	PESD5V0S1UB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5Z5.0	SHIKUES(时科)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5Z5V0	ST(先科)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	LESD5Z5.0T1G	LRC(乐山无线电)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5Z5.0	AnBon(台湾安邦)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	VESD05A1-02V-G-08	VISHAY(威世)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	UClamp0501H-N	BORN伯恩半导体
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	UCLAMP0501H.TCT	SEMTECH
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5V0D5-TP	MCC(美微科)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	CESD523NC5VU	CREATEK(达晶微)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	PESD5V0L1UB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	PESDNC5D5VU	Prisemi 芯导
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	SFD52A05L01	Brightking(台湾君耀)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	PJSD05TS	PANJIT(强茂)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	BSD5A051U	BORN伯恩半导体
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	PESD5Z5.0	Nexperia(安世)
FSNC5D5V1UA	5	6.5	20	15	180	4横+N2	SOD-523	ESD5Z12.0T1G	BORN伯恩半导体
FSNC5D7V1UA	7	7.5	22	12	140	4横+Z.H.8	SOD-523		
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	CESD12VD5	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	LESD5Z12T1G	LRC(乐山无线电)
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	ESD5Z12T1G	ON(安森美)
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	ESD5Z12T1G-N	BORN伯恩半导体
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	PESD5Z12,115	Nexperia(安世)
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	SZESD5Z12T1G	ON(安森美)
FSNC5D12V1UA	12	13.3	35	8	100	4横+N3	SOD-523	PESD12VS1UB	Nexperia(安世)
FSNC5D15V1UA	15	16.5	45	6	60	4横+N4	SOD-523	ESD5Z15.0T1G	BORN伯恩半导体
FSNC5D15V1UA	15	16.5	45	6	60	4横+N4	SOD-523	PESD15VS1UB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D15V1UA	15	16.5	45	6	60	4横+N4	SOD-523	BSD5A151V35	BORN伯恩半导体

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC5D24V1UA	24	26	55	4	40	4横+N5	SOD-523	ESD5Z24.0T1G	BORN伯恩半导体
FSNC5D24V1UA	24	26	55	4	40	4横+N5	SOD-523	PESD24VS1UB-N	BORN伯恩半导体
FSNC5D24V1UA	24	26	55	4	40	4横+N5	SOD-523	PESD24VS1UB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D36V1UA	36	40	50	2.5	10	1横+KT	SOD-523		
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	LAD52C03L01	Brightking(台湾君耀)
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	TPAZ5123-01H	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	ESD5z3.3T	Applied Power(应能微)
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	ESD5Z3.3C	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	ESD5Z36	MDD
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	TPESD5491S	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC5D3V1BA	3.3	3.8	6	8	15	CT	SOD-523	ESD3.3V52D-C .	SOCAY(硕凯)
FSNC5D5V1B	5	6	10	15	3.5	LB	SOD-523		
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	PESD5V0S1BBN	BORN伯恩半导体
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	LESD5D5.0CT1G	LRC(乐山无线电)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	ESD5B5.0ST1G	ON(安森美)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	CESDB5V0D5	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	RLSD52A051C	RUILON(瑞隆源)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	ESD5Z5.0C	SHIKUES(时科)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	CESD523NC5VB	CREATEK(达晶微)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	PESD5V0V1BB-N	BORN伯恩半导体
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	PESDNC5D5VB	Prisemi 芯导
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	PESD5V0V1BB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	SBD52C05L01	Brightking(台湾君耀)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	LESD5Z5.0CT1G	LRC(乐山无线电)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	PESD5V0U1BB,115	Nexperia(安世)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	TPAZ5125-01H	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	PJSD05CTS	PANJIT(强茂)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	LESD5Z5.0CT1G	UMW(友台半导体)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	ESD5Z5.0CT1G	TECH PUBLIC(台舟)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	CESD523LC5VB	CREATEK(达晶微)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	SLESD5Z5.0C	Slkor(萨科微)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	LAD52C05L01	Brightking(台湾君耀)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	SE5D10B5.0A	SEMIWARE(赛米微尔)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	SEN0501D5	SALLTECH(萨瑞)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	SD5C051V	ZHIDE(志得)
FSNC5D5V1BA	5	5.8	6	8	15	DT/|+5.C8.	SOD-523	SDD52C05L01	Brightking(台湾君耀)
FSNC5D8V1BA	8	9	11	9	10	8C	SOD-523		
FSNC5D12V1BA	12	13	14	6	10	12C	SOD-523		
FSNC9D3V1BA	3.3	3.7	7	6	15	1横+B/批号	SOD-923		
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	RLSD92A031C	RUILON(瑞隆源)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	ESD9B5.0ST5G	ON(安森美)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	PESDNC9D5VB	Prisemi 芯导
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	LESD9D5.0CT5G	LRC(乐山无线电)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	RLSD92A051C	RUILON(瑞隆源)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	ESD5V0D9B -	Yint(音特电子)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	ESD9B5VD	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	ESD9Z5.0C	AnBon(台湾安邦)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	CESD923NC5VB	CREATEK(达晶微)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	ESD9B3.3ST5G	ON(安森美)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	ESD5V0D9B-TP	MCC(美微科)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	SLESD9D5.0CT5G	Slkor(萨科微)
FSNC9D5V1BA	5	6	8.5	6	12	1横+C/批号	SOD-923	LAD92C5.0L01	Brightking(台湾君耀)
FSNC9D12V1UA	12	15.3	20	16	60	1横+12W	SOD-923		
FSNC712	7/12	7.5/13.3	19	24	55	712	SOT-23		
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	SDT23C712L02	Brightking(台湾君耀)
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	SM712-02HTG	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	RLST23A712C	RUILON(瑞隆源)
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	SM712-TP	MCC(美微科)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	MSP712	MSKSEMI(美森科)
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	SM712	SEMBO(深波)
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	SM712H-TP	MCC(美微科)
FSNC712A	7/12	7.5/13.3	14~25	17	55	712	SOT-23	CDSOT23-SM712	BOURNS
FSNC1236	12/36	14/40	32~60	15/3	35	1236	SOT-23		
FSNC23T3V2U	3.3	4.5	9	32	300	M03	SOT-23		
FSNC23T3V2UA	3.3	4	8	25	400	M03	SOT-23		
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	PESD5V0S2BT	BORN伯恩半导体
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	GSOT05C-E3-08	VISHAY(威世)
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	PESD5V2S2UT	UMW(友台半导体)
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	RLST23A052V	RUILON(瑞隆源)
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	SM05.N	BORN伯恩半导体
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	HSM05-TP	MCC(美微科)
FSNC23T5V2U	5	6	9	30	220	M05	SOT-23	SM05T1G	ON(安森美)
FSNC23T5V2UA	5	6	9	15	150	M05	SOT-23		
FSNC23T5V2UB	5	6	8	10	120	B 05C	SOT-23		
FSNC23T5V2UC	5	6	9	16	120	M05	SOT-23	CEST23NC5VU-M	CREATEK(达晶微)
FSNC23T5V2UC	5	6	9	16	120	M05	SOT-23	MA3075WALT1G	ON(安森美)
FSNC23T5V2UC	5	6	9	16	120	M05	SOT-23	SM05	UMW(友台半导体)
FSNC23T5V2UC	5	6	9	16	120	M05	SOT-23	MST23C242V	Me-TECH(美台高科)
FSNC23T5V2UC	5	6	9	16	120	M05	SOT-23	PSOT05C	Protek Devices
FSNC23T5V2UD	5	6.5	8.5	20	150	M05	SOT-23		
FSNC23T7V2U	7	7.5	11	25	180	M07	SOT-23	MMBZ6V8A	ON(安森美)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	SM12T1G	ON(安森美)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	LGSOT12CLT1G	LRC(乐山无线电)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	SET23A12L02-E18	Brightking(台湾君耀)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	ESDA14V2L	BORN伯恩半导体
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	PESD12VS2UT,215	Nexperia(安世)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	CESD12VAP	CJ（江苏长电/长晶）

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	PESD12VS2UT	UMW(友台半导体)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	RLST23A122V	RUILON(瑞隆源)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	CEST23NC12VU	CREATEK(达晶微)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	SM12.N	BORN伯恩半导体
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	SM12	UMW(友台半导体)
FSNC23T12V2U	12	13.5	18	15	100	M12	SOT-23	PSOT12C	Protek Devices
FSNC23T12V2UA	12	13.5	15	10	120	12C	SOT-23		
FSNC23T15V2U	15	16.5	22	11	80	M15	SOT-23	MMBZ18VALT1G	ON(安森美)
FSNC23T15V2U	15	16.5	22	11	80	M15	SOT-23	PESD15VS2UT	UMW(友台半导体)
FSNC23T15V2U	15	16.5	22	11	80	M15	SOT-23	SM15.N	BORN伯恩半导体
FSNC23T15V2U	15	16.5	22	11	80	M15	SOT-23	SM15H-TP	MCC(美微科)
FSNC23T15V2U	15	16.5	22	11	80	M15	SOT-23	PSOT15C	Protek Devices
FSNC23T15V2UA	15	16.5	19	7	100	15C	SOT-23		
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	PESD1CAN	UMW(友台半导体)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	PESD5V2S2UT,215	Nexperia(安世)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	PESD2CAN	UMW(友台半导体)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	ESDA25L	ST(意法半导体)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	ESDA25L	BORN伯恩半导体
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	SET23A24L02	Brightking(台湾君耀)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	PESD24VS2UT,215	Nexperia(安世)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	PESD24VS2UT	UMW(友台半导体)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	RLST23A242V	RUILON(瑞隆源)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	SM24.N	BORN伯恩半导体
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	SM24B-TP	MCC(美微科)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	GSOT24C-E3-08	VISHAY(威世)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	PSOT24C	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	ESD0P8RFL E6327	Infineon(英飞凌)
FSNC23T24V2U	24	26.5	33	6	60	M24	SOT-23	ESD0P4RFL E6327	Infineon(英飞凌)
FSNC23T24V2UA	24	26.5	30	4	100	M24	SOT-23		

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC23T36V2U	36	40	55	3	50	M36	SOT-23		
FSNC23T3V2B	3.3	4.5	8.5	24	120	C03	SOT-23		
FSNC23T3V2BA	3.3	4.5	8.5	16	100	C03	SOT-23		
FSNC23T3V2BB	3.3	3.6	8	24	135	C03	SOT-23		
FSNC23T3V2BC	3.3	3.6	8	30	60	C03	SOT-23		
FSNC23T5V2B	5	6.5	9.5	20	120	C05	SOT-23		
FSNC23T5V2BA	5	6.5	9.5	15	90	C05	SOT-23		
FSNC23T5V2BB	5	5.5	6.5	8	12	V3W/14	SOT-23		
FSNC23T8V2B	8	8.5	11	15	110	C08	SOT-23		
FSNC23T8V2BA	8	8.5	11	12	70	C07	SOT-23		
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	TPD2E007DCKR	TI(德州仪器)
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	RLST23A122C	RUILON(瑞隆源)
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	PESD12VL2BT-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	SM12-TP	MCC(美微科)
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	SM12B-TP	MCC(美微科)
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	CESDBLC12VAP	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC23T12V2B	12	13.3	20	12	70	C12/AB2	SOT-23	PESD15VL2BTN	BORN伯恩半导体
FSNC23T12V2BA	12	13.3	20	8	50	C12	SOT-23		
FSNC23T15V2B	15	16.5	25	9	40	BB2	SOT-23	BST23C152V	BORN伯恩半导体
FSNC23T15V2B	15	16.5	25	9	40	C15/BB2	SOT-23	SM15C	AnBon(台湾安邦)
FSNC23T15V2B	15	16.5	25	9	40	C15/BB2	SOT-23	SM15B-TP	MCC(美微科)
FSNC23T15V2B	15	16.5	25	9	40	C15/BB2	SOT-23	CESDBLC15VAP	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC23T15V2B	15	16.5	25	9	40	C15/BB2	SOT-23	PESD15VL2BT,215	Nexperia(安世)
FSNC23T15V2BA	15	16.5	25	6	30	C15	SOT-23		
FSNC23T18V2B	18	19.5	30	7	35	C18	SOT-23		
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	NUP2125WTT1G	ON(安森美)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PESD24VL2BTN	BORN伯恩半导体
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	TPESD1CAN	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PESD2CAN	TECH PUBLIC(台舟)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	SDT23C24L02	Brightking(台湾君耀)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	ESD2105L	MDD
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	TPCDSOT23-T24CAN	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	ESD二极管	FUXINSEMI(富芯微)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	RLST23A242C	RUILON(瑞隆源)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	TPSM24CANB-02HTG	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	S-LR2105LT1G	LRC(乐山无线电)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	NUP2105LT1G-MS	MSKSEMI(美森科)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	SDT23C24L02-AT	Brightking(台湾君耀)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	TPESDCAN24-2BLY	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	ESDONCAN1LT3G	ON(安森美)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	SM24BHE3-TP	MCC(美微科)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PEC3124C2A-AU	PANJIT(强茂)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	NUP2105LT1G-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PESD2IVN24-TR	Nexperia(安世)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PESD1CAN,215	Nexperia(安世)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PESD2CAN,215	Nexperia(安世)
FSNC23T24V2B	24	26	40	6	30	C24/CB2/27EY	SOT-23	PESD1CAN	BORN伯恩半导体
FSNC23T24V2B	24	26.5	36	8	30	CB2/27EY	SOT-23		
FSNC23T24V2BA	24	26.5	40	4	20	SCH/C24	SOT-23		
FSNC23T36V2B	36	38	55	4	25	C36	SOT-23		
FSLC23T3V2BA	3.3	4.5	8.5	19	0.8	BW3	SOT-23		
FSLC23T5V2BA	5	6.5	9	15	0.8	BW5	SOT-23		
FSLC23T8V2BA	8	8.5	12	14	0.8	BW8	SOT-23		
FSLC23T12V2BA	12	13.3	19	7	0.8	BWA	SOT-23		
FSLC23T15V2BA	15	16.5	24	6	0.8	BWC	SOT-23		
FSLC23T24V2BA	24	26	34	4	0.8	BWF	SOT-23		
FSLC23T5V1U	5	6	9.5	15	1.5	L05.F	SOT-23		
FSLC23T5V2U	5	6	10	4	0.6	R22	SOT-23	UBT23A05L02	Brightking(台湾君耀)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSLC23T5V2U	5	6	10	4	0.6	R22	SOT-23	PESD23T5VU	DIOTEC/德欧泰克
FSLC23T5V2U	5	6	10	4	0.6	R22/W02*	SOT-23	ESD5302F	WILLSEMI(韦尔)
FSLC23T5V2U	5	6	10	4	0.6	WAQ/W02L	SOT-23	ESD5302F	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC23T5V2UB	5	6	15	8	1.2	UR22	SOT-23		
FSNC2X3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	B	DFN0603-2L		
FSNC2X5V1B	5	6	9	4	5	G	DFN0603-2L		
FSNC2X5V1BA	5	5.6	8	6	12	H	DFN0603-2L		
FSNC2X8V1BA	8	9	13	6	10	J	DFN0603-2L		
FSNC2X12V1BA	12	13.5	16	6	7	K	DFN0603-2L		
FSLC2F3V1B	3.3	4.5	12	4	0.35	1横+S	DFN1006-2L		
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	RCLAMP0521PATCT	SEMTECH
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESD8L3.3CT5G	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	Rclamp0521p.tct	SEMTECH
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPRCLAMP3321P	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPPESD3V3X1BL	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	Rclamp0531T-N	BORN伯恩半导体
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	ESD7951ST5G	BORN伯恩半导体
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	PESDUC2FD5VB	Prisemi 芯导
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESDLC0521P	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	ESD5V0B03-1006	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	PESDMC2FD5VB	Prisemi 芯导
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	R1	DFN1006-2L	BDFN2C051U	BORN伯恩半导体
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	ESD0501BL	MDD
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPPESD5V0F1BL	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	ESDSLC5V0LB-TP	MCC(美微科)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESD8L5.0CT5G	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	SE10F10B5.0MA	SEMIWARE(赛米微尔)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESD5V3U1U-02LRH	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESD0531T	TECH PUBLIC(台舟)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	RCLAMP0521P-P	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	PESD5V0U1BL-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	R1	DFN1006-2L	BSDFN2C051U	BORN伯恩半导体
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPPESD5V0X1BCAL	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPSP3022-01ETG	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESD8LS5.0CT5G	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPAZ5425-01F	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPD1E6B06DPLR-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	AZ5425-01F	晶炎
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	ESD5V0B06G-1006	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPESD9N5BM	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	SLESD5.0U035	Slkor(萨科微)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ/ZZ	DFN1006-2L	PESD5V0F1BL	安世
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	SBX0521P	SEMBO(深波)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	TPA0Z8131DI-05L	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ/ZZ	DFN1006-2L	PESD5V0F1BLD,315	Nexperia(安世)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ/ZZ	DFN1006-2L	PESD5V0F1BRLDYL	Nexperia(安世)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	ULC3311CDN	Leiditech(雷卯电子)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ	DFN1006-2L	AZ5413-01F.R7GR	AMAZING(晶焱)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ/UV	DFN1006-2L	LESD8L5.0T5G	LRC(乐山无线电)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ/4M	DFN1006-2L	ESD8472MUT5G	ON(安森美)
FSLC2F5V1B	5	6	12	4	0.35	JJ/6J	DFN1006-2L	SMF05C	ON(安森美)
FSLC2F5V1BA	5	5.5	8.5	3	3.5	1横+5T	DFN1006-2L		
FSLC2F5V1BT	5	5.5	12	4.5	0.3	T5	DFN1006-2L		
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	ESD5311N-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	ESD5301N-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	TPUCLAMP0501T	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	CESD1006LC5VU	CREATEK(达晶微)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	ESD0501L	MDD

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	PESDXC2FD5VU	Prisemi 芯导
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	TPESD9X5VU	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	PESDSC2FD5VU	Prisemi 芯导
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	PESDLC2FD5VUH	Prisemi 芯导
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	TPESD9X5VL	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	VBUS051BD-HD1-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	TPESD5301N	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	SP3030-01ETG	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	TPAZ5215-01F	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2F5V1U	5	6	12	4	0.6	1横+5L	DFN1006-2L	ESD9X5VU-2/TR	WILLSEMI(韦尔)
FSLC2X5V1B	5	6	12	4	0.6	5L	DFN0603-2L		
FSLC2X5V1U	5	6	10	4	0.6	1横+L5	DFN0603-2L		
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	CESD1006NC12VB-M	CREATEK(达晶微)
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	UClamp1211P-N	BORN伯恩半导体
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	ESD12010C	MDD
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	BDFN2C181R	BORN伯恩半导体
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	TPESD203-B1-02EL	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	PJSD12LCFN2	PANJIT(强茂)
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	ESDLC12VLB-TP	MCC(美微科)
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	ESD8V0L1B-02LRH-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F12V1BA	12	13.5	16	6	7	AF	DFN1006-2L	ESD9N12BA	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F12V1U	12	14	20	20	100	1横+U12	DFN1006-2L		
FSNC2F12V1UA	12	13.5	20	10	8	1横+12	DFN1006-2L		
FSNC2F15V1BA	15	16.5	22	7	13	1横+E	DFN1006-2L		
FSNC2F15V1UA	15	16.5	22	7	35	1横+15	DFN1006-2L		
FSNC2F3V1BA	3.3	4.5	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L		
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	TPPESD3V3V1BL	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	TPUCLAMP3311P	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	ESD0402DFN1006 3.3V	PTTC(聚鼎)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	SES3V3D1006SY-2B	Semitel(晶讯)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	PJSD03LCFN2	PANJIT(强茂)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	BDFN2C3R31V	BORN伯恩半导体
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	TPE03GBP2	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	TPAZ5123-01F	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	TPDESD3V3S1BL	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	ESDL3V3LB-TP	MCC(美微科)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	AU3321P1	Applied Power(应能微)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	AZ5013-01F.R7G	AMAZING(晶焱)
FSNC2F3V1BB	3.3	3.7	7	6	15	1横+T	DFN1006-2L	AZ5123-01F.R7GR	AMAZING(晶焱)
FSNC2F3V1BC	3.3	3.8	5	20	50	1横+ES	DFN1006-2L		
FSNC2F3V1UA	3.3	5	7	20	200	1横+3	DFN1006-2L		
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	ESD9B5VL	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	TPAZ5325-01F	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	ESD0801PB	MDD
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	TPUCLAMP0511T	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	SLESD8D5.0C	Slkor(萨科微)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	ESD5V0B100A-1006	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	MKT312U035 停产	MK(米客方德)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	PESD5V0S1BLN-MS	MSKSEMI(美森科)
FSNC2F5V1B	5	6	9	4	5	1横+UB	DFN1006-2L	SESDFBP05CL	SINO-IC(光宇睿芯)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	MKT3412AB 停产	MK(米客方德)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	ESD5451N-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	PESDNC2FD5VB	Prisemi 芯导
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	PESDNC2FD5VBS	Prisemi 芯导
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	CLAMP0551P1	WPMtek(维攀微)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	ESD5451X-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	TPESD8D5.0CT5G	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	TPESD9N5B	TECH PUBLIC(台舟)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	RLSD92Q051C	RUILON(瑞隆源)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	PESD5V0V1BL-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	SES5VD1006SHSY-2B	Semitel(晶讯)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	ESD 0402 DFN1006 6.3V	PTTC(聚鼎)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	PESD5V0G1BLYL	Nexperia(安世)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	PJSD05LCFN2_R1	PANJIT(强茂)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	JEB05DF	JJW(捷捷微)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	ESD5V0B15G-0201	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	ESDLC5V0L2B-TP	MCC(美微科)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	MKT312N15 停产	MK(米客方德)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	PESD05NFA-MS	MSKSEMI(美森科)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	TPAZ5725-01F	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	ESD5471X-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	TESDBLC5V0LED02	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	DTESDB5V0LED02	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC2F5V1BA	5	6	8	6	12	PB/.H/C/.S	DFN1006-2L	LESD8D5.0CKT5G	LRC(乐山无线电)
FSNC2F5V1BB	5	6	9	15	25	D5	DFN1006-2L		
FSNC2F5V1UA	5	6	10	15	150	1横+YB	DFN1006-2L		
FSNC2F5V1UB	5	6	9.5	22	150	D5	DFN1006-2L		
FSNC2F7V1UA	7	8	11	12	80	1横+7	DFN1006-2L		
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	BDFN2C071V	BORN伯恩半导体
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	PESDNC2FD7VBL	Prisemi 芯导
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	TPESD5411N	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	PESDNC2FD8VB	Prisemi 芯导
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	PESDNC2FD7VB	Prisemi 芯导
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	ESD7V0LB-TP	MCC(美微科)
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	ESDA07CP	Leiditech(雷卯电子)
FSNC2F8V1BA	8	9	13	6	10	2横+R2C	DFN1006-2L	VCUT0714A-HD1-GS08	VISHAY(威世)
FSNC2F24V1BA	24	26	35	4	20	DH	DFN1006-2L	PESDNC2FD24VB	Prisemi 芯导

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSNC2F24V1BA	24	26	35	4	20	DH	DFN1006-2L	BDFN2A241V35	BORN伯恩半导体
FSNC2F24V1BA	24	26	35	4	20	DH	DFN1006-2L	PESD24VS1UL-N	BORN伯恩半导体
FSNC2F24V1BA	24	26	35	4	20	DH	DFN1006-2L	BDFN2C241V35	BORN伯恩半导体
FSNC2F24V1BA	24	26	35	4	20	DH	DFN1006-2L	ESD24VB35-1006	TECH PUBLIC(台舟)
FSNC2F24V1U	24	26	33	7	60	1横+24	DFN1006-2L		
FSNC2F24V1UA	24	26.6	35	4	40	1横+24	DFN1006-2L		
FSLC3F5V2U	5	6	20.5	4	0.6	1横+L05	DFN1006-3L		
FSNC3F3V2BB	3.3	3.7	7	6	15	3B	DFN1006-3L		
FSNC3F5V2BA	5	5.6	8	6	12	5B	DFN1006-3L		
FSNC16F5V1BA	5	5.5	7.5	100	300	3X	DFN1610-2L		
FSHC16F4V1U	4.5	5.5	6.5	100	1100	1横+H4	DFN1610-2L		
FSHC16F5V1U	5	6	7	100	1000	1横+H5	DFN1610-2L		
FSHC16F7V1UA	7	7.5	6.5	100	500	1横+H7	DFN1610-2L		
FSHC16F12V1U	12	13.3	15	70	800	1横+H12	DFN1610-2L		
FSHC16F15V1U	15	16.5	18	60	600	1横+H15	DFN1610-2L		
FSHC16F18V1U	18	19.5	25	50	400	1横+H18	DFN1610-2L		
FSHC16F26V1U	26	28	35	40	300	1横+H26	DFN1610-2L		
FSHC3F5V1U	5	6	7.5	300	3200		DFN2X2-3L		
FSHC3F7V1U	7	8	9	200	1800		DFN2X2-3L		
FSHC3F10V1U	10	12	13.5	200	1500		DFN2X2-3L		
FSHC3F12V1U	12	13.3	15	180	1400		DFN2X2-3L		
FSHC3F15V1U	15	16.5	18.5	130	1000		DFN2X2-3L		
FSHC3F24V1U	24	26	30	100	800		DFN2X2-3L		
FSUC2X5V1B	5	6	15	3	0.25	5U	DFN0603-2L		
FSUC2X5V1BA	5	6	15	3	0.25	空白	DFN0603-2L		
FSUC2F5V1B	5	6	15	3	0.2	NL	DFN1006-2L		
FSUC06F5V2U	5	6	8.5	4	0.3	.0522P	DFN1610-6	RCLAMP0522P-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC06F5V2U	5	6	8.5	4	0.3	.0522P	DFN1610-6	RCLAMP0522P.TCT	UMW(友台半导体)
FSUC06F5V2U	5	6	8.5	4	0.3	.0522P	DFN1610-6	MSESD0522P	MSKSEMI(美森科)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	VRWM(V)	VBR(V)	Vc(V)	IPP(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	TESD5V0V4UA RDG	Taiwan Semiconductor(台湾半导体)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	ESD0524P	MDD
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	PESDALC10N5VU	Prisemi 芯导
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	TPD4E05U06DQAR-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	ESD5304D-MS	MSKSEMI(美森科)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	0524P	YANGJIE(扬杰)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	CESD2510LC5VU-M	CREATEK(达晶微)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	TPSP3012-04UTG	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	SBC0524P	SEMBO(深波)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	TPESDR0524PMUTAG	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	ESDA6V8UD-MS	MSKSEMI(美森科)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	MKT642U05 停产	MK(米客方德)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	RCLAMP0524P-MS	MSKSEMI(美森科)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	ULC0524P	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	ESD5344D-MS	MSKSEMI(美森科)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	MSULC0524P	MSKSEMI(美森科)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	MS1045-04F	MSKSEMI(美森科)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	UBQ10A05L04HI	Brightking(台湾君耀)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	IP4292CZ10-TBR,115	Nexperia(安世)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	IP4294CZ10-TBR,115	Nexperia(安世)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	AZ1045-04F	AMAZING(晶焱)
FSUC10F5V4U	5	6	8.5	4	0.3	.0524P	DFN2510-10L	WS05-4R2P	WAYON/维安
FSUC10F5V4UA	5	6	8	4.5	0.2	.0524P	DFN2510-10L		
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	TPAZ1143-04F	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	TPRCLAMP3324P	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	SESUC3V3D2510-10U	Semitel(晶讯)
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	TPESD3324PA	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	ESDLC3304P5-TP	MCC(美微科)
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	UBQ10A03L04	Brightking(台湾君耀)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSUC10F3V4U	3.3	4	8.5	4.5	0.3	.3324P	DFN2510-10L	ESD3V3U4ULC-MS	MSKSEMI(美森科)
FSLC523T5V2U	5	6	10	4	0.6	P5	SOT-523	RCLAMP0502BATCT	SEMTECH
FSLC523T5V2U	5	6	10	4	0.6	P5	SOT-523	UAT52A05L02	Brightking(台湾君耀)
FSNC353T5V4UB	5	6	10	8	100	.W.E/S	SOT-353		
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	SMF15CT1G	ON(安森美)
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	SMF05CT1G-MS	MSKSEMI(美森科)
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	LESDA6V1W6T1G	LRC(乐山无线电)
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	SAT36A05L05	Brightking(台湾君耀)
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	SEMF05LCC	SINO-IC(光宇睿芯)
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	CESD5V0K5	CJ（江苏长电/长晶）
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	SMF05CT2G	ON(安森美)
FSNC363T5V5UB	5	6	9.5	8	100	.5C	SOT-363	PESD5V0L5UYF	Nexperia(安世)
FSLC353T5V4UA	5	6	8.5	4.5	0.3	.A54	SOT-353		
FSLC363T5V4UA	5	6	8.5	4	0.4	.B54	SOT-363	RCLAMP0504FATCT-N	BORN伯恩半导体
FSLC363T5V4UA	5	6	8.5	4	0.4	.B54	SOT-363	RCLAMP0504F	Semtech(升特)
FSLC363T5V4U	5	6	10	4	0.4	.B54	SOT-363		
FSLC523T5V2U	5	6	8	4	0.6	P5	SOT-563		
FSLC563T5V2U	5	6	8	4	0.3	.A	SOT-563		
FSLC563T5V4U	5	6	8	4	0.3	.空白待定	SOT-563		
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.4D	SOT23-6	PRTR5V0U4D,125	Nexperia(安世)
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.UL46	SOT23-6	USBLC6-4SC6	ST(意法半导体)
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.U5H4	SOT23-6	ESDU5V0H4	CJ（江苏长电/长晶）
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05	SOT23-6	SESRV05-4	SEMIWARE(赛米微尔)
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.V5L	SOT23-6	BST236A054U	BORN伯恩半导体
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05	SOT23-6	AZC099-04F	晶焱-Amazing
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.F54	SOT23-6	RCLAMP0504F	Semtech(升特)
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.MMWW	SOT23-6	ESDA6V8UW	WILLSEMI(韦尔)
FSUC236T5V4U	5	6	9	4.5	0.3	.V05/.P4HH	SOT23-6	PDWL050019	TECH PUBLIC(台舟)
FSUC236T5V4UB	5	6	10	5.5	0.3	.V05	SOT23-6		

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSUC236T5V4UC	5	6	25	25	3	.V05	SOT23-6		
FSLC236T5V2U	5	6	8.5	4	0.8	.UL26	SOT23-6		
FSLC236T5V2UA	5	6	10	4.5	0.8	.UL26	SOT23-6	USBLC6-2SC6	ST(意法半导体)
FSLC236T5V2UA	5	6	10	4.5	0.8	.UL26	SOT23-6	USBLC6-2SC6	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC236T5V2UA	5	6	10	4.5	0.8	.UL26	SOT23-6	MSUSBLC6-2SC6	MSKSEMI(美森科)
FSLC236T5V2UA	5	6	10	4.5	0.8	.UL26	SOT23-6	UBT26A05L03	Brightking(台湾君耀)
FSLC236T5V2UA	5	6	10	4.5	0.8	.UL26	SOT23-6	TPESD0502S6	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC236T5V2UA	5	6	10	4.5	0.8	.UL26	SOT23-6	MAX3207EAUT+T	MAXIM(美信)
FSNC236T5V4UA	5	6	9	22	200	.S05	SOT23-6		
FSNC236T5V4UB	5	6	8	12	100	.ES61	SOT23-6		
FSNC236T5V4UC	5	6	8	23	150	.空白	SOT23-6		
FSNC236T7V4UA	7	7.5	11	20	150	.S07	SOT23-6		
FSNC236T12V4UA	12	13	18	15	90	.S12	SOT23-6		
FSNC236T15V4UA	15	16	25	12	70	.S15	SOT23-6		
FSNC236T5V5UA	5	6	9	22	200	.S05	SOT23-6		
FSNC236T7V5UA	7	7.5	11	20	150	.S07	SOT23-6		
FSNC236T12V5UA	12	13	18	15	90	.S12	SOT23-6		
FSNC236T15V5UA	15	16	25	12	70	.S15	SOT23-6		
FSLC143T5V2UA	5	6	10	6	0.6	R05	SOT-143	UDT14A05L03	Brightking(台湾君耀)
FSLC143T5V2UA	5	6	10	6	0.6	R05	SOT-143	CM1213A-02SR	ON(安森美)
FSLC143T5V2UA	5	6	10	6	0.6	R05	SOT-143	SR05	SEMBO(深波)
FSLC143T5V2UA	5	6	10	6	0.6	R05	SOT-143	PESD2ETH-AXR	Nexperia(安世)
FSLC143T5V2UA	5	6	10	6	0.6	R05	SOT-143	MSSR05.TCT	MSKSEMI(美森科)
FSLC2.8	2.8	3	5	20	10	U2.8	SOT-23		
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	SLVU2.8-4-TP	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	TPE08A2.8L04	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	TPAZ3028-04P.RDG	TECH PUBLIC(台舟)
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	SLVU2.8-8-LF-T7	PROTEK
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	UFS08A2.8L04	Brightking(台湾君耀)

ESD静电浪涌保护二极管

型号	工作电压	击穿电压	钳位电压	浪涌电流	结电容	印字	封装	代替型号	
Type	V_{RWM}(V)	V_{BR}(V)	V_C(V)	I_{PP}(A)	Cj(pF)	Marking	Package	型号	品牌
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	RLS08A2.84LV	RUILON(瑞隆源)
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	SLVU2.8-4-TP	MCC(美微科)
FSLC2.8-4	2.8	3	5	20	3	SLVU2.8-4	SOP-8	UFS08C2.8L04	Brightking(台湾君耀)

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
UMB05F	MB05F	30	1668	1000	50	1	5	MBF	贴片桥
UMB1F	MB1F	30	1668	1000	100	1	5	MBF	贴片桥
UMB2F	MB2F	30	1668	1000	200	1	5	MBF	贴片桥
UMB4F	MB4F	30	1668	1000	400	1	5	MBF	贴片桥
UMB6F	MB6F	30	1668	1000	600	1	5	MBF	贴片桥
UMB8F	MB8F	30	1668	1000	800	1	5	MBF	贴片桥
UMB10F	MB10F	30	1668	1000	1000	1	5	MBF	贴片桥
MB05F	MB05F	30	1563	800	50	1	5	MBF	贴片桥
MB1F	MB1F	30	1563	800	100	1	5	MBF	贴片桥
MB2F	MB2F	30	1563	800	200	1	5	MBF	贴片桥
MB4F	MB4F	30	1563	800	400	1	5	MBF	贴片桥
MB6F	MB6F	30	1563	800	600	1	5	MBF	贴片桥
MB8F	MB8F	30	1563	800	800	1	5	MBF	贴片桥
MB10F	MB10F	30	1563	800	1000	1	5	MBF	贴片桥
MB12F	MB12F	30	1250	1000	20	0.55	300	MBF	贴片桥
MB14F	MB14F	30	1250	1000	40	0.55	300	MBF	贴片桥
MB16F	MB16F	30	1250	1000	60	0.7	300	MBF	贴片桥
MB18F	MB18F	30	1250	1000	80	0.85	200	MBF	贴片桥
MB110F	MB110F	30	1250	1000	100	0.85	200	MBF	贴片桥
MB115F	MB115F	30	1250	1000	150	0.9	100	MBF	贴片桥
MB120F	MB120F	30	1250	1000	200	0.9	100	MBF	贴片桥
MB6S	MB6S	30	1563	800	600	1.1	5	MBS	贴片桥

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
MB8S	MB8S	30	1563	800	800	1.1	5	MBS	贴片桥
MB10S	MB10S	30	1563	800	1000	1.1	5	MBS	贴片桥
MB6SA	MB6S	30	1563	1000	600	1	5	MBS	贴片桥
MB8SA	MB8S	30	1563	1000	800	1	5	MBS	贴片桥
MB10SA	MB10S	30	1563	1000	1000	1	5	MBS	贴片桥
ABS6	ABS6	30	1668	1000	600	1.1	5	ABS	贴片桥
ABS8	ABS8	30	1668	1000	800	1.1	5	ABS	贴片桥
ABS10	ABS10	30	1668	1000	1000	1.1	5	ABS	贴片桥
FBS26	FBS26	70	1668	2000	600	1.3	5	ABS	贴片桥
FBS28	FBS28	70	1668	2000	800	1.3	5	ABS	贴片桥
FBS210	FBS210	70	1668	2000	1000	1.3	5	ABS	贴片桥
ABS26	ABS26	50	1668	2000	600	1	5	ABS	贴片桥
ABS28	ABS28	50	1668	2000	800	1	5	ABS	贴片桥
ABS210	ABS210	50	1668	2000	1000	1	5	ABS	贴片桥
UM6B	UM6B	25	1136	800	600	1.1	3	UMB	贴片桥
UM8B	UM8B	25	1136	800	800	1.1	3	UMB	贴片桥
UM10B	UM10B	25	1136	800	1000	1.1	3	UMB	贴片桥
TB6S	TB6S	30	1668	1000	600	1.1	5	TBS	贴片桥
TB8S	TB8S	30	1668	1000	800	1.1	5	TBS	贴片桥
TB10S	TB10S	30	1668	1000	1000	1.1	5	TBS	贴片桥
DB101S	DB101S	50	2500	1000	50	1.1	5	DB-1S	贴片桥
DB102S	DB102S	50	2500	1000	100	1.1	5	DB-1S	贴片桥

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
DB103S	DB103S	50	2500	1000	200	1.1	5	DB-1S	贴片桥
DB104S	DB104S	50	2500	1000	400	1.1	5	DB-1S	贴片桥
DB105S	DB105S	50	2500	1000	600	1.1	5	DB-1S	贴片桥
DB106S	DB106S	50	2500	1000	800	1.1	5	DB-1S	贴片桥
DB107S	DB107S	50	2500	1000	1000	1.1	5	DB-1S	贴片桥
DB201S	DB201S	60	3125	2000	50	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB202S	DB202S	60	3125	2000	100	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB203S	DB203S	60	3125	2000	200	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB204S	DB204S	60	3125	2000	400	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB205S	DB205S	60	3125	2000	600	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB206S	DB206S	60	3125	2000	800	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB207S	DB207S	60	3125	2000	1000	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB301S	DB301S	80	4168	3000	50	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB302S	DB302S	80	4168	3000	100	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB303S	DB303S	80	4168	3000	200	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB304S	DB304S	80	4168	3000	400	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB305S	DB305S	80	4168	3000	600	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB306S	DB306S	80	4168	3000	800	1.1	5	DB-S	贴片桥
DB307S	DB307S	80	4168	3000	1000	1.1	5	DB-S	贴片桥
FMSB30A	FMSB30A	80	4168	3000	50	1.3	5	UMSB	贴片桥
FMSB30B	FMSB30B	80	4168	3000	100	1.3	5	UMSB	贴片桥
FMSB30D	FMSB30D	80	4168	3000	200	1.3	5	UMSB	贴片桥

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
FMSB30G	FMSB30G	80	4168	3000	400	1.3	5	UMSB	贴片桥
FMSB30J	FMSB30J	80	4168	3000	600	1.3	5	UMSB	贴片桥
FMSB30K	FMSB30K	80	4168	3000	800	1.3	5	UMSB	贴片桥
FMSB30M	FMSB30M	80	4168	3000	1000	1.3	5	UMSB	贴片桥
MSB40B	MSB40B	95	2080	4000	100	1.1	5	UMSB	贴片桥
MSB40D	MSB40D	95	2080	4000	200	1.1	5	UMSB	贴片桥
MSB40G	MSB40G	95	2080	4000	400	1.1	5	UMSB	贴片桥
MSB40J	MSB40J	95	2080	4000	600	1.1	5	UMSB	贴片桥
MSB40K	MSB40K	95	2080	4000	800	1.1	5	UMSB	贴片桥
MSB40M	MSB40M	95	2080	4000	1000	1.1	5	UMSB	贴片桥
KBP206	KBP206	50	4168	2000	600	1.1	10	KBP	插件桥
KBP208	KBP208	50	4168	2000	800	1.1	10	KBP	插件桥
KBP210	KBP210	50	4168	2000	1000	1.1	10	KBP	插件桥
KBP306	KBP306	80	5000	3000	600	1.1	10	KBP	插件桥
KBP308	KBP308	80	5000	3000	800	1.1	10	KBP	插件桥
KBP310	KBP310	80	5000	3000	1000	1.1	10	KBP	插件桥
GBU4005	GBU4005	120	5000	4000	50	1.1	10	GBU	插件桥
GBU401	GBU401	120	5000	4000	100	1.1	10	GBU	插件桥
GBU402	GBU402	120	5000	4000	200	1.1	10	GBU	插件桥
GBU404	GBU404	120	5000	4000	400	1.1	10	GBU	插件桥
GBU406	GBU406	120	5000	4000	600	1.1	10	GBU	插件桥
GBU408	GBU408	120	5000	4000	800	1.1	10	GBU	插件桥

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
GBU410	GBU410	120	5000	4000	1000	1.1	10	GBU	插件桥
GBU6005	GBU6005	150	5000	6000	50	1	5	GBU	插件桥
GBU601	GBU601	150	5000	6000	100	1	5	GBU	插件桥
GBU602	GBU602	150	5000	6000	200	1	5	GBU	插件桥
GBU604	GBU604	150	5000	6000	400	1	5	GBU	插件桥
GBU606	GBU606	150	5000	6000	600	1	5	GBU	插件桥
GBU608	GBU608	150	5000	6000	800	1	5	GBU	插件桥
GBU610	GBU610	150	5000	6000	1000	1	5	GBU	插件桥
GBU8005	GBU8005	170	5000	8000	50	1	5	GBU	插件桥
GBU801	GBU801	170	5000	8000	100	1	5	GBU	插件桥
GBU802	GBU802	170	5000	8000	200	1	5	GBU	插件桥
GBU804	GBU804	170	5000	8000	400	1	5	GBU	插件桥
GBU806	GBU806	170	5000	8000	600	1	5	GBU	插件桥
GBU808	GBU808	170	5000	8000	800	1	5	GBU	插件桥
GBU810	GBU810	170	5000	8000	1000	1	5	GBU	插件桥
GBU10005	GBU10005	200	5000	10000	50	1.1	5	GBU	插件桥
GBU1001	GBU1001	200	5000	10000	100	1.1	5	GBU	插件桥
GBU1002	GBU1002	200	5000	10000	200	1.1	5	GBU	插件桥
GBU1004	GBU1004	200	5000	10000	400	1.1	5	GBU	插件桥
GBU1006	GBU1006	200	5000	10000	600	1.1	5	GBU	插件桥
GBU1008	GBU1008	200	5000	10000	800	1.1	5	GBU	插件桥
GBU1010	GBU1010	200	5000	10000	1000	1.1	5	GBU	插件桥

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
GBU15005	GBU15005	240	6500	15000	50	1.05	10	GBU	插件桥
GBU1501	GBU1501	240	6500	15000	100	1.05	10	GBU	插件桥
GBU1502	GBU1502	240	6500	15000	200	1.05	10	GBU	插件桥
GBU1504	GBU1504	240	6500	15000	400	1.05	10	GBU	插件桥
GBU1506	GBU1506	240	6500	15000	600	1.05	10	GBU	插件桥
GBU1508	GBU1508	240	6500	15000	800	1.05	10	GBU	插件桥
GBU1510	GBU1510	240	6500	15000	1000	1.05	10	GBU	插件桥
GBJ20005	GBJ20005	250	7813	20000	50	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2001	GBJ2001	250	7813	20000	100	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2002	GBJ2002	250	7813	20000	200	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2004	GBJ2004	250	7813	20000	400	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2006	GBJ2006	250	7813	20000	600	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2008	GBJ2008	250	7813	20000	800	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2010	GBJ2010	250	7813	20000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ25005	GBJ25005	350	6950	25000	50	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2501	GBJ2501	350	6950	25000	100	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2502	GBJ2502	350	6950	25000	200	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2504	GBJ2504	350	6950	25000	400	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2506	GBJ2506	350	6950	25000	600	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2508	GBJ2508	350	6950	25000	800	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ2510	GBJ2510	350	6950	25000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ35005	GBJ35005	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥

整流桥

型号	印字	浪涌电流	功率	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式	特点
Type	Marking	I_{FSM}(A)	P_D(mW)	I_O(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package	Feature
GBJ3501	GBJ3501	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ3502	GBJ3502	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ3504	GBJ3504	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ3506	GBJ3506	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ3508	GBJ3508	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥
GBJ3510	GBJ3510	350	6950	35000	1000	1.05	10	GBJ	插件桥

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMAJ5.0(C)A	AE	WE	5	6.4	7.25	10	9.2	43.5	800	400	SMA
SMAJ6.0(C)A	AG	WG	6	6.67	7.67	10	10.3	38.8	800	400	SMA
SMAJ6.5(C)A	AK	WK	6.5	7.22	8.3	10	11.2	35.7	500	400	SMA
SMAJ7.0(C)A	AM	WM	7	7.78	8.95	10	12	33.3	200	400	SMA
SMAJ7.5(C)A	AP	WP	7.5	8.33	9.58	1	12.9	31	100	400	SMA
SMAJ8.0(C)A	AR	WR	8	8.89	10.23	1	13.6	29.4	50	400	SMA
SMAJ8.5(C)A	AT	WT	8.5	9.44	10.82	1	14.4	27.7	10	400	SMA
SMAJ9.0(C)A	AV	WV	9	10	11.5	1	15.4	26	5	400	SMA
SMAJ10(C)A	AX	WX	10	11.1	12.8	1	17	23.5	5	400	SMA
SMAJ11(C)A	AZ	WZ	11	12.2	14	1	18.2	22	5	400	SMA
SMAJ12C)A	BE	XE	12	13.3	15.3	1	19.9	20.1	5	400	SMA
SMAJ13(C)A	BG	XG	13	14.4	15.6	1	21.5	18.6	5	400	SMA
SMAJ14(C)A	BK	XK	14	15.6	17.9	1	23.2	17.2	5	400	SMA
SMAJ15(C)A	BM	XM	15	16.7	19.2	1	24.4	16.4	5	400	SMA
SMAJ16(C)A	BP	XP	16	17.8	20.5	1	26	15.3	5	400	SMA
SMAJ17(C)A	BR	XR	17	18.9	21.7	1	27.6	14.5	5	400	SMA
SMAJ18(C)A	BT	XT	18	20	23.3	1	29.2	13.7	5	400	SMA
SMAJ20(C)A	BV	XV	20	22.2	25.5	1	32.4	12.3	5	400	SMA
SMAJ22(C)A	BX	XX	22	24.4	28	1	35.5	11.2	5	400	SMA
SMAJ24(C)A	BZ	XZ	24	26.7	30.7	1	38.9	10.3	5	400	SMA
SMAJ26(C)A	CE	YE	26	28.9	33.2	1	42.1	9.5	5	400	SMA
SMAJ28(C)A	CG	YG	28	31.1	35.8	1	45.4	8.8	5	400	SMA
SMAJ30(C)A	CK	YK	30	33.3	38.3	1	48.4	8.3	5	400	SMA
SMAJ33(C)A	CM	YM	33	36.7	42.2	1	53.3	7.5	5	400	SMA
SMAJ36(C)A	CP	YP	36	40	46	1	58.1	6.9	5	400	SMA
SMAJ40(C)A	CR	YR	40	44.4	51.1	1	64.5	6.2	5	400	SMA

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMAJ43(C)A	CT	YT	43	47.8	54.9	1	69.4	5.7	5	400	SMA
SMAJ45(C)A	CV	YV	45	50	57.5	1	72.7	5.5	5	400	SMA
SMAJ48(C)A	CX	YX	48	53.3	61.3	1	77.4	5.2	5	400	SMA
SMAJ51(C)A	CZ	YZ	51	56.7	65.2	1	82.4	4.9	5	400	SMA
SMAJ54(C)A	RE	ZE	54	60	69	1	87.1	4.6	5	400	SMA
SMAJ58(C)A	RG	ZG	58	64.4	74.1	1	93.6	4.3	5	400	SMA
SMAJ60(C)A	RK	ZK	60	66.7	76.7	1	96.8	4.1	5	400	SMA
SMAJ64(C)A	RM	ZM	64	71.1	81.8	1	103	3.9	5	400	SMA
SMAJ70(C)A	RP	ZP	70	77.8	89.5	1	113	3.5	5	400	SMA
SMAJ75(C)A	RR	ZR	75	83.3	95.8	1	121	3.3	5	400	SMA
SMAJ78(C)A	RT	ZT	78	86.7	99.7	1	126	3.2	5	400	SMA
SMAJ85(C)A	RV	ZV	85	94.4	108.2	1	137	2.2	5	400	SMA
SMAJ90(C)A	RX	ZX	90	100	115.5	1	146	2.1	5	400	SMA
SMAJ100(C)A	RZ	ZZ	100	111	128	1	162	1.9	5	400	SMA
SMAJ110(C)A	SE	VE	110	122	140.5	1	177	1.7	5	400	SMA
SMAJ120(C)A	SG	VG	120	133	153	1	193	1.6	5	400	SMA
SMAJ130(C)A	SK	VK	130	144	165.5	1	209	1.4	5	400	SMA
SMAJ150(C)A	SM	VM	150	167	192.5	1	243	1.2	5	400	SMA
SMAJ160(C)A	SP	VP	160	178	205	1	259	1.2	5	400	SMA
SMAJ170(C)A	SR	VR	170	189	217.5	1	275	1.09	5	400	SMA
SMAJ188(C)A	ST	VT	188	209	231	1	328	0.91	5	400	SMA
SMAJ200(C)A	SV	VV	200	224	247	1	332	0.89	5	400	SMA
SMAJ220(C)A	SX	VX	220	246	272	1	352	0.8	5	400	SMA
SMAJ250(C)A	SZ	VZ	250	279	309	1	405	0.75	5	400	SMA
SMAJ300(C)A	TE	UE	300	335	371	1	486	0.7	5	400	SMA
SMAJ350(C)A	TG	UG	350	391	432	1	567	0.7	5	400	SMA

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMAJ400(C)A	TK	UK	400	447	494	1	648	0.6	5	400	SMA
SMAJ440(C)A	TM	UM	440	492	543	1	713	0.6	5	400	SMA
P6SMB6.8(C)A			5.8	6.46	7.14	10	10.5	57.1	1000	600	SMB
P6SMB7.5(C)A			6.4	7.13	7.88	10	11.3	53.1	500	600	SMB
P6SMB8.2(C)A			7	7.79	8.61	10	12.1	49.6	200	600	SMB
P6SMB9.1(C)A			7.8	8.65	9.56	1	13.4	44.7	50	600	SMB
P6SMB10(C)A			8.6	9.5	10.5	1	14.5	41.3	10	600	SMB
P6SMB11(C)A			9.4	10.45	11.55	1	15.6	38.4	5	600	SMB
P6SMB12(C)A			10.2	11.4	12.6	1	16.7	35.9	5	600	SMB
P6SMB13(C)A			11.1	12.35	13.65	1	18.2	32.9	5	600	SMB
P6SMB15(C)A			12.8	14.25	15.75	1	21.2	28.3	5	600	SMB
P6SMB16(C)A			13.6	15.2	16.8	1	22.5	26.6	5	600	SMB
P6SMB18(C)A			15.3	17.1	18.9	1	25.2	23.8	5	600	SMB
P6SMB20(C)A			17.1	19	21	1	27.7	21.6	5	600	SMB
P6SMB22(C)A			18.8	20.9	23.1	1	30.6	19.6	5	600	SMB
P6SMB24(C)A			20.5	22.8	25.2	1	33.2	18.1	5	600	SMB
P6SMB27(C)A			23.1	25.65	28.35	1	37.5	16	5	600	SMB
P6SMB30(C)A			25.6	28.5	31.5	1	41.4	14.5	5	600	SMB
P6SMB33(C)A			28.2	31.35	34.65	1	45.7	13.1	5	600	SMB
P6SMB36(C)A			30.8	34.2	37.8	1	49.9	12	5	600	SMB
P6SMB39(C)A			33.3	37.05	40.95	1	53.9	11.1	5	600	SMB
P6SMB43(C)A			36.8	40.85	45.15	1	59.3	10.1	5	600	SMB
P6SMB47(C)A			40.2	44.65	49.35	1	64.8	9.2	5	600	SMB
P6SMB51(C)A			43.6	48.45	53.55	1	70.1	8.5	5	600	SMB
P6SMB56(C)A			47.8	53.2	58.8	1	77	7.8	5	600	SMB
P6SMB62(C)A			53	58.9	65.1	1	85	7	5	600	SMB

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
P6SMB68(C)A			58.1	64.6	71.4	1	92	6.5	5	600	SMB
P6SMB75(C)A			64.1	71.25	78.75	1	103	5.8	5	600	SMB
P6SMB82(C)A			70.1	77.9	86.1	1	113	5.3	5	600	SMB
P6SMB91(C)A			77.8	86.45	95.35	1	125	4.8	5	600	SMB
P6SMB100(C)A			85.5	95	105	1	137	4.3	5	600	SMB
P6SMB110(C)A			94	104.5	115.5	1	152	3.9	5	600	SMB
P6SMB120(C)A			102	114	126	1	165	3.6	5	600	SMB
P6SMB130(C)A			111	123.5	136.5	1	179	3.3	5	600	SMB
P6SMB150(C)A			128	142.5	157.5	1	207	2.9	5	600	SMB
P6SMB160(C)A			136	152	168	1	219	2.7	5	600	SMB
P6SMB170(C)A			145	161.5	178.5	1	234	2.5	5	600	SMB
P6SMB180(C)A			154	171	189	1	246	2.4	5	600	SMB
P6SMB200(C)A			171	190	210	1	274	2.2	5	600	SMB
P6SMB220(C)A			185	209	231	1	328	1.8	5	600	SMB
P6SMB250(C)A			214	237.5	262.5	1	344	1.7	5	600	SMB
P6SMB300(C)A			256	285	315	1	414	1.4	5	600	SMB
P6SMB350(C)A			299.3	332.5	367.5	1	482	1.2	5	600	SMB
P6SMB380(C)A			324.9	361	399	1	524.4	1.1	5	600	SMB
P6SMB400(C)A			342	380	420	1	548	1.1	5	600	SMB
P6SMB440(C)A			376.2	418	462	1	607.2	1	5	600	SMB
P6SMB500(C)A			427.5	475	525	1	690	0.8	5	600	SMB
P6SMB520(C)A			444.6	494	546	1	717.6	0.8	5	600	SMB
P6SMB550(C)A			470.3	522.5	577.5	1	759	0.8	5	600	SMB
P6SMB600(C)A			513	570	630	1	828	0.7	5	600	SMB
SMBJ5.0(C)A	KE	AE	5	6.4	7.25	10	9.2	65.2	800	600	SMB
SMBJ6.0(C)A	KG	AG	6	6.67	7.67	10	10.3	58.3	800	600	SMB

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMBJ6.5(C)A	KK	AK	6.5	7.22	8.3	10	11.2	53.6	500	600	SMB
SMBJ7.0(C)A	KM	AM	7	7.78	8.95	10	12	50	200	600	SMB
SMBJ7.5(C)A	KP	AP	7.5	8.33	9.58	1	12.9	46.5	100	600	SMB
SMBJ8.0(C)A	KR	AR	8	8.89	10.23	1	13.6	44.1	50	600	SMB
SMBJ8.5(C)A	KT	AT	8.5	9.44	10.82	1	14.4	41.7	10	600	SMB
SMBJ9.0(C)A	KV	AV	9	10	11.5	1	15.4	39	5	600	SMB
SMBJ10(C)A	KX	AX	10	11.1	12.8	1	17	35.3	5	600	SMB
SMBJ11(C)A	KZ	AZ	11	12.2	14	1	18.2	33	5	600	SMB
SMBJ12C)A	LE	BE	12	13.3	15.3	1	19.9	30.2	5	600	SMB
SMBJ13(C)A	LG	BG	13	14.4	15.6	1	21.5	27.9	5	600	SMB
SMBJ14(C)A	LK	BK	14	15.6	17.9	1	23.2	25.8	5	600	SMB
SMBJ15(C)A	LM	BM	15	16.7	19.2	1	24.4	24	5	600	SMB
SMBJ16(C)A	LP	BP	16	17.8	20.5	1	26	23.1	5	600	SMB
SMBJ17(C)A	LR	BR	17	18.9	21.7	1	27.6	21.7	5	600	SMB
SMBJ18(C)A	LT	BT	18	20	23.3	1	29.2	20.5	5	600	SMB
SMBJ20(C)A	LV	BV	20	22.2	25.5	1	32.4	18.5	5	600	SMB
SMBJ22(C)A	LX	BX	22	24.4	28	1	35.5	16.9	5	600	SMB
SMBJ24(C)A	LZ	BZ	24	26.7	30.7	1	38.9	15.4	5	600	SMB
SMBJ26(C)A	ME	CE	26	28.9	33.2	1	42.1	14.2	5	600	SMB
SMBJ28(C)A	MG	CG	28	31.1	35.8	1	45.4	13.2	5	600	SMB
SMBJ30(C)A	MK	CK	30	33.3	38.3	1	48.4	12.4	5	600	SMB
SMBJ33(C)A	MM	CM	33	36.7	42.2	1	53.3	11.3	5	600	SMB
SMBJ36(C)A	MP	CP	36	40	46	1	58.1	10.3	5	600	SMB
SMBJ40(C)A	MR	CR	40	44.4	51.1	1	64.5	9.3	5	600	SMB
SMBJ43(C)A	MT	CT	43	47.8	54.9	1	69.4	8.6	5	600	SMB
SMBJ45(C)A	MV	CV	45	50	57.5	1	72.7	8.3	5	600	SMB

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMBJ48(C)A	MX	CX	48	53.3	61.3	1	77.4	7.7	5	600	SMB
SMBJ51(C)A	MZ	CZ	51	56.7	65.2	1	82.4	7.3	5	600	SMB
SMBJ54(C)A	NE	DE	54	60	69	1	87.1	6.9	5	600	SMB
SMBJ58(C)A	NG	DG	58	64.4	74.1	1	93.6	6.4	5	600	SMB
SMBJ60(C)A	NK	DK	60	66.7	76.7	1	96.8	6.2	5	600	SMB
SMBJ64(C)A	NM	DM	64	71.1	81.8	1	103	5.8	5	600	SMB
SMBJ70(C)A	NP	DP	70	77.8	89.5	1	113	5.3	5	600	SMB
SMBJ75(C)A	NR	DR	75	83.3	95.8	1	121	4.9	5	600	SMB
SMBJ78(C)A	NT	DT	78	86.7	99.7	1	126	4.7	5	600	SMB
SMBJ85(C)A	NV	DV	85	94.4	108.2	1	137	4.4	5	600	SMB
SMBJ90(C)A	NX	DX	90	100	115.5	1	146	4.1	5	600	SMB
SMBJ100(C)A	NZ	DZ	100	111	128	1	162	3.7	5	600	SMB
SMBJ110(C)A	PE	EE	110	122	140.5	1	177	3.4	5	600	SMB
SMBJ120(C)A	PG	EG	120	133	153	1	193	3.1	5	600	SMB
SMBJ130(C)A	PK	EK	130	144	165.5	1	209	2.9	5	600	SMB
SMBJ150(C)A	PM	EM	150	167	192.5	1	243	2.5	5	600	SMB
SMBJ160(C)A	PP	EP	160	178	205	1	259	2.3	5	600	SMB
SMBJ170(C)A	PR	ER	170	189	217.5	1	275	2.2	5	600	SMB
SMBJ188(C)A	PT	ET	188	209	231	1	328	2	5	600	SMB
SMBJ200(C)A	PV	EV	200	224	247	1	332	1.9	5	600	SMB
SMBJ220(C)A	PX	EX	220	246	272	1	352	1.5	5	600	SMB
SMBJ250(C)A	PZ	EZ	250	279	305	1	405	1.5	5	600	SMB
SMBJ300(C)A	QE	FE	300	335	371	1	486	1.3	5	600	SMB
SMBJ350(C)A	QG	FG	350	391	432	1	567	1.1	5	600	SMB
SMBJ400(C)A	QK	FK	400	447	494	1	648	0.9	5	600	SMB
SMBJ440(C)A	QM	FM	440	492	543	1	713	0.9	5	600	SMB

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMCJ5.0(C)A	GDE	BDE	5	6.4	7.25	10	9.2	163	1000	1500	SMC
SMCJ6.0(C)A	GDG	BDG	6	6.67	7.67	10	10.3	145.6	1000	1500	SMC
SMCJ6.5(C)A	GDK	BDK	6.5	7.22	8.3	10	11.2	133.9	500	1500	SMC
SMCJ7.0(C)A	GDM	BDM	7	7.78	8.95	10	12	125	200	1500	SMC
SMCJ7.5(C)A	GDP	BDP	7.5	8.33	9.58	1	12.9	116.3	100	1500	SMC
SMCJ8.0(C)A	GDR	BDR	8	8.89	10.23	1	13.6	110.3	50	1500	SMC
SMCJ8.5(C)A	GDT	BDT	8.5	9.44	10.82	1	14.4	104.2	20	1500	SMC
SMCJ9.0(C)A	GDV	BDV	9	10	11.5	1	15.4	97.4	10	1500	SMC
SMCJ10(C)A	GDX	BDX	10	11.1	12.8	1	17	88.2	5	1500	SMC
SMCJ11(C)A	GDZ	BDZ	11	12.2	14	1	18.2	82.4	5	1500	SMC
SMCJ12C)A	GEE	BEE	12	13.3	15.3	1	19.9	75.3	5	1500	SMC
SMCJ13(C)A	GEG	BEG	13	14.4	15.6	1	21.5	69.7	5	1500	SMC
SMCJ14(C)A	GEK	BEK	14	15.6	17.9	1	23.2	64.7	5	1500	SMC
SMCJ15(C)A	GEM	BEM	15	16.7	19.2	1	24.4	61.5	5	1500	SMC
SMCJ16(C)A	GEP	BEP	16	17.8	20.5	1	26	57.7	5	1500	SMC
SMCJ17(C)A	GER	BER	17	18.9	21.7	1	27.6	53.3	5	1500	SMC
SMCJ18(C)A	GET	BET	18	20	23.3	1	29.2	51.4	5	1500	SMC
SMCJ20(C)A	GEV	BEV	20	22.2	25.5	1	32.4	46.3	5	1500	SMC
SMCJ22(C)A	GEX	BEX	22	24.4	28	1	35.5	42.2	5	1500	SMC
SMCJ24(C)A	GEZ	BEZ	24	26.7	30.7	1	38.9	38.6	5	1500	SMC
SMCJ26(C)A	GFE	BFE	26	28.9	33.2	1	42.1	35.6	5	1500	SMC
SMCJ28(C)A	GFG	BFG	28	31.1	35.8	1	45.4	33	5	1500	SMC
SMCJ30(C)A	GFK	BFK	30	33.3	38.3	1	48.4	31	5	1500	SMC
SMCJ33(C)A	GFM	BFM	33	36.7	42.2	1	53.3	28.1	5	1500	SMC
SMCJ36(C)A	GFP	BFP	36	40	46	1	58.1	25.8	5	1500	SMC
SMCJ40(C)A	GFR	BFR	40	44.4	51.1	1	64.5	23.2	5	1500	SMC

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMCJ43(C)A	GFT	BFT	43	47.8	54.9	1	69.4	21.6	5	1500	SMC
SMCJ45(C)A	GFV	BFV	45	50	57.5	1	72.7	20.6	5	1500	SMC
SMCJ48(C)A	GFX	BFX	48	53.3	61.3	1	77.4	19.4	5	1500	SMC
SMCJ51(C)A	GFZ	BFZ	51	56.7	65.2	1	82.4	18.2	5	1500	SMC
SMCJ54(C)A	GGE	BGE	54	60	69	1	87.1	17.2	5	1500	SMC
SMCJ58(C)A	GGG	BGG	58	64.4	74.1	1	93.6	16	5	1500	SMC
SMCJ60(C)A	GGK	BGK	60	66.7	76.7	1	96.8	15.5	5	1500	SMC
SMCJ64(C)A	GGM	BGM	64	71.1	81.8	1	103	14.6	5	1500	SMC
SMCJ70(C)A	GGP	BGP	70	77.8	89.5	1	113	13.3	5	1500	SMC
SMCJ75(C)A	GGR	BGR	75	83.3	95.8	1	121	12.4	5	1500	SMC
SMCJ78(C)A	GGT	BGT	78	86.7	99.7	1	126	11.4	5	1500	SMC
SMCJ85(C)A	GGV	BGV	85	94.4	108.2	1	137	10.4	5	1500	SMC
SMCJ90(C)A	GGX	BGX	90	100	115.5	1	146	10.3	5	1500	SMC
SMCJ100(C)A	GGZ	BGZ	100	111	128	1	162	9.3	5	1500	SMC
SMCJ110(C)A	GHE	BHE	110	122	140.5	1	177	8.4	5	1500	SMC
SMCJ120(C)A	GHG	BHG	120	133	153	1	193	7.9	5	1500	SMC
SMCJ130(C)A	GHK	BHK	130	144	165.5	1	209	7.2	5	1500	SMC
SMCJ150(C)A	GHM	BHM	150	167	192.5	1	243	6.2	5	1500	SMC
SMCJ160(C)A	GHP	BHP	160	178	205	1	259	5.8	5	1500	SMC
SMCJ170(C)A	GHR	BHR	170	189	217.5	1	275	5.5	5	1500	SMC
SMCJ188(C)A	GHT	BHT	188	209	231	1	328	4.6	5	1500	SMC
SMCJ200(C)A	GHV	BHV	200	224	247	1	332	4.6	5	1500	SMC
SMCJ220(C)A	GHX	BHX	220	246	272	1	352	3.7	5	1500	SMC
SMCJ250(C)A	GHZ	BHZ	250	279	305	1	405	3.1	5	1500	SMC
SMCJ300(C)A	GJE	BJE	300	335	371	1	486	2.6	5	1500	SMC
SMCJ350(C)A	GJG	BJG	350	391	432	1	567	2.6	5	1500	SMC

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMCJ400(C)A	GJK	BJK	400	447	494	1	648	2.3	5	1500	SMC
SMCJ440(C)A	GJM	BJM	440	492	543	1	713	2.1	5	1500	SMC
SMF5.0(C)A	AE	CAE	5	6.4	7.25	10	9.2	21.7	200	200	SOD-123FL
SMF6.0(C)A	AG	CAG	6	6.67	7.67	10	10.3	19.4	200	200	SOD-123FL
SMF6.5(C)A	AK	CAK	6.5	7.22	8.3	10	11.2	17.9	150	200	SOD-123FL
SMF7.0(C)A	AM	CAM	7	7.78	8.95	10	12	16.7	75	200	SOD-123FL
SMF7.5(C)A	AP	CAP	7.5	8.33	9.58	1	12.9	15.5	50	200	SOD-123FL
SMF8.0(C)A	AR	CAR	8	8.89	10.23	1	13.6	14.7	25	200	SOD-123FL
SMF8.5(C)A	AT	CAT	8.5	9.44	10.82	1	14.4	13.9	20	200	SOD-123FL
SMF9.0(C)A	AV	CAV	9	10	11.5	1	15.4	13	10	200	SOD-123FL
SMF10(C)A	AX	CAX	10	11.1	12.8	1	17	11.8	5	200	SOD-123FL
SMF11(C)A	AZ	CAZ	11	12.2	14	1	18.2	11	1	200	SOD-123FL
SMF12(C)A	BE	CBE	12	13.3	15.3	1	19.9	10.1	1	200	SOD-123FL
SMF13(C)A	BG	CBG	13	14.4	15.6	1	21.5	9.3	1	200	SOD-123FL
SMF14(C)A	BK	CBK	14	15.6	17.9	1	23.2	8.62	1	200	SOD-123FL
SMF15(C)A	BM	CBM	15	16.7	19.2	1	24.4	8.2	1	200	SOD-123FL
SMF16(C)A	BP	CBP	16	17.8	20.5	1	26	7.69	1	200	SOD-123FL
SMF17(C)A	BR	CBR	17	18.9	21.7	1	27.6	7.25	1	200	SOD-123FL
SMF18(C)A	BT	CBT	18	20	23.3	1	29.2	6.85	1	200	SOD-123FL
SMF20(C)A	BV	CBV	20	22.2	25.5	1	32.4	6.17	1	200	SOD-123FL
SMF22(C)A	BX	CBX	22	24.4	28	1	35.5	5.63	1	200	SOD-123FL
SMF24(C)A	BZ	CBZ	24	26.7	30.7	1	38.9	5.14	1	200	SOD-123FL
SMF26(C)A	CE	CCE	26	28.9	33.2	1	42.1	4.75	1	200	SOD-123FL
SMF28(C)A	CG	CCG	28	31.1	35.8	1	45.4	4.41	1	200	SOD-123FL
SMF30(C)A	CK	CCK	30	33.3	38.3	1	48.4	4.13	1	200	SOD-123FL
SMF33(C)A	CM	CCM	33	36.7	42.2	1	53.3	3.75	1	200	SOD-123FL

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMF36(C)A	CP	CCP	36	40	46	1	58.1	3.44	1	200	SOD-123FL
SMF40(C)A	CR	CCR	40	44.4	51.1	1	64.5	3.1	1	200	SOD-123FL
SMF43(C)A	CT	CCT	43	47.8	54.9	1	69.4	2.88	1	200	SOD-123FL
SMF45(C)A	CV	CCV	45	50	57.5	1	72.7	2.75	1	200	SOD-123FL
SMF48(C)A	CX	CCX	48	53.3	61.3	1	77.4	2.58	1	200	SOD-123FL
SMF51(C)A	CZ	CCZ	51	56.7	65.2	1	82.4	2.43	1	200	SOD-123FL
SMF54(C)A	DE	CDE	54	60	69	1	87.1	2.3	1	200	SOD-123FL
SMF58(C)A	DG	CDG	58	64.4	74.1	1	93.6	2.14	1	200	SOD-123FL
SMF60(C)A	DK	CDK	60	66.7	76.7	1	96.8	2.07	1	200	SOD-123FL
SMF64(C)A	DM	CDM	64	71.1	81.8	1	103	1.94	1	200	SOD-123FL
SMF70(C)A	DP	CDP	70	77.8	89.5	1	113	1.77	1	200	SOD-123FL
SMF75(C)A	DR	CDR	75	83.3	95.8	1	121	1.65	1	200	SOD-123FL
SMF78(C)A	DT	CDT	78	86.7	99.7	1	126	1.59	1	200	SOD-123FL
SMF85(C)A	DV	CDV	85	94.4	108.2	1	137	1.46	1	200	SOD-123FL
SMF90(C)A	DX	CDX	90	100	115.5	1	146	1.37	1	200	SOD-123FL
SMF100(C)A	DZ	CDZ	100	111	128	1	162	1.23	1	200	SOD-123FL
SMF110(C)A	EE	CEE	110	122	140.5	1	177	1.13	1	200	SOD-123FL
SMF120(C)A	EG	CEG	120	133	153	1	193	1.04	1	200	SOD-123FL
SMF130(C)A	EK	CEK	130	144	165.5	1	209	0.96	1	200	SOD-123FL
SMF150(C)A	EM	CEM	150	167	192.5	1	243	0.82	1	200	SOD-123FL
SMF160(C)A	EP	CEP	160	178	205	1	259	0.77	1	200	SOD-123FL
SMF170(C)A	ER	CER	170	189	217.5	1	275	0.73	1	200	SOD-123FL
SMF180(C)A	ET	CET	180	201	222	1	328	0.91	1	200	SOD-123FL
SMF200(C)A	EX	CEX	200	224	247	1	332	0.89	5	200	SOD-123FL
SMF220(C)A	E22	CE22	220	246	272	1	352	0.8	5	200	SOD-123FL
SMF250(C)A	E25	CE25	250	279	309	1	405	0.75	5	200	SOD-123FL

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMF5.0(C)AL	AE	5CL	5	6.4	7	10	9.2	43.5(40.1)	40	400	SOD-123FL
SMF6.0(C)AL	AG	6CL	6	6.67	7.37	10	10.3	38.8(35.9)	40	400	SOD-123FL
SMF6.5(C)AL	AK	6VCL	6.5	7.22	7.98	10	11.2	35.7(33.1)	30	400	SOD-123FL
SMF7.0(C)AL	AM	7CL	7	7.78	8.6	10	12	33.3(30.9)	30	400	SOD-123FL
SMF7.5(C)AL	AP	7VCL	7.5	8.33	9.21	1	12.9	31.0(28.7)	30	400	SOD-123FL
SMF8.0(C)AL	AR	8CL	8	8.89	9.83	1	13.6	29.4(27.2)	20	400	SOD-123FL
SMF8.5AL	AT		8.5	9.44	10.4	1	14.4	27.8	10	400	SOD-123FL
SMF9.0(C)AL	AV	9CL	9	10	11.1	1	15.4	26.0(24.1)	5	400	SOD-123FL
SMF10(C)AL	AX	10CL	10	11.1	12.3	1	17	23.5	2	400	SOD-123FL
SMF11(C)AL	AZ	11CL	11	12.2	13.5	1	18.2	22	1	400	SOD-123FL
SMF12(C)AL	BE	12CL	12	13.3	14.7	1	19.9	20.1	1	400	SOD-123FL
SMF13(C)AL	BG	13CL	13	14.4	15.9	1	21.5	18.6	1	400	SOD-123FL
SMF14(C)AL	BK	14CL	14	15.6	17.2	1	23.2	17.2	1	400	SOD-123FL
SMF15(C)AL	BM	15CL	15	16.7	18.5	1	24.4	16.4	1	400	SOD-123FL
SMF17AL	BR		17	18.9	20.9	1	27.6	14.5	1	400	SOD-123FL
SMF18(C)AL	BT	18CL	18	20	22.1	1	29.2	13.7	1	400	SOD-123FL
SMF20(C)AL	BV	20CL	20	22.2	24.5	1	32.4	12.3	1	400	SOD-123FL
SMF22(C)AL	BX	22CL	22	24.4	26.9	1	35.5	11.3	1	400	SOD-123FL
SMF24(C)AL	BZ	24CL	24	26.7	29.5	1	38.9	10.3	1	400	SOD-123FL
SMF26(C)AL	CE	26CL	26	28.9	31.9	1	42.1	9.5	1	400	SOD-123FL
SMF28(C)AL	CG	28CL	28	31.1	34.4	1	45.4	8.8	1	400	SOD-123FL
SMF30(C)AL	CK	30CL	30	33.3	36.8	1	48.4	8.3	1	400	SOD-123FL
SMF33(C)AL	CM	33CL	33	36.7	40.6	1	53.3	7.5	1	400	SOD-123FL

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SMF36(C)AL	CP	36CL	36	40	44.2	1	58.1	6.9	1	400	SOD-123FL
SMF40(C)AL	CR	40CL	40	44.4	49.1	1	64.5	6.2	1	400	SOD-123FL
SMF43(C)AL	CT	43CL	43	47.8	52.8	1	69.4	5.8	1	400	SOD-123FL
SMF45(C)AL	CV	45CL	45	50	55.3	1	72.7	5.5	1	400	SOD-123FL
SMF48(C)AL	CX	48CL	48	53.3	58.9	1	77.4	5.2	1	400	SOD-123FL
SMF51AL	CZ		51	56.7	62.7	1	82.4	4.9	1	400	SOD-123FL
SMF58AL	DE		58	64.4	71.2	1	93.6	4.3	1	400	SOD-123FL
SMF60AL	DG		60	66.7	73.7	1	96.8	4.1	1	400	SOD-123FL
SMF64AL	DM		64	71.1	78.6	1	103	3.9	1	400	SOD-123FL
SMF70AL	DP		70	77.8	86	1	113	3.5	1	400	SOD-123FL
SMF75AL	DR		75	83.3	92.1	1	121	3.3	1	400	SOD-123FL
SMF78AL	DT		78	86.7	95.8	1	126	3.2	1	400	SOD-123FL
SMF85AL	DV		85	94.4	104	1	137	2.9	1	400	SOD-123FL
SM4F5.0(C)A	F5.0A	F5.0CA	5	6.4	7.07	10	9.2	43.38	800	400	SOD-123FL
SM4F6.0(C)A	F6.0A	F6.0CA	6	6.67	7.37	10	10.3	38.83	800	400	SOD-123FL
SM4F6.5(C)A	F6.5A	F6.5CA	6.5	7.22	7.98	10	11.2	35.71	500	400	SOD-123FL
SM4F7.0(C)A	F7.0A	F7.0CA	7	7.78	8.6	10	12	33.33	200	400	SOD-123FL
SM4F7.5(C)A	F7.5A	F7.5CA	7.5	8.33	9.21	1	12.9	31.01	100	400	SOD-123FL
SM4F8.0(C)A	F8.0A	F8.0CA	8	8.89	9.83	1	13.6	29.41	50	400	SOD-123FL
SM4F8.5(C)A	F8.5A	F8.5CA	8.5	9.44	10.4	1	14.4	27.78	10	400	SOD-123FL
SM4F9.0(C)A	F9.0A	F9.0CA	9	10	11.1	1	15.4	25.97	5	400	SOD-123FL
SM4F10(C)A	F10A	F10CA	10	11.1	12.3	1	17	23.52	2.5	400	SOD-123FL
SM4F11(C)A	F11A	F11CA	11	12.2	13.5	1	18.2	21.98	2.5	400	SOD-123FL

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SM4F12(C)A	F12A	F12CA	12	13.3	17.7	1	19.9	20.1	2.5	400	SOD-123FL
SM4F13(C)A	F13A	F13CA	13	14.4	15.9	1	21.5	18.6	1	400	SOD-123FL
SM4F14(C)A	F14A	F14CA	14	15.6	17.2	1	23.2	17.24	1	400	SOD-123FL
SM4F15(C)A	F15A	F15CA	15	16.7	18.5	1	24.4	16.4	1	400	SOD-123FL
SM4F16(C)A	F16A	F16CA	16	17.8	19.7	1	26	15.38	1	400	SOD-123FL
SM4F17(C)A	F17A	F17CA	17	18.9	20.9	1	27.6	14.5	1	400	SOD-123FL
SM4F18(C)A	F18A	F18CA	18	20	22.1	1	29.2	13.7	1	400	SOD-123FL
SM4F19(C)A	F19A	F19CA	19	21.1	23.3	1	30.6	13.08	1	400	SOD-123FL
SM4F20(C)A	F20A	F20CA	20	22.2	24.5	1	32.4	13.08	1	400	SOD-123FL
SM4F22(C)A	F22A	F22CA	22	24.4	26.9	1	35.5	12.35	1	400	SOD-123FL
SM4F24(C)A	F24A	F24CA	24	26.7	29.5	1	38.9	10.28	1	400	SOD-123FL
SM4F26(C)A	F26A	F26CA	26	28.9	31.9	1	42.1	9.5	1	400	SOD-123FL
SM4F28(C)A	F28A	F28CA	28	31.1	34.4	1	45.4	8.82	1	400	SOD-123FL
SM4F30(C)A	F30A	F30CA	30	33.3	36.8	1	48.4	8.26	1	400	SOD-123FL
SM4F33(C)A	F33A	F33CA	33	36.7	40.6	1	53.3	7.5	1	400	SOD-123FL
SM4F36(C)A	F36A	F36CA	36	40	44.2	1	58.1	6.88	1	400	SOD-123FL
SM4F40(C)A	F40A	F40CA	40	44.4	49.1	1	64.5	6.2	1	400	SOD-123FL
SM4F43(C)A	F43A	F43CA	43	47.8	52.8	1	69.4	5.76	1	400	SOD-123FL
SM4F45(C)A	F45A	F45CA	45	50	55.3	1	72.7	5.5	1	400	SOD-123FL
SM4F48A	F48A		48	53.3	58.9	1	77.4	5.16	1	400	SOD-123FL
SM4F51A	F51A		51	56.7	62.7	1	82.4	4.86	1	400	SOD-123FL
SM4F54A	F54A		54	60	66.3	1	87.1	4.6	1	400	SOD-123FL
SM4F58A	F58A		58	64.4	71.2	1	93.6	4.28	1	400	SOD-123FL

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

TVS瞬态电压抑制二极管

型号	印字Marking		工作电压	击穿电压VBR(V)@IT			钳位电压	峰值电流	漏电流(uA)	峰值功率	封装
Type	A(UNI)	CA(BI)	VRWM(V)	最小值	最大值	IT(mA)	VC(V)@IPP	IPP(A)	IR@VRWM	PPK(W)	Package
SM4F60A	F60A		60	66.7	73.7	1	96.8	4.14	1	400	SOD-123FL
SM4F64A	F64A		64	71.1	78.6	1	103	3.88	1	400	SOD-123FL
SM4F70A	F70A		70	77.8	86	1	113	3.54	1	400	SOD-123FL
SM4F75A	F75A		75	83.3	92.1	1	121	3.3	1	400	SOD-123FL
SM4F78A	F78A		78	86.7	95.8	1	126	3.18	1	400	SOD-123FL
SM4F80A	F80A		80	88.8	97.6	1	129	3.1	1	400	SOD-123FL
SM4F85A	F85A		85	94.4	104	1	137	2.92	1	400	SOD-123FL
SM4F90A	F90A		90	100	111	1	146	2.74	1	400	SOD-123FL
SM4F100A	F110A		100	111	123	1	162	2.46	1	400	SOD-123FL

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
F1A	F1A	30	150	1000	50	1.3	5	SOD-123FL
F1B	F1B	30	150	1000	100	1.3	5	SOD-123FL
F1D	F1D	30	150	1000	200	1.3	5	SOD-123FL
F1G	F1G	30	150	1000	400	1.3	5	SOD-123FL
F1J	F1J	30	250	1000	600	1.3	5	SOD-123FL
F1K	F1K	30	500	1000	800	1.3	5	SOD-123FL
F1M	F1M	30	500	1000	1000	1.3	5	SOD-123FL
FR104W	F4	30	150	1000	400	1.3	5	SOD-123FL
FR105W	F5	30	250	1000	600	1.3	5	SOD-123FL
FR106W	F6	30	500	1000	800	1.3	5	SOD-123FL
FR107W	F7	30	500	1000	1000	1.3	5	SOD-123FL
SGP1RWS	R1	15	150	1000	50	1.3	5	SOD-323
SGP2RWS	R2	15	150	1000	100	1.3	5	SOD-323
SGP3RWS	R3	15	150	1000	200	1.3	5	SOD-323
SGP4RWS	R4	15	150	1000	400	1.3	5	SOD-323
SGP5RWS	R5	15	250	1000	600	1.3	5	SOD-323
SGP6RWS	R6	15	500	1000	800	1.3	5	SOD-323
SGP7RWS	R7	15	500	1000	1000	1.3	5	SOD-323
RS1A	RS1A	30	150	1000	50	1.3	5	SMA
RS1B	RS1B	30	150	1000	100	1.3	5	SMA
RS1D	RS1D	30	150	1000	200	1.3	5	SMA
RS1G	RS1G	30	150	1000	400	1.3	5	SMA
RS1J	RS1J	30	250	1000	600	1.3	5	SMA
RS1K	RS1K	30	500	1000	800	1.3	5	SMA
RS1M	RS1M	30	500	1000	1000	1.3	5	SMA
RS1AF	RS1A	30	150	1000	50	1.3	5	SMAF
RS1BF	RS1B	30	150	1000	100	1.3	5	SMAF
RS1DF	RS1D	30	150	1000	200	1.3	5	SMAF

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
RS1GF	RS1G	30	150	1000	400	1.3	5	SMAF
RS1JF	RS1J	30	250	1000	600	1.3	5	SMAF
RS1KF	RS1K	30	500	1000	800	1.3	5	SMAF
RS1MF	RS1M	30	500	1000	1000	1.3	5	SMAF
RS2A	RS2A	50	150	2000	50	1.3	5	SMA
RS2B	RS2B	50	150	2000	100	1.3	5	SMA
RS2D	RS2D	50	150	2000	200	1.3	5	SMA
RS2G	RS2G	50	150	2000	400	1.3	5	SMA
RS2J	RS2J	50	250	2000	600	1.3	5	SMA
RS2K	RS2K	50	500	2000	800	1.3	5	SMA
RS2M	RS2M	50	500	2000	1000	1.3	5	SMA
RS2AF	RS2A	50	150	2000	50	1.3	5	SMAF
RS2BF	RS2B	50	150	2000	100	1.3	5	SMAF
RS2DF	RS2D	50	150	2000	200	1.3	5	SMAF
RS2GF	RS2G	50	150	2000	400	1.3	5	SMAF
RS2JF	RS2J	50	250	2000	600	1.3	5	SMAF
RS2KF	RS2K	50	500	2000	800	1.3	5	SMAF
RS2MF	RS2M	50	500	2000	1000	1.3	5	SMAF
RS2AB	RS2A	50	150	2000	50	1.3	5	SMB
RS2BB	RS2B	50	150	2000	100	1.3	5	SMB
RS2DB	RS2D	50	150	2000	200	1.3	5	SMB
RS2GB	RS2G	50	150	2000	400	1.3	5	SMB
RS2JB	RS2J	50	250	2000	600	1.3	5	SMB
RS2KB	RS2K	50	500	2000	800	1.3	5	SMB
RS2MB	RS2M	50	500	2000	1000	1.3	5	SMB
RS2ABF	RS2AB	60	150	2000	50	1.3	5	SMBF
RS2BBF	RS2BB	60	150	2000	100	1.3	5	SMBF
RS2DBF	RS2DB	60	150	2000	200	1.3	5	SMBF

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
RS2GBF	RS2GB	60	150	2000	400	1.3	5	SMBF
RS2JBF	RS2JB	60	250	2000	600	1.3	5	SMBF
RS2KBF	RS2KB	60	500	2000	800	1.3	5	SMBF
RS2MBF	RS2MB	60	500	2000	1000	1.3	5	SMBF
RS3AF	RS3A	80	150	3000	50	1.3	5	SMAF
RS3BF	RS3B	80	150	3000	100	1.3	5	SMAF
RS3DF	RS3D	80	150	3000	200	1.3	5	SMAF
RS3GF	RS3G	80	150	3000	400	1.3	5	SMAF
RS3JF	RS3J	80	250	3000	600	1.3	5	SMAF
RS3KF	RS3K	80	500	3000	800	1.3	5	SMAF
RS3MF	RS3M	80	500	3000	1000	1.3	5	SMAF
RS3ABF	RS3AB	100	150	3000	50	1.3	5	SMBF
RS3BBF	RS3BB	100	150	3000	100	1.3	5	SMBF
RS3DBF	RS3DB	100	150	3000	200	1.3	5	SMBF
RS3GBF	RS3GB	100	150	3000	400	1.3	5	SMBF
RS3JBF	RS3JB	100	250	3000	600	1.3	5	SMBF
RS3KBF	RS3KB	100	500	3000	800	1.3	5	SMBF
RS3MBF	RS3MB	100	500	3000	1000	1.3	5	SMBF
RS3AB	RS3A	100	150	3000	50	1.3	5	SMB
RS3BB	RS3B	100	150	3000	100	1.3	5	SMB
RS3DB	RS3D	100	150	3000	200	1.3	5	SMB
RS3GB	RS3G	100	150	3000	400	1.3	5	SMB
RS3JB	RS3J	100	250	3000	600	1.3	5	SMB
RS3KB	RS3K	100	500	3000	800	1.3	5	SMB
RS3MB	RS3M	100	500	3000	1000	1.3	5	SMB
RS5AB	RS5A	150	150	5000	50	1.3	5	SMB
RS5BB	RS5B	150	150	5000	100	1.3	5	SMB
RS5DB	RS5D	150	150	5000	200	1.3	5	SMB

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
RS5GB	RS5G	150	150	5000	400	1.3	5	SMB
RS5JB	RS5J	150	250	5000	600	1.3	5	SMB
RS5KB	RS5K	150	500	5000	800	1.3	5	SMB
RS5MB	RS5M	150	500	5000	1000	1.3	5	SMB
RS3AC	RS3A	100	150	3000	50	1.3	10	SMC
RS3BC	RS3B	100	150	3000	100	1.3	10	SMC
RS3DC	RS3D	100	150	3000	200	1.3	10	SMC
RS3GC	RS3G	100	250	3000	400	1.3	10	SMC
RS3JC	RS3J	100	500	3000	600	1.3	10	SMC
RS3KC	RS3K	100	500	3000	800	1.3	10	SMC
RS3MC	RS3M	100	500	3000	1000	1.3	10	SMC
US1AL	U1A	30	50	1000	50	1	5	SOD-123FL
US1BL	U1B	30	50	1000	100	1	5	SOD-123FL
US1DL	U1D	30	50	1000	200	1	5	SOD-123FL
US1GL	U1G	30	50	1000	400	1.3	5	SOD-123FL
US1JL	U1J	30	75	1000	600	1.7	5	SOD-123FL
US1KL	U1K	30	75	1000	800	1.7	5	SOD-123FL
US1ML	U1M	30	75	1000	1000	1.7	5	SOD-123FL
US1JF	US1J	30	75	1000	600	1.7	5	SMAF
US1KF	US1K	30	75	1000	800	1.7	5	SMAF
US1MF	US1M	30	75	1000	1000	1.7	5	SMAF
US2AF	US2A	60	50	2000	50	1	5	SMAF
US2BF	US2B	60	50	2000	100	1	5	SMAF
US2DF	US2D	60	50	2000	200	1	5	SMAF
US2GF	US2G	60	50	2000	400	1.3	5	SMAF
US2JF	US2J	60	75	2000	600	1.7	5	SMAF
US2KF	US2K	60	75	2000	800	1.7	5	SMAF
US2MF	US2M	60	75	2000	1000	1.7	5	SMAF

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
US3AF	US3A	80	50	3000	50	1	5	SMAF
US3BF	US3B	80	50	3000	100	1	5	SMAF
US3DF	US3D	80	50	3000	200	1	5	SMAF
US3GF	US3G	80	50	3000	400	1.3	5	SMAF
US3JF	US3J	80	75	3000	600	1.68	5	SMAF
US3KF	US3K	80	75	3000	800	1.68	5	SMAF
US3MF	US3M	80	75	3000	1000	1.68	5	SMAF
US2ABF	US2AB	60	50	2000	50	1	5	SMBF
US2BBF	US2BB	60	50	2000	100	1	5	SMBF
US2DBF	US2DB	60	50	2000	200	1	5	SMBF
US2GBF	US2GB	60	50	2000	400	1.3	5	SMBF
US2JBF	US2JB	60	75	2000	600	1.7	5	SMBF
US2KBF	US2KB	60	75	2000	800	1.7	5	SMBF
US2MBF	US2MB	60	75	2000	1000	1.7	5	SMBF
US3AB	US3A	100	50	3000	50	1	10	SMB
US3BB	US3B	100	50	3000	100	1	10	SMB
US3DB	US3D	100	50	3000	200	1	10	SMB
US3GB	US3G	100	50	3000	400	1.3	10	SMB
US3JB	US3J	100	75	3000	600	1.68	10	SMB
US3KB	US3K	100	75	3000	800	1.68	10	SMB
US3MB	US3M	100	75	3000	1000	1.68	10	SMB
US3ABF	US3AB	100	50	3000	50	1	10	SMBF
US3BBF	US3BB	100	50	3000	100	1	10	SMBF
US3DBF	US3DB	100	50	3000	200	1	10	SMBF
US3GBF	US3GB	100	50	3000	400	1.3	10	SMBF
US3JBF	US3JB	100	75	3000	600	1.68	10	SMBF
US3KBF	US3KB	100	75	3000	800	1.68	10	SMBF
US3MBF	US3MB	100	75	3000	1000	1.68	10	SMBF

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
US5ABF	US5AB	150	50	5000	50	1	5	SMBF
US5BBF	US5BB	150	50	5000	100	1	5	SMBF
US5DBF	US5DB	150	50	5000	200	1	5	SMBF
US5GBF	US5GB	150	50	5000	400	1.3	5	SMBF
US5JBF	US5JB	150	75	5000	600	1.68	5	SMBF
US5KBF	US5KB	150	75	5000	800	1.68	5	SMBF
US5MBF	US5MB	150	75	5000	1000	1.68	5	SMBF
US1A	US1A	30	50	1000	50	1	5	SMA
US1B	US1B	30	50	1000	100	1	5	SMA
US1D	US1D	30	50	1000	200	1	5	SMA
US1G	US1G	30	50	1000	400	1.3	5	SMA
US1J	US1J	30	75	1000	600	1.65	5	SMA
US1K	US1K	30	75	1000	800	1.65	5	SMA
US1M	US1M	30	75	1000	1000	1.65	5	SMA
US2A	US2A	50	50	2000	50	1	5	SMA
US2B	US2B	50	50	2000	100	1	5	SMA
US2D	US2D	50	50	2000	200	1	5	SMA
US2G	US2G	50	50	2000	400	1.3	5	SMA
US2J	US2J	50	75	2000	600	1.65	5	SMA
US2K	US2K	50	75	2000	800	1.65	5	SMA
US2M	US2M	50	75	2000	1000	1.65	5	SMA
US2AB	US2A	50	50	2000	50	1	5	SMB
US2BB	US2B	50	50	2000	100	1	5	SMB
US2DB	US2D	50	50	2000	200	1	5	SMB
US2GB	US2G	50	50	2000	400	1.3	5	SMB
US2JB	US2J	50	75	2000	600	1.65	5	SMB
US2KB	US2K	50	75	2000	800	1.65	5	SMB
US2MB	US2M	50	75	2000	1000	1.65	5	SMB

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
US3AB	US3A	90	50	3000	50	1	5	SMB
US3BB	US3B	90	50	3000	100	1	5	SMB
US3DB	US3D	90	50	3000	200	1	5	SMB
US3GB	US3G	90	50	3000	400	1.3	5	SMB
US3JB	US3J	90	75	3000	600	1.85	5	SMB
US3KB	US3K	90	75	3000	800	1.85	5	SMB
US3MB	US3M	90	75	3000	1000	1.85	5	SMB
US5AB	US5A	100	50	5000	50	1	5	SMB
US5BB	US5B	100	50	5000	100	1	5	SMB
US5DB	US5D	100	50	5000	200	1	5	SMB
US5GB	US5G	100	50	5000	400	1.3	5	SMB
US5JB	US5J	100	75	5000	600	1.65	5	SMB
US5KB	US5K	100	75	5000	800	1.65	5	SMB
US5MB	US5M	100	75	5000	1000	1.65	5	SMB
US3AC	US3A	90	50	3000	50	1	5	SMC
US3BC	US3B	90	50	3000	100	1	5	SMC
US3DC	US3D	90	50	3000	200	1	5	SMC
US3GC	US3G	90	50	3000	400	1.3	5	SMC
US3JC	US3J	90	75	3000	600	1.7	5	SMC
US3KC	US3K	90	75	3000	800	1.7	5	SMC
US3MC	US3M	90	75	3000	1000	1.7	5	SMC
US5A	US5A	120	35	5000	50	0.95	10	SMC
US5B	US5B	120	35	5000	100	0.95	10	SMC
US5D	US5D	120	35	5000	200	0.95	10	SMC
US5G	US5G	120	35	5000	400	1.25	10	SMC
US5J	US5J	120	35	5000	600	1.7	10	SMC
US5K	US5K	120	50	5000	800	1.7	10	SMC
US5M	US5M	120	50	5000	1000	1.7	10	SMC

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
ES1AW	E1A	30	35	1000	50	0.95	5	SOD-123FL
ES1BW	E1B	30	35	1000	100	0.95	5	SOD-123FL
ES1CW	E1C	30	35	1000	150	0.95	5	SOD-123FL
ES1DW	E1D	30	35	1000	200	0.95	5	SOD-123FL
ES1EW	E1E	30	35	1000	300	1.25	5	SOD-123FL
ES1GW	E1G	30	35	1000	400	1.25	5	SOD-123FL
ES1JW	E1J	30	35	1000	600	1.7	5	SOD-123FL
ES1AF	ES1A	30	35	1000	50	0.95	5	SMAF
ES1BF	ES1B	30	35	1000	100	0.95	5	SMAF
ES1CF	ES1C	30	35	1000	150	0.95	5	SMAF
ES1DF	ES1D	30	35	1000	200	0.95	5	SMAF
ES1EF	ES1E	30	35	1000	300	1.25	5	SMAF
ES1GF	ES1G	30	35	1000	400	1.25	5	SMAF
ES1JF	ES1J	30	35	1000	600	1.7	5	SMAF
ES1KF	ES1K	30	35	1000	800	1.7	5	SMAF
ES2AF	ES2A	50	35	2000	50	1	5	SMAF
ES2BF	ES2B	50	35	2000	100	1	5	SMAF
ES2CF	ES2C	50	35	2000	150	1	5	SMAF
ES2DF	ES2D	50	35	2000	200	1	5	SMAF
ES2EF	ES2E	50	35	2000	300	1.25	5	SMAF
ES2GF	ES2G	50	35	2000	400	1.25	5	SMAF
ES2JF	ES2J	50	35	2000	600	1.7	5	SMAF
ES2KF	ES2K	50	35	2000	800	1.7	5	SMAF
ES3AF	ES3A	80	35	3000	50	1	5	SMAF
ES3BF	ES3B	80	35	3000	100	1	5	SMAF
ES3CF	ES3C	80	35	3000	150	1	5	SMAF
ES3DF	ES3D	80	35	3000	200	1	5	SMAF
ES3EF	ES3E	80	35	3000	300	1.25	5	SMAF

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
ES3GF	ES3G	80	35	3000	400	1.25	5	SMAF
ES3JF	ES3J	80	35	3000	600	1.68	5	SMAF
ES2ABF	ES2AB	50	35	2000	50	1	5	SMBF
ES2BBF	ES2BB	50	35	2000	100	1	5	SMBF
ES2CBF	ES2CB	50	35	2000	150	1	5	SMBF
ES2DBF	ES2DB	50	35	2000	200	1	5	SMBF
ES2EBF	ES2EB	50	35	2000	300	1.25	5	SMBF
ES2GBF	ES2GB	50	35	2000	400	1.25	5	SMBF
ES2JBF	ES2JB	50	35	2000	600	1.7	5	SMBF
ES2KBF	ES2KB	50	35	2000	800	1.7	5	SMBF
ES3ABF	ES3AB	80	35	3000	50	1	5	SMBF
ES3BBF	ES3BB	80	35	3000	100	1	5	SMBF
ES3CBF	ES3CB	80	35	3000	150	1	5	SMBF
ES3DBF	ES3DB	80	35	3000	200	1	5	SMBF
ES3EBF	ES3EB	80	35	3000	300	1.25	5	SMBF
ES3GBF	ES3GB	80	35	3000	400	1.25	5	SMBF
ES3JBF	ES3JB	80	35	3000	600	1.7	5	SMBF
ES5ABF	ES5AB	150	35	5000	50	1	10	SMBF
ES5BBF	ES5BB	150	35	5000	100	1	10	SMBF
ES5CBF	ES5CB	150	35	5000	150	1	10	SMBF
ES5DBF	ES5DB	150	35	5000	200	1	10	SMBF
ES5EBF	ES5EB	150	35	5000	300	1.25	10	SMBF
ES5GBF	ES5GB	150	35	5000	400	1.25	10	SMBF
ES5JBF	ES5JB	150	35	5000	600	1.7	10	SMBF
ES1A	ES1A	30	35	1000	50	0.95	5	SMA
ES1B	ES1B	30	35	1000	100	0.95	5	SMA
ES1C	ES1C	30	35	1000	150	0.95	5	SMA
ES1D	ES1D	30	35	1000	200	0.95	5	SMA

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
ES1E	ES1E	30	35	1000	300	1.25	5	SMA
ES1G	ES1G	30	35	1000	400	1.25	5	SMA
ES1J	ES1J	30	35	1000	600	1.7	5	SMA
ES1K	ES1K	30	35	1000	800	1.7	5	SMA
ES2AA	ES2A	50	35	2000	50	1	5	SMA
ES2BA	ES2B	50	35	2000	100	1	5	SMA
ES2CA	ES2C	50	35	2000	150	1	5	SMA
ES2DA	ES2D	50	35	2000	200	1	5	SMA
ES2EA	ES2E	50	35	2000	300	1.25	5	SMA
ES2GA	ES2G	50	35	2000	400	1.25	5	SMA
ES2JA	ES2J	50	35	2000	600	1.68	5	SMA
ES2KA	ES2K	50	35	2000	800	1.68	5	SMA
ES2AB	ES2A	60	35	2000	50	0.95	5	SMB
ES2BB	ES2B	60	35	2000	100	0.95	5	SMB
ES2CB	ES2C	60	35	2000	150	0.95	5	SMB
ES2DB	ES2D	60	35	2000	200	0.95	5	SMB
ES2EB	ES2E	60	35	2000	300	1.25	5	SMB
ES2GB	ES2G	60	35	2000	400	1.25	5	SMB
ES2JB	ES2J	60	35	2000	600	1.7	5	SMB
ES2KB	ES2K	60	35	2000	800	1.7	5	SMB
ES3AB	ES3A	80	35	3000	50	1	5	SMB
ES3BB	ES3B	80	35	3000	100	1	5	SMB
ES3CB	ES3C	80	35	3000	150	1	5	SMB
ES3DB	ES3D	80	35	3000	200	1	5	SMB
ES3EB	ES3E	80	35	3000	300	1.4	5	SMB
ES3GB	ES3G	80	35	3000	400	1.4	5	SMB
ES3JB	ES3J	80	35	3000	600	1.7	5	SMB
ES5AB	ES5A	120	35	5000	50	0.95	5	SMB

快特快超快恢复二极管

型号	印字	浪涌电流	恢复时间	工作电流	反向耐压	正向压降	反向漏流	封装形式
Type	Marking	I_{FSM}(A)	Trr(nS)	IO(mA)	V_R(V)	V_F(V)	I_R(μA)	Package
ES5BB	ES5B	120	35	5000	100	0.95	5	SMB
ES5CB	ES5C	120	35	5000	150	0.95	5	SMB
ES5DB	ES5D	120	35	5000	200	0.95	5	SMB
ES5EB	ES5E	120	35	5000	300	1.25	5	SMB
ES5GB	ES5G	120	35	5000	400	1.25	5	SMB
ES5JB	ES5J	120	35	5000	600	1.7	5	SMB
MURS320B	MURS320	100	35	3000	200	0.92	5	SMB
MURS340B	MURS340	100	50	3000	400	1.25	5	SMB
MURS360B	MURS360	100	50	3000	600	1.25	5	SMB
ES3AC	ES3A	90	35	3000	50	1	5	SMC
ES3BC	ES3B	90	35	3000	100	1	5	SMC
ES3CC	ES3C	90	35	3000	150	1	5	SMC
ES3DC	ES3D	90	35	3000	200	1	5	SMC
ES3EC	ES3E	90	35	3000	300	1.25	5	SMC
ES3GC	ES3G	90	35	3000	400	1.25	5	SMC
ES3JC	ES3J	100	35	3000	600	1.7	10	SMC
ES3KC	ES3K	100	35	3000	800	1.7	10	SMC
ES5AC	ES5A	120	35	5000	50	1	5	SMC
ES5BC	ES5B	120	35	5000	100	1	5	SMC
ES5CC	ES5C	120	35	5000	150	1	5	SMC
ES5DC	ES5D	120	35	5000	200	1	5	SMC
ES5EC	ES5E	120	35	5000	300	1.25	5	SMC
ES5GC	ES5G	120	35	5000	400	1.25	5	SMC
ES5JC	ES5J	120	35	5000	600	1.68	5	SMC

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

三端稳压IC

型号	耗散功率	输出电压	输出电流	静态电流	最高耐压输入电压	落差电压	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_O(V)	I_O(mA)	Iq(uA)	Vin(V)	Vdr(mV)	Acc	Marking	Package	Feature
FS6206-1.5V	300	1.5	100	4	7.5	100	2%	65E9	SOT-23	低落差电压
FS6206-1.8V	300	1.8	100	4	7.8	80	2%	65K5	SOT-23	低落差电压
FS6206-2.5V	300	2.5	100	4	8.5	60	2%	65T5	SOT-23	低落差电压
FS6206-2.8V	300	2.8	100	4	8.8	60	2%	65X5	SOT-23	低落差电压
FS6206-3.0V	300	3.0	100	4	9	50	2%	65Z5	SOT-23	低落差电压
FS6206-3.3V	300	3.3	100	4	9.3	40	2%	662K	SOT-23	低落差电压
FS6206-5.0V	300	5	100	4	11	30	2%	66MX	SOT-23	低落差电压
FSS7130	300	3.0	100	2	24	100	3%	7130	SOT-23-3L	高输入电压
FS7130	300	3.0	100	2	24	100	3%	7130	SOT-89	高输入电压
FSS7133	300	3.3	100	2	24	100	3%	7133	SOT-23-3L	高输入电压
FS7133	300	3.3	100	2	24	100	3%	7133	SOT-89	高输入电压
FSS7144	200	4.4	100	1.5	24	100	2%	7144	SOT-23-3L	高输入电压
FS7144	300	4.4	100	1.5	24	100	2%	7144	SOT-89	高输入电压
FSS7150	300	5.0	100	2	24	100	3%	7150	SOT-23-3L	高输入电压
FS7150	300	5.0	100	2	24	100	3%	7150	SOT-89	高输入电压
FSS7330	400	3.0	300	1.5	20	300	2%	7330	SOT-23-3L	高输入电压
FS7330	400	3.0	300	1.5	20	300	2%	7330	SOT-89	高输入电压
FSS7333	400	3.3	300	1.5	20	300	2%	7333	SOT-23-3L	高输入电压
FS7333	400	3.3	300	1.5	20	300	2%	7333	SOT-89	高输入电压
FSS7350	400	5.0	300	1.5	20	300	2%	7350	SOT-23-3L	高输入电压
FS7350	400	5.0	300	1.5	20	300	2%	7350	SOT-89	高输入电压
FSS7530	400	3.0	100	2	24	100	3%	7530	SOT-23-3L	高输入电压
FS7530	400	3.0	100	2	24	100	3%	7530	SOT-89	高输入电压

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

三端稳压IC

型号	耗散功率	输出电压	输出电流	静态电流	最高耐压输入电压	落差电压	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_O(V)	I_O(mA)	Iq(uA)	Vin(V)	Vdr(mV)	Acc	Marking	Package	Feature
FSS7533	400	3.3	100	2	24	100	3%	7533	SOT-23-3L	高输入电压
FS7533	400	3.3	100	2	24	100	3%	7533	SOT-89	高输入电压
FSS7536	400	3.6	100	2	24	100	3%	7536	SOT-23-3L	高输入电压
FS7536	400	3.6	100	2	24	100	3%	7536	SOT-89	高输入电压
FSS7540	400	4.0	100	2	24	100	3%	7540	SOT-23-3L	高输入电压
FS7540	400	4.0	100	2	24	100	3%	7540	SOT-89	高输入电压
FSS7544	400	4.4	100	2	24	100	3%	7544	SOT-23-3L	高输入电压
FS7544	400	4.4	100	2	24	100	3%	7544	SOT-89	高输入电压
FSS7550	400	5.0	100	2	24	100	3%	7550	SOT-23-3L	高输入电压
FS7550	400	5.0	100	2	24	100	3%	7550	SOT-89	高输入电压
FS78L33	600	3.3	200	2000	35	1700	4%	78L33	SOT-89	高输入电压
FSS78L05M	250	5.0	100	3800	35	1700	4%	L05	SOT-23	高输入电压
FS78L05	600	5.0	100	3800	35	1700	4%	78L05	SOT-89	高输入电压
FSS78L06M	250	6.0	100	3800	35	1700	4%	L06	SOT-23	高输入电压
FS78L06	600	6.0	100	3800	35	1700	4%	78L06	SOT-89	高输入电压
FSS78L08M	225	8.0	100	4300	35	1700	4%	78L08	SOT-23	高输入电压
FS78L08	500	8.0	100	4300	35	1700	4%	78L08	SOT-89	高输入电压
FSS78L09M	225	9.0	100	4300	35	1700	4.5%	78L09	SOT-23	高输入电压
FS78L09	500	9.0	100	4300	35	1700	4.5%	78L09	SOT-89	高输入电压
FSS78L12M	225	12.0	100	4300	35	1700	4.5%	78L12	SOT-23	高输入电压
FS78L12	600	12.0	100	2000	40	1700	4.5%	78L12	SOT-89	高输入电压
FSS78L15M	225	15.0	100	4300	35	1700	4.5%	78L15	SOT-23	高输入电压

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

三端稳压IC

型号	耗散功率	输出电压	输出电流	静态电流	最高耐压输入电压	落差电压	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_O(V)	I_O(mA)	Iq(uA)	Vin(V)	Vdr(mV)	Acc	Marking	Package	Feature
FS78L15	500	15.0	100	4300	35	1700	4.5%	78L15	SOT-89	高输入电压
FSS79L05M	250	-5.0	-100	3800	-30	-1700	4%	9L05	SOT-23	高输入电压
FS79L05	600	-5.0	-100	3800	-30	-1700	4%	79L05	SOT-89	高输入电压
FSS79L06M	250	-6.0	-100	3800	-30	-1700	4%	9L06	SOT-23	高输入电压
FS79L06	600	-6.0	-100	3800	-30	-1700	4%	79L06	SOT-89	高输入电压
FSS79L09M	225	-9.0	-100	4300	-30	-1700	4.5%	79L09	SOT-23	高输入电压
FS79L09	500	-9.0	-100	4300	-30	-1700	4.5%	79L09	SOT-89	高输入电压
FSS79L12M	225	-12.0	-100	4300	-30	-1700	4.5%	79L12	SOT-23	高输入电压
FS79L12	500	-12.0	-100	4300	-30	-1700	4.5%	79L12	SOT-89	高输入电压
FSS79L15M	225	-15.0	-100	4300	-30	-1700	4.5%	79L15	SOT-23	高输入电压
FS79L15	500	-15.0	-100	4300	-30	-1700	4.5%	79L15	SOT-89	高输入电压
FS1117-1.8	500	1.8	1000	10000	15	1300	5%	1117-1.8	SOT-89	大工作电流
FSL1117-1.8	500	1.8	1000	10000	15	1300	5%	1117-1.8	SOT-223	大工作电流
FSS1117-2.5	500	2.5	1000	10000	15	1300	5%	1117-2.5	SOT-23-3L	大工作电流
FS1117-2.5	500	2.5	1000	10000	15	1300	5%	1117-2.5	SOT-89	大工作电流
FSL1117-2.5	500	2.5	1000	10000	15	1300	5%	1117-2.5	SOT-223	大工作电流
FSS1117-3.3	500	3.3	1000	10000	15	1300	5%	1117-3.3	SOT-23-3L	大工作电流
FS1117-3.3	500	3.3	1000	10000	15	1300	5%	1117-3.3	SOT-89	大工作电流
FSL1117-3.3	500	3.3	1000	10000	15	1300	5%	1117-3.3	SOT-223	大工作电流
FSS1117-5.0	500	5.0	1000	10000	15	1300	5%	1117-5.0	SOT-23-3L	大工作电流
FS1117-5.0	500	5.0	1000	10000	15	1300	5%	1117-5.0	SOT-89	大工作电流
FSL1117-5.0	500	5.0	1000	10000	15	1300	5%	1117-5.0	SOT-223	大工作电流

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

可调三端稳压IC

型号	耗散功率	基准电压	输出电流	静态电流	最高耐压输入电压	工作温度	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_{ref}(V)	I_O(mA)	Iq(uA)	Vin(V)	Top(℃)	Acc	Marking	Package	Feature
FS431M-0.3	200	2.495	150	1	40	85	0.3%	431	SOT-23	
FS431M-0.5	200	2.495	150	1	40	85	0.5%	431	SOT-23	
FS431M-1	200	2.495	150	1	40	85	1%	431	SOT-23	
FS431RM-0.3	200	2.495	150	1	40	85	0.3%	431	SOT-23	反脚位
FS431RM-0.5	200	2.495	150	1	40	85	0.5%	431	SOT-23	反脚位
FS431RM-1	200	2.495	150	1	40	85	1%	431	SOT-23	反脚位
FS431S-0.5	200	2.495	150	1	40	70	0.5%	431.	SOT-23	
FS431S-1	200	2.495	150	1	40	70	1%	431.	SOT-23	
FS431S-2	200	2.495	150	1	40	70	2%	431.	SOT-23	
FS432M-0.5	200	1.25	100	0.5	20	70	0.5%	432	SOT-23	
FS432M-1	200	1.25	100	0.5	20	70	1%	432	SOT-23	
FS1117-adj	500	1.25	1000	1000	20	85	1%	1117-adj	SOT-89	

DC-DC电源管理IC

型号	耗散功率	电源电压	输出电流	静态电流	最高耐压输入电压	工作温度	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_{cc}(V)	I_O(mA)	Iq(uA)	Vin(V)	Top(℃)	Acc	Marking	Package	Feature
FS4054	500	5	500	1	7	100	1%	4054	SOT-23-5L	
FS4057	500	5	500	1	7	100	1%	4057	SOT-23-6L	
FS4056A	800	5	1000	1	7	100	1%	4056A	ESOP-8	
FS4056D	800	5	1000	1	7	100	1%	4056D	ESOP-8	
XT9502		9	100/500		18	85	1%/2%	9502	SOP-8	

富信
电子集团

安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

锂电池充放电保护IC

型号	耗散功率	过充电压	过放电压	静态电流	最高耐压输入电压	工作温度	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_{ocp}(V)	V_{odp}(V)	Iq(uA)	Vin(V)	Top(℃)	Acc	Marking	Package	Feature
DW01	500	4.3	2.4	2	10	85	1%	DW01	SOT-23-6L	
DW01A	500	4.3	2.4	2.4	10	85	1%	DW01A	SOT-23-6L	
DW02A	900	4.3	2.4	1.5	10	85	1%	DW02A	SOT-23-5L	DW01+8205
DW03A	900	4.3	2.4	1.5	10	85	1%	DW03A	SOT-23-5L	DW01+8205

运算放大器IC

型号	电源电压	高电压	低电压	静态电流	输入电压	工作温度	工作电流	印字	封装	特点
Type	V_{CC}(V)	Voh(V)	Vol(mV)	Iq(mA)	Vi(V)	Top(℃)	Io(mA)	Marking	Package	Feature
FS321	24	22	5	0.5	-0.3~24	0~70	50	A63A	SOT-23-5L	
FSV321	7.5	7	0.5	0.04	-0.5~7.5	-40~125	60	321	SOT-23-5L	

霍尔开关

型号	供电电压	工作磁场	释放磁场	静态电流	输出电压	工作温度	工作电流	印字	封装	特点
Type	V_{DD}(V)	Bops(mT)	Brps(mT)	Is(μA)	Vo(V)	Top(℃)	Io(mA)	Marking	Package	Feature
FS4915MR	2-5.5	1.5	1.1	1.9	0.13	-45~150	2	4915	SOT-23-3L	接近开关

升压IC

型号	耗散功率	输出电压	工作电流	静态电流	输入电压	工作温度	精度	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	V_o(V)	I_o(mA)	Iq(uA)	Vin(V)	Top(℃)	Acc	Marking	Package	Feature
FS2261	250	3.3-5	800	0.01	1.5	-40~80	1%/2%	多种	SOT-23-6L	升压可调
XT1861	250/500	1.5-6	500-1000	15	0.9	-40~85	2.5%	多种	多种	固定升压

电压检测（复位）IC

型号	耗散功率	输入电压	电压精度	静态电流	输出电压	工作温度	工作电流	印字	封装	特点
Type	P_D(mW)	Vin(V)	VDF	Is(μA)	Vout(V)	Top(℃)	Io(mA)	Marking	Package	Feature
FS809	150	6	2%	1	VSS-0.3~6	-30~85	50	多种	SOT23-3L/B	复位